

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6250906号  
(P6250906)

(45) 発行日 平成29年12月20日 (2017.12.20)

(24) 登録日 平成29年12月1日 (2017.12.1)

(51) Int.Cl.	F I
HO 1 L 21/336 (2006.01)	HO 1 L 29/78 6 2 6 C
HO 1 L 29/786 (2006.01)	HO 1 L 27/108 3 2 1
HO 1 L 21/8242 (2006.01)	HO 1 L 27/105 4 4 1
HO 1 L 27/108 (2006.01)	HO 1 L 27/10 4 6 1
HO 1 L 21/8239 (2006.01)	HO 1 L 27/108 6 7 1 C
請求項の数 3 (全 99 頁) 最終頁に続く	

(21) 出願番号	特願2016-93804 (P2016-93804)	(73) 特許権者	000153878
(22) 出願日	平成28年5月9日 (2016.5.9)		株式会社半導体エネルギー研究所
(62) 分割の表示	特願2012-97372 (P2012-97372)		神奈川県厚木市長谷398番地
原出願日	平成24年4月23日 (2012.4.23)	(72) 発明者	冢田 義紀
(65) 公開番号	特開2016-184748 (P2016-184748A)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
(43) 公開日	平成28年10月20日 (2016.10.20)		半導体エネルギー研究所内
審査請求日	平成28年6月3日 (2016.6.3)	(72) 発明者	磯部 敦生
(31) 優先権主張番号	特願2011-102569 (P2011-102569)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
(32) 優先日	平成23年4月29日 (2011.4.29)		半導体エネルギー研究所内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	塩野入 豊
(31) 優先権主張番号	特願2011-102571 (P2011-102571)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
(32) 優先日	平成23年4月29日 (2011.4.29)		半導体エネルギー研究所内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	熱海 知昭
			神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
			半導体エネルギー研究所内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

酸化物半導体層と、

前記酸化物半導体層の端部と接する絶縁層と、を有し、

前記絶縁層は、前記端部の側面と接する第1の酸化絶縁層と、前記端部と接しない第2の酸化絶縁層と、前記端部の下面と接する第3の酸化絶縁層とが積層された部分を有し、

前記絶縁層は、酸化アルミニウムを有し、前記酸化物半導体層の端部において、キャリアの移動経路の形成を抑制する機能を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

酸化物半導体層と、

前記酸化物半導体層の端部と接する絶縁層と、を有し、

前記絶縁層は、前記端部と接する第1の酸化絶縁層と、前記端部と接しない第2の酸化絶縁層とが積層された部分を有し、

前記絶縁層は、酸化アルミニウムを有し、前記酸化物半導体層の端部において、キャリアの移動経路の形成を抑制する機能を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】

酸化物半導体層と、

前記酸化物半導体層の端部と接する絶縁層と、

前記酸化物半導体層の端部と接する導電層と、を有し、

前記絶縁層は、前記端部の側面と接する第1の酸化絶縁層と、前記端部と接しない第2

10

20

の酸化絶縁層と、前記端部の下面と接する第3の酸化絶縁層とが積層された部分を有し、  
前記導電層は、前記酸化物半導体層の上面と接し、

前記絶縁層は、酸化アルミニウムを有し、前記酸化物半導体層の端部において、キャリアの移動経路の形成を抑制する機能を有することを特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、記憶装置を用いた半導体装置に関する。

【背景技術】

【0002】

中央演算処理装置（CPU：Central Processing Unit）などの半導体装置は、その用途によって多種多様な構成を有しているが、一般的に、データや命令を記憶するための主記憶装置の他に、高速でデータの書き込みと読み出しができるレジスタ、キャッシュなどの緩衝記憶装置が設けられている。緩衝記憶装置は、演算装置と主記憶装置の間に介在し、低速な主記憶装置へのアクセスを減らして演算処理を高速化させることを目的として、CPUに設けられている。

【0003】

通常は、レジスタとしてフリップフロップが、キャッシュとしてSRAM（Static Random Access Memory）が用いられる。下記特許文献1には、キャッシュとして、SRAMなどの揮発性メモリと、不揮発性メモリとを併用する構成について記載されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開平7-121444号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

ところで、中央演算処理装置などの半導体装置には、高速動作のみならず、消費電力の低さと、集積度の高さが要求される。しかし、例えば、トランジスタのサイズにもよるが、ハイレベルの電源電位が与えられているノードと、ローレベルの電源電位が与えられているノードの間において、直列に接続されたpチャネル型トランジスタ及びnチャネル型トランジスタを、バルクのシリコンを用いて作製した場合、室温下にて、ノード間の電圧が約3Vの状態にて、1pA程度のオフ電流が生じる。中央演算処理装置や、緩衝記憶装置の規模が大型化してトランジスタ数が多くなるほど、或いは、中央演算処理装置や、緩衝記憶装置が設けられたICチップの温度が上昇するほど、上記オフ電流の総量は大きくなるため、消費電力が高んでしまう。よって、中央演算処理装置を構成しているトランジスタは、オフ電流が小さくなるように、その構造に工夫を凝らす必要がある。しかし、高速動作とオフ電流の小ささを兼ね備えたトランジスタの実現は、開発に時間と費用を要する。

【0006】

半導体装置の消費電力を抑えるため、緩衝記憶装置への電源の供給を停止するという一つの方法が提案されている。緩衝記憶装置に用いられるフリップフロップやSRAMは揮発性であるため、上記方法では、揮発性の記憶装置の周辺に不揮発性の記憶装置を配置し、電源停止の前にデータを不揮発性の記憶装置へ一時的に移している。しかし、これらの不揮発性の記憶装置は、主に磁気素子や強誘電体が用いられているため、作製工程が複雑である。

【0007】

また、長時間の電源停止を行う際には、データをハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置に移してから電源停止を行うこともできるが、それらの記憶装置はデータを元に

10

20

30

40

50

戻すのに時間を必要とするため、短時間の電源停止には適さない。

【 0 0 0 8 】

上述の問題に鑑み、本発明は、高速動作を確保しつつ、消費電力を抑えることができる半導体装置の提供を目的の一つとする。或いは、本発明は、高速動作を確保しつつ、消費電力を抑えることができ、高集積化を実現できる半導体装置の提供を目的の一つとする。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 9 】

上記課題を解決するために、本発明の一態様では、結晶性を有するシリコン、またはゲルマニウムなどの半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタを用いた記憶素子と、当該記憶素子のデータを記憶する容量素子と、当該容量素子における電荷の供給、保持、放出を制御するスイッチング素子とを、半導体装置に設ける。さらに、本発明の一態様では、上記記憶素子を構成するトランジスタが形成されている層上に、上記スイッチング素子を構成するトランジスタが形成されており、なおかつ、記憶素子を構成するトランジスタが有するソース電極及びドレイン電極のいずれか一方が、スイッチング素子を構成するトランジスタが有するソース電極及びドレイン電極のいずれか一方として、機能しているものとする。

10

【 0 0 1 0 】

或いは、上記課題を解決するために、本発明の一態様では、結晶性を有するシリコン、またはゲルマニウムなどの半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタを用いた記憶素子と、当該記憶素子のデータを記憶する容量素子と、当該容量素子における電荷の供給、保持、放出を制御するスイッチング素子とを、半導体装置に設ける。さらに、本発明の一態様では、上記記憶素子を構成するトランジスタが形成されている層上に、上記スイッチング素子を構成するトランジスタが形成されているものとする。

20

【 0 0 1 1 】

上記スイッチング素子には、酸化物半導体をチャネル形成領域に含むトランジスタを用いる。酸化物半導体は、シリコンよりもバンドギャップが広く、真性キャリア密度がシリコンよりも低い。よって、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタは、通常のシリコンやゲルマニウムなどの半導体で形成されたトランジスタに比べて、オフ電流が極めて小さい。

【 0 0 1 2 】

また、本発明の一態様では、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタのオフ電流をさらに小さくさせるために、半導体装置に以下の第1の構成を採用する。具体的に、本発明の一態様に係る半導体装置において、上記スイッチング素子を構成するトランジスタは、絶縁膜上に形成される酸化物半導体膜と、酸化物半導体膜上のゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜を間に挟んで酸化物半導体膜と重なる位置に設けられたゲート電極と、酸化物半導体膜に接続された一对の導電膜と、を有する。酸化物半導体膜は、ゲート電極と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第1の領域と、第1の領域を挟む一对の第2の領域とを有している。また、上記絶縁膜は、加熱により一部の酸素が脱離する第1の酸化絶縁膜と、酸素の拡散を防ぎ、なおかつ当該第1の酸化絶縁膜の周囲に設けられた第2の酸化絶縁膜とを有する。そして、上記酸化物半導体膜は、第1の領域において上記第1の酸化絶縁膜に接し、第2の領域において第1の酸化絶縁膜及び第2の酸化絶縁膜に接する。

30

40

【 0 0 1 3 】

上記構成により、第1の酸化絶縁膜から放出された酸素は、第2の酸化絶縁膜への拡散が妨げられるため、第1の領域における酸化物半導体膜の端部に効率よく供給される。なお、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタは、酸化物半導体膜を所望の形状にエッチングするためのエッチング処理、酸化物半導体膜の端部の減圧雰囲気における暴露等により、酸化物半導体膜の端部において酸素の脱離による酸素欠損が形成されやすい。そして、酸素欠損はキャリアの移動経路となるため、酸化物半導体膜の端部に酸素欠損が形成されると、寄生チャネルが生じ、それによりトランジスタのオフ電流が大きくな

50

る。しかし、本発明の一態様では、上記構成により、第1の領域における酸化物半導体膜の端部に酸素欠損が形成されるのを防ぎ、オフ電流を小さくさせることができる。

【0014】

或いは、本発明の一態様では、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタのオフ電流をさらに小さくさせるために、半導体装置に上記第1の構成の代わりに、以下の第2の構成を採用しても良い。具体的に、本発明の一態様に係る半導体装置において、上記スイッチング素子を構成するトランジスタは、酸化物半導体膜と、酸化物半導体膜上のゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜を間に挟んで酸化物半導体膜と重なる位置に設けられたゲート電極と、酸化物半導体膜に接続された一对の導電膜と、を有する。さらに、上記半導体装置は、酸化物半導体膜の端部と接するように、酸化物半導体膜の周囲に設けられ、なおかつ加熱により一部の酸素が脱離する第1の酸化絶縁膜と、当該第1の酸化絶縁膜を間に挟んで酸化物半導体膜の周囲に設けられ、なおかつ酸素の拡散を防ぐ第2の酸化絶縁膜と、酸化物半導体膜の下部に設けられ、なおかつ加熱により一部の酸素が脱離する第3の酸化絶縁膜と、を有する。また、酸化物半導体膜は、ゲート電極と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第1の領域と、第1の領域を挟む一对の第2の領域とを有している。

10

【0015】

上記構成により、第1の酸化絶縁膜から放出された酸素は、第2の酸化絶縁膜への拡散が妨げられるため、酸化物半導体膜の端部に効率よく供給される。また、第3の酸化絶縁膜から放出された酸素は、酸化物半導体膜の下部に供給される。上述したように、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタは、酸化物半導体膜を所望の形状にエッチングするためのエッチング処理、酸化物半導体膜の端部の減圧雰囲気における暴露等により、酸化物半導体膜の端部において酸素の脱離による酸素欠損が形成されやすい。そして、酸素欠損はキャリアの移動経路となるため、酸化物半導体膜の端部に酸素欠損が形成されると、寄生チャネルが生じ、それによりトランジスタのオフ電流が大きくなる。しかし、本発明の一態様では、酸化物半導体膜の端部、特に、第1の領域における酸化物半導体膜の端部に酸素が効率よく供給されることにより、第1の領域における酸化物半導体膜の端部に酸素欠損が形成されるのを防ぎ、オフ電流を小さくさせることができる。

20

【0016】

なお、上記第1の構成或いは第2の構成を有する半導体装置において、上記酸化物半導体膜は、第2の領域が、ドーパントを含んでいても良い。或いは、上記酸化物半導体膜は、第2の領域が、ドーパントを含む一对の第3の領域と、上記ドーパントの濃度が第3の領域よりも高い一对の第4の領域とを有していても良い。具体的に、酸化物半導体膜は、第1の領域と、第1の領域を挟む一对の第2の領域とを有し、第2の領域は、第1の領域を挟む一对の第3の領域と、第1の領域及び一对の第3の領域を挟む一对の第4の領域とを有する。上記第3の領域は、電界緩和領域として機能する。

30

【0017】

酸化物半導体膜を活性層として用いたトランジスタのオフ電流が小さいことは、いろいろな実験により証明できる。例えば、チャネル幅が $1 \times 10^6 \mu\text{m}$ でチャネル長が $10 \mu\text{m}$ の素子であっても、ソース端子とドレイン端子間の電圧(ドレイン電圧)が1Vから10Vの範囲において、オフ電流が、半導体パラメータアナライザの測定限界以下、すなわち $1 \times 10^{-13} \text{A}$ 以下という特性を得ることができる。この場合、オフ電流をトランジスタのチャネル幅で除した数値に相当するオフ電流密度は、 $100 \text{ zA} / \mu\text{m}$ 以下であることが分かる。

40

【0018】

用いる酸化物半導体としては、少なくともインジウム(In)あるいは亜鉛(Zn)を含むことが好ましい。特にInとZnを含むことが好ましい。また、該酸化物半導体を用いたトランジスタの電気的特性のばらつきを減らすためのスタビライザーとして、それらに加えてガリウム(Ga)を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてスズ(Sn)を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてハフニウム(Hf)を有する

50

ことが好ましい。また、スタビライザーとしてアルミニウム (Al) を有することが好ましい。

【0019】

また、他のスタビライザーとして、ランタノイドである、ランタン (La)、セリウム (Ce)、プラセオジウム (Pr)、ネオジウム (Nd)、サマリウム (Sm)、ユウロピウム (Eu)、ガドリニウム (Gd)、テルビウム (Tb)、ジスプロシウム (Dy)、ホルミウム (Ho)、エルビウム (Er)、ツリウム (Tm)、イッテルビウム (Yb)、ルテチウム (Lu) のいずれか一種あるいは複数種を有してもよい。

【0020】

例えば、酸化物半導体として、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、二元系金属の酸化物である In-Zn 系酸化物、Sn-Zn 系酸化物、Al-Zn 系酸化物、Zn-Mg 系酸化物、Sn-Mg 系酸化物、In-Mg 系酸化物、In-Ga 系酸化物、三元系金属の酸化物である In-Ga-Zn 系酸化物 (IGZO とも表記する)、In-Al-Zn 系酸化物、In-Sn-Zn 系酸化物、Sn-Ga-Zn 系酸化物、Al-Ga-Zn 系酸化物、Sn-Al-Zn 系酸化物、In-Hf-Zn 系酸化物、In-La-Zn 系酸化物、In-Ce-Zn 系酸化物、In-Pr-Zn 系酸化物、In-Nd-Zn 系酸化物、In-Sm-Zn 系酸化物、In-Eu-Zn 系酸化物、In-Gd-Zn 系酸化物、In-Tb-Zn 系酸化物、In-Dy-Zn 系酸化物、In-Ho-Zn 系酸化物、In-Er-Zn 系酸化物、In-Tm-Zn 系酸化物、In-Yb-Zn 系酸化物、In-Lu-Zn 系酸化物、四元系金属の酸化物である In-Sn-Ga-Zn 系酸化物、In-Hf-Ga-Zn 系酸化物、In-Al-Ga-Zn 系酸化物、In-Sn-Al-Zn 系酸化物、In-Sn-Hf-Zn 系酸化物、In-Hf-Al-Zn 系酸化物を用いることができる。

【0021】

なお、ここで、例えば、In-Ga-Zn 系酸化物とは、In と Ga と Zn を主成分として有する酸化物という意味であり、In と Ga と Zn の比率は問わない。また、In と Ga と Zn 以外の金属元素が入っていてもよい。

【0022】

また、酸化物半導体として、 $\text{InM}(\text{ZnO})_m$  ( $m > 0$ 、且つ、 $m$  は整数でない) で表記される材料を用いてもよい。なお、 $M$  は、Ga、Fe、Mn 及び Co から選ばれた一の金属元素または複数の金属元素を示す。また、酸化物半導体として、 $\text{In}_3\text{SnO}_5(\text{ZnO})_n$  ( $n > 0$ 、且つ、 $n$  は整数) で表記される材料を用いてもよい。

【0023】

例えば、 $\text{In} : \text{Ga} : \text{Zn} = 1 : 1 : 1$  ( $= 1/3 : 1/3 : 1/3$ ) あるいは  $\text{In} : \text{Ga} : \text{Zn} = 2 : 2 : 1$  ( $= 2/5 : 2/5 : 1/5$ ) の原子数比の In-Ga-Zn 系酸化物やその組成の近傍の酸化物を用いることができる。あるいは、 $\text{In} : \text{Sn} : \text{Zn} = 1 : 1 : 1$  ( $= 1/3 : 1/3 : 1/3$ )、 $\text{In} : \text{Sn} : \text{Zn} = 2 : 1 : 3$  ( $= 1/3 : 1/6 : 1/2$ ) あるいは  $\text{In} : \text{Sn} : \text{Zn} = 2 : 1 : 5$  ( $= 1/4 : 1/8 : 5/8$ ) の原子数比の In-Sn-Zn 系酸化物やその組成の近傍の酸化物を用いるとよい。

【0024】

しかし、これらに限られず、必要とする電気的特性 (移動度、しきい値電圧、ばらつき等) に応じて適切な組成のものを用いればよい。また、必要とする電気的特性を得るために、キャリア密度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素の原子数比、原子間結合距離、密度等を適切なものとするのが好ましい。

【0025】

例えば、In-Sn-Zn 系酸化物では比較的容易に高い移動度を得られる。しかしながら、In-Ga-Zn 系酸化物でも、バルク内欠陥密度を低減することにより移動度を上げることができる。

【0026】

なお、例えば、In、Ga、Zn の原子数比が  $\text{In} : \text{Ga} : \text{Zn} = a : b : c$  ( $a + b +$

10

20

30

40

50

$c = 1$ )である酸化物の組成が、原子数比が  $I n : G a : Z n = A : B : C (A + B + C = 1)$  の酸化物の組成の近傍であるとは、 $a$ 、 $b$ 、 $c$  が、 $(a - A)^2 + (b - B)^2 + (c - C)^2 \leq r^2$  を満たすことを言い、 $r$  は、例えば、 $0.05$  とすればよい。他の酸化物でも同様である。

【0027】

酸化物半導体は単結晶でも、非単結晶でもよい。後者の場合、アモルファスでも、多結晶でもよい。また、アモルファス中に結晶性を有する部分を含む構造でも、非アモルファスでもよい。

【0028】

アモルファス状態の酸化物半導体は、比較的容易に平坦な表面を得ることができるため、これを用いてトランジスタを作製した際の界面散乱を低減でき、比較的容易に、比較的高い移動度を得ることができる。

10

【0029】

また、結晶性を有する酸化物半導体では、よりバルク内欠陥を低減することができ、表面の平坦性を高めればアモルファス状態の酸化物半導体以上の移動度を得ることができる。表面の平坦性を高めるためには、平坦な表面上に酸化物半導体を形成することが好ましく、具体的には、平均面粗さ ( $Ra$ ) が  $1\text{ nm}$  以下、好ましくは  $0.3\text{ nm}$  以下、より好ましくは  $0.1\text{ nm}$  以下の表面上に形成するとよい。

【0030】

なお、 $Ra$  は、JIS B 0601 で定義されている中心線平均粗さを面に対して適用できるように三次元に拡張したものであり、「基準面から指定面までの偏差の絶対値を平均した値」と表現でき、以下の数式 1 にて定義される。

20

【0031】

【数 1】

$$Ra = \frac{1}{S_0} \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} |f(x, y) - Z_0| dx dy \cdots (\text{式 1})$$

【0032】

なお、上記において、 $S_0$  は、測定面 (座標  $(x_1, y_1)$   $(x_1, y_2)$   $(x_2, y_1)$   $(x_2, y_2)$  で表される 4 点によって囲まれる長方形の領域) の面積を指し、 $Z_0$  は測定面の平均高さを指す。 $Ra$  は原子間力顕微鏡 (AFM: Atomic Force Microscope) にて評価可能である。

30

【発明の効果】

【0033】

本発明の一態様では、記憶素子を構成するトランジスタが、結晶性を有するシリコン、またはゲルマニウムなどの半導体をチャネル形成領域に有することで、半導体装置の高速動作を確保することができる。また、本発明の一態様では、オフ電流が極めて小さいトランジスタでスイッチング素子を構成することで、スイッチング素子を介して容量素子からリークする電荷の量を小さく抑えることができる。すなわち、本発明の一態様では、記憶素子とスイッチング素子に要求される特性に合わせて、最適な構造のトランジスタを容易に作り分けることができる。また、本発明の一態様では、記憶素子を構成するトランジスタと、スイッチング素子を構成するトランジスタとを積層することで、半導体装置の高集積化を実現することができる。

40

【0034】

よって、本発明の一態様では、上記構成により、高速動作を確保しつつ、消費電力を抑えることができる半導体装置を実現できる。或いは、本発明の一態様では、高速動作を確保しつつ、消費電力を抑えることができ、高集積化を実現できる半導体装置を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【0035】

50

【図 1】半導体装置の断面図。	
【図 2】トランジスタの断面図、及び上面図。	
【図 3】半導体装置の断面図。	
【図 4】トランジスタの断面図、及び上面図。	
【図 5】記憶回路の回路図。	
【図 6】記憶装置の構成を示す図。	
【図 7】半導体装置のブロック図。	
【図 8】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 9】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 10】半導体装置の作製方法を示す図。	10
【図 11】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 12】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 13】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 14】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 15】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 16】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 17】電子機器の図。	
【図 18】本発明の一態様に係る酸化物半導体の構造を説明する図。	
【図 19】本発明の一態様に係る酸化物半導体の構造を説明する図。	
【図 20】本発明の一態様に係る酸化物半導体の構造を説明する図。	20
【図 21】基板加熱温度と欠陥密度の関係を示す図。	
【図 22】計算によって得られた移動度のゲート電圧依存性を説明する図。	
【図 23】計算によって得られたドレイン電流と移動度のゲート電圧依存性を説明する図。	
。【図 24】計算によって得られたドレイン電流と移動度のゲート電圧依存性を説明する図。	
。【図 25】計算によって得られたドレイン電流と移動度のゲート電圧依存性を説明する図。	
。【図 26】計算に用いたトランジスタの断面構造を説明する図。	
【図 27】酸化物半導体膜を用いたトランジスタ特性のグラフ。	30
【図 28】試料 1 のトランジスタの B T 試験後の $V_{gs} - I_{ds}$ 特性を示す図。	
【図 29】試料 2 であるトランジスタの B T 試験後の $V_{gs} - I_{ds}$ 特性を示す図。	
【図 30】試料 A および試料 B の X R D スペクトルを示す図。	
【図 31】トランジスタのオフ電流と測定時基板温度との関係を示す図。	
【図 32】 $I_{ds}$ および移動度の $V_{gs}$ 依存性を示す図。	
【図 33】基板温度としきい値電圧の関係および基板温度と移動度の関係を示す図。	
【図 34】半導体装置の上面図及び断面図。	
【図 35】半導体装置の上面図及び断面図。	
【図 36】半導体装置の断面図。	
【図 37】トランジスタの断面図、及び上面図。	40
【図 38】半導体装置の断面図。	
【図 39】半導体装置の断面図。	
【図 40】トランジスタの断面図、及び上面図。	
【図 41】半導体装置の断面図。	
【図 42】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 43】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 44】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 45】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 46】半導体装置の作製方法を示す図。	
【図 47】半導体装置の作製方法を示す図。	50

【図４８】半導体装置の作製方法を示す図。

【図４９】半導体装置の作製方法を示す図。

【図５０】半導体装置の作製方法を示す図。

【図５１】半導体装置の作製方法を示す図。

【図５２】半導体装置の作製方法を示す図。

【発明を実施するための形態】

【００３６】

以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。したがって、本発明は、以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

10

【００３７】

なお、集積回路や、ＲＦタグ、半導体表示装置など、記憶装置を用いることができるありとあらゆる半導体装置が、本発明の範疇に含まれる。集積回路には、マイクロプロセッサ、画像処理回路、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、マイクロコントローラ等を含むＬＳＩ（Large Scale Integrated Circuit）、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）やＣＰＬＤ（Complex PLD）などのプログラマブル論理回路（PLD：Programmable Logic Device）が、その範疇に含まれる。また、半導体表示装置には、液晶表示装置、有機発光素子（OLED）に代表される発光素子を各画素に備えた発光装置、電子ペーパー、ＤＭＤ（Digital Micromirror Device）、ＰＤＰ（Plasma Display Panel）、ＦＥＤ（Field Emission Display）など、半導体膜を用いた回路素子を駆動回路に有している半導体表示装置が、その範疇に含まれる。

20

【００３８】

（実施の形態１）

本発明の一態様に係る半導体装置は、結晶性を有するシリコン、またはゲルマニウムなどの半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタを用いた記憶素子と、当該記憶素子のデータを記憶する容量素子と、当該容量素子における電荷の供給、保持、放出を制御するスイッチング素子とを有する。図１に、記憶素子が有するｎチャネル型トランジスタ１０２ｎ及びｐチャネル型トランジスタ１０２ｐと、容量素子１３６と、スイッチング素子が有するトランジスタ１２１との構成を断面図で一例として示す。

30

【００３９】

図１に示す半導体装置は、その表面に絶縁膜１０１が形成された基板１００上に、ｎチャネル型トランジスタ１０２ｎと、ｐチャネル型トランジスタ１０２ｐとを有する。

【００４０】

ｎチャネル型トランジスタ１０２ｎは、結晶性を有するシリコンを有する半導体膜１０３ｎと、半導体膜１０３ｎ上のゲート絶縁膜１０４ｎと、ゲート絶縁膜１０４ｎを間に挟んで半導体膜１０３ｎと重なる位置に設けられたゲート電極１０５ｎと、半導体膜１０３ｎに接続され、ソース電極またはドレイン電極として機能する導電膜１６１及び導電膜１６２とを有する。そして、半導体膜１０３ｎは、チャネル形成領域として機能する第１の領域１０８と、ソースまたはドレインとして機能する第２の領域１０９及び第２の領域１１０とを有する。第２の領域１０９及び第２の領域１１０は、第１の領域１０８を間に挟んでいる。なお、図１では、半導体膜１０３ｎが、第１の領域１０８と第２の領域１０９及び第２の領域１１０との間に、ＬＤＤ（Lightly Doped Drain）領域として機能する第３の領域１１１及び第３の領域１１２を有している場合を例示している。

40

【００４１】

また、ｐチャネル型トランジスタ１０２ｐは、結晶性を有するシリコンを有する半導体膜１０３ｐと、半導体膜１０３ｐ上のゲート絶縁膜１０４ｐと、ゲート絶縁膜１０４ｐを間

50

に挟んで半導体膜 103p と重なる位置に設けられたゲート電極 105p と、半導体膜 103p に接続され、ソース電極またはドレイン電極として機能する導電膜 162 及び導電膜 163 とを有する。そして、半導体膜 103p は、チャネル形成領域として機能する第 1 の領域 114 と、ソースまたはドレインとして機能する第 2 の領域 115 及び第 2 の領域 116 とを有する。第 2 の領域 115 及び第 2 の領域 116 は、第 1 の領域 114 を間に挟んでいる。なお、図 1 では、半導体膜 103p が、第 1 の領域 114 と第 2 の領域 115 及び第 2 の領域 116 との間に、LDD 領域として機能する第 3 の領域 117 及び第 3 の領域 118 を有している場合を例示している。

【0042】

なお、図 1 では、n チャンネル型トランジスタ 102n と、p チャンネル型トランジスタ 102p とが導電膜 162 を共有している場合を例示しているが、上記 2 つのトランジスタが互いに独立した導電膜を有していても良い。

【0043】

また、図 1 では、n チャンネル型トランジスタ 102n と、p チャンネル型トランジスタ 102p とが、薄膜の半導体膜を用いている場合を例示しているが、n チャンネル型トランジスタ 102n と、p チャンネル型トランジスタ 102p とが、バルクの半導体基板にチャネル形成領域を有するトランジスタであっても良い。

【0044】

また、図 1 に示す半導体装置では、n チャンネル型トランジスタ 102n が有する半導体膜 103n、ゲート絶縁膜 104n、及びゲート電極 105n を覆うように、なおかつ、p チャンネル型トランジスタ 102p が有する半導体膜 103p、ゲート絶縁膜 104p、及びゲート電極 105p を覆うように、絶縁膜 119 が設けられている。そして、絶縁膜 119 上には、第 1 の酸化絶縁膜 120a 及び第 2 の酸化絶縁膜 120b を有する絶縁膜 120 が設けられている。

【0045】

導電膜 161 は、絶縁膜 119 及び絶縁膜 120 に設けられた開口部において第 2 の領域 109 に接するように、絶縁膜 120 上に設けられている。導電膜 162 は、絶縁膜 119 及び絶縁膜 120 に設けられた開口部において第 2 の領域 110 及び第 2 の領域 115 に接するように、絶縁膜 120 上に設けられている。導電膜 163 は、絶縁膜 119 及び絶縁膜 120 に設けられた開口部において第 2 の領域 116 に接するように、絶縁膜 120 上に設けられている。

【0046】

第 1 の酸化絶縁膜 120a は、加熱により一部の酸素が脱離する酸化絶縁膜を用いて形成する。加熱により一部の酸素が脱離する酸化絶縁膜としては、化学量論的組成比を満たす酸素よりも多くの酸素を含む絶縁膜を用いることが好ましい。第 1 の酸化絶縁膜 120a として、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム等を用いることができる。

【0047】

第 2 の酸化絶縁膜 120b は、酸素の拡散を防ぐ酸化絶縁膜で形成する。第 2 の酸化絶縁膜 120b の一例としては、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム等がある。なお、酸化アルミニウムは、化学量論的組成比を満たす酸素を含む酸化アルミニウム、または化学量論的組成比を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化アルミニウム ( $AlO_x$ 、 $x$  は  $3/2$  以上) とすることが好ましい。また、酸化窒化アルミニウムは、化学量論的組成比を満たす酸素を含む酸化アルミニウムの一部の酸素が窒素で置換されている。

【0048】

なお、「加熱により一部の酸素が脱離する」とは、TDS (Thermal Desorption Spectroscopy: 昇温脱離ガス分光法) 分析にて、酸素原子に換算しての酸素の放出量が  $1.0 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$  以上、好ましくは  $3.0 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$  以上であることをいう。

【0049】

10

20

30

40

50

ここで、TDS分析にて、酸素原子に換算しての酸素の脱離量の測定方法について、以下に説明する。

【0050】

TDS分析したときの気体の脱離量は、スペクトルの積分値に比例する。このため、絶縁膜のスペクトルの積分値と、標準試料の基準値に対する比とにより、気体の放出量を計算することができる。標準試料の基準値とは、所定の原子を含む試料の、スペクトルの積分値に対する原子の密度の割合である。

【0051】

例えば、標準試料である所定の密度の水素を含むシリコンウェハのTDS分析結果、及び絶縁膜のTDS分析結果から、絶縁膜の酸素分子の脱離量( $N_{O_2}$ )は、数式2で求めることができる。質量数32のものとして $CH_3OH$ があるが、絶縁膜中に存在する可能性は低い。よって、TDS分析で得られる質量数32で検出されるスペクトルの全ては、酸素分子由来であると仮定する。また、酸素原子の同位体である質量数17の酸素原子及び質量数18の酸素原子を含む酸素分子についても、自然界における存在比率が極微量であるため、存在しないものと仮定する。

【0052】

$$N_{O_2} = N_{H_2} / S_{H_2} \times S_{O_2} \times \quad (\text{数式2})$$

【0053】

$N_{H_2}$ は、標準試料から脱離した水素分子を密度で換算した値である。 $S_{H_2}$ は、標準試料をTDS分析したときのスペクトルの積分値である。標準試料の基準値は、 $N_{H_2} / S_{H_2}$ とする。 $S_{O_2}$ は、絶縁膜をTDS分析したときのスペクトルの積分値である。は、TDS分析におけるスペクトル強度に影響する係数である。数式2の詳細に関しては、特開平6-275697公報を参照する。なお、上記絶縁膜の酸素の脱離量は、電子科学株式会社製の昇温脱離分析装置EMD-WA1000S/Wを用い、標準試料として $1 \times 10^{16} \text{ atoms/cm}^3$ の水素原子を含むシリコンウェハを用いて測定する。

【0054】

また、TDS分析において、一部の酸素は酸素原子として検出される。酸素分子と酸素原子の比率は、酸素分子のイオン化率から算出することができる。なお、上述のは酸素分子のイオン化率を含むため、酸素分子の放出量を評価することで、酸素原子の脱離量についても見積もることができる。

【0055】

なお、 $N_{O_2}$ は酸素分子の脱離量である。絶縁膜においては、酸素原子に換算したときの酸素の放出量は、酸素分子の脱離量の2倍となる。

【0056】

上記構成において、加熱により酸素放出される絶縁膜は、酸素が過剰な酸化シリコン( $SiO_x$  ( $x > 2$ ))であってもよい。酸素が過剰な酸化シリコン( $SiO_x$  ( $x > 2$ ))とは、シリコン原子数の2倍より多い酸素原子を単位体積当たりを含むものである。単位体積当たりのシリコン原子数及び酸素原子数は、ラザフォード後方散乱法により測定した値である。

【0057】

絶縁膜120上には、スイッチング素子が有するトランジスタ121が設けられている。具体的に、トランジスタ121は、絶縁膜120上に位置する酸化物半導体膜122と、酸化物半導体膜122上のゲート絶縁膜123と、ゲート絶縁膜123を間に挟んで酸化物半導体膜122と重なる位置に設けられたゲート電極124と、酸化物半導体膜122に接続され、ソース電極またはドレイン電極として機能する導電膜163及び導電膜164とを有する。酸化物半導体膜122は、ゲート電極124と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第1の領域127と、ソースまたはドレインとして機能し、第1の領域127を挟む第2の領域128及び第2の領域129とを有している。具体的に、導電膜163は、酸化物半導体膜122が有する第2の領域128に接続されている。また、導電膜164は、酸化物半導体膜122が有する第2の領域129に接続さ

10

20

30

40

50

れている。

【 0 0 5 8 】

シリコン半導体よりもバンドギャップが広く、真性キャリア密度がシリコンよりも低い半導体材料の一例として、酸化物半導体の他に、炭化珪素（SiC）、窒化ガリウム（GaN）などの化合物半導体などがある。酸化物半導体は、炭化珪素や窒化ガリウムと異なり、スパッタリング法や湿式法により作製可能であり、量産性に優れるといった利点がある。また、炭化シリコンまたは窒化ガリウムとは異なり、酸化物半導体は室温でも成膜が可能のため、ガラス基板上への成膜、或いはシリコンを用いた集積回路上への成膜が可能である。また、基板の大型化にも対応が可能である。よって、上述したワイドギャップ半導体の中でも、特に酸化物半導体は量産性が高いというメリットを有する。また、トランジスタの性能（例えば移動度）を向上させるために結晶性の酸化物半導体を得ようとする場合でも、200 から 800 の熱処理によって容易に結晶性の酸化物半導体を得ることができる。

10

【 0 0 5 9 】

次いで、図2を用いて、酸化物半導体膜122が有する第1の領域127、第2の領域128及び第2の領域129と、絶縁膜120が有する第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120bとの位置関係について説明する。

【 0 0 6 0 】

図2（A）は、絶縁膜120及びトランジスタ121の断面図であり、図2（B）は、絶縁膜120及びトランジスタ121の上面図である。図2（B）の破線A1 - A2における断面図が、図2（A）に相当する。また、図2（C）は、図2（B）の破線B1 - B2における、絶縁膜120及びトランジスタ121の断面図である。

20

【 0 0 6 1 】

トランジスタ121は、ゲート電極124の側部に、絶縁膜を有するサイドウォール130が設けられており、ゲート電極124の上部に、絶縁膜131が設けられている。そして、導電膜163及び導電膜164は、その一部がサイドウォール130に接している。導電膜163及び導電膜164は必ずしもサイドウォール130に接している必要は無いが、サイドウォール130に接するように導電膜163及び導電膜164を形成することで、導電膜163及び導電膜164の位置が多少ずれて形成されたとしても、導電膜163及び導電膜164と酸化物半導体膜122との接する面積が、変動するのを防ぐことができる。よって、導電膜163及び導電膜164の位置がずれることによる、トランジスタ121のオン電流の変動を防ぐことができる。

30

【 0 0 6 2 】

なお、ゲート電極124の上部に位置する絶縁膜131は必ずしも設ける必要は無いが、絶縁膜131を設けることで、導電膜163及び導電膜164の位置がずれて形成され、ゲート電極124の上部にかかっても、導電膜163及び導電膜164とゲート電極124が導通するのを防ぐことができる。

【 0 0 6 3 】

そして、絶縁膜120は、第1の酸化絶縁膜120aの周囲に第2の酸化絶縁膜120bが設けられている。そして、酸化物半導体膜122は、第1の領域127において上記第1の酸化絶縁膜120aに接し、第2の領域128及び第2の領域129において第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120bに接する。

40

【 0 0 6 4 】

上記構成により、加熱により第1の酸化絶縁膜120aから放出された酸素が、第2の酸化絶縁膜120bを通過するのを抑制することができるので、上記酸素が第1の領域127における酸化物半導体膜122の端部132に効率よく供給される。なお、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタ121は、酸化物半導体膜122を所望の形状にエッチングするためのエッチング処理、酸化物半導体膜122の端部の減圧雰囲気における暴露等により、酸化物半導体膜122の端部において酸素の脱離による酸素欠損が形成されやすい。そして、酸素欠損はキャリアの移動経路となるため、酸化物半導体膜1

50

22の端部に酸素欠損が形成されると、寄生チャネルが生じ、それによりトランジスタ121のオフ電流が大きくなる。しかし、本発明の一態様では、上記構成により、第1の領域127における酸化物半導体膜122の端部132に酸素欠損が形成されるのを防ぎ、オフ電流を小さくさせることができる。

【0065】

なお、特に断りが無い限り、本明細書でオフ電流とは、nチャネル型トランジスタにおいては、ドレインをソースとゲート電極よりも高い電位とした状態において、ソースの電位を基準としたときのゲート電極の電位が0以下であるときに、ソースとドレインの間に流れる電流のことを意味する。或いは、本明細書でオフ電流とは、pチャネル型トランジスタにおいては、ドレインをソースとゲート電極よりも低い電位とした状態において、ソースの電位を基準としたときのゲート電極の電位が0以上であるときに、ソースとドレインの間に流れる電流のことを意味する。

10

【0066】

また、図1に示すように、容量素子136は、絶縁膜120上の導電膜133と、導電膜133上の絶縁膜134と、絶縁膜134を間に挟んで導電膜133と重なる位置に設けられた導電膜135とを有する。絶縁膜134は、トランジスタ121上にも設けられている。また、導電膜133と導電膜164とは電氣的に接続されていても良いし、或いは、導電膜133と導電膜164とが一の連続した導電膜で構成されていても良い。

【0067】

なお、図1では、容量素子136をトランジスタ121と共に絶縁膜120の上に設けている場合を例示しているが、容量素子136は、nチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pと共に、絶縁膜120の下に設けられていても良い。

20

【0068】

また、トランジスタ121は、ゲート電極124を酸化物半導体膜122の片側において少なくとも有していれば良いが、酸化物半導体膜122を間に挟んで存在する一対のゲート電極を有していても良い。

【0069】

次いで、図1に示した構成とは異なる、本発明の一態様に係る半導体装置の構成について説明する。図3に、記憶素子が有するnチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pと、容量素子136と、スイッチング素子が有するトランジスタ121との構成を断面図で一例として示す。

30

【0070】

図3に示す半導体装置は、図1に示す半導体装置と同様に、その表面に絶縁膜101が形成された基板100上に、nチャネル型トランジスタ102nと、pチャネル型トランジスタ102pとを有する。nチャネル型トランジスタ102nと、pチャネル型トランジスタ102pの具体的な構成については、図1と同様である。

【0071】

そして、図3に示す半導体装置は、図1と同様に、nチャネル型トランジスタ102nが有する半導体膜103n、ゲート絶縁膜104n、及びゲート電極105nを覆うように、なおかつ、pチャネル型トランジスタ102pが有する半導体膜103p、ゲート絶縁膜104p、及びゲート電極105pを覆うように、絶縁膜119が設けられている。そして、絶縁膜119上には、第1の酸化絶縁膜140a、第2の酸化絶縁膜140b、及び第3の酸化絶縁膜140cを有する絶縁膜140が設けられている。絶縁膜140上には、スイッチング素子が有するトランジスタ121が設けられている。

40

【0072】

導電膜161は、絶縁膜119及び絶縁膜140に設けられた開口部において第2の領域109に接するように、絶縁膜140上に設けられている。導電膜162は、絶縁膜119及び絶縁膜140に設けられた開口部において第2の領域110及び第2の領域115に接するように、絶縁膜140上に設けられている。導電膜163は、絶縁膜119及び絶縁膜140に設けられた開口部において第2の領域115に接するように、絶縁膜14

50

0 上に設けられている。

【0073】

第1の酸化絶縁膜140a及び第3の酸化絶縁膜140cは、加熱により一部の酸素が脱離する酸化絶縁膜を用いて形成する。加熱により一部の酸素が脱離する酸化絶縁膜としては、化学量論的組成比を満たす酸素よりも多くの酸素を含む絶縁膜を用いることが好ましい。第1の酸化絶縁膜140aとして、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム等を用いることができる。

【0074】

第2の酸化絶縁膜140bは、酸素の拡散を防ぐ酸化絶縁膜で形成する。第2の酸化絶縁膜140bの一例としては、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム等がある。なお、酸化アルミニウムは、化学量論的組成比を満たす酸素を含む酸化アルミニウム、または化学量論的組成比を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化アルミニウム( $AlO_x$ 、 $x$ は $3/2$ 以上)とすることが好ましい。また、酸化窒化アルミニウムは、化学量論的組成比を満たす酸素を含む酸化アルミニウムの一部の酸素が窒素で置換されている。

【0075】

また、具体的に、トランジスタ121は、酸化物半導体膜142と、酸化物半導体膜142上のゲート絶縁膜143と、ゲート絶縁膜143を間に挟んで酸化物半導体膜142と重なる位置に設けられたゲート電極144と、酸化物半導体膜142に接続され、ソース電極またはドレイン電極として機能する導電膜163及び導電膜164とを有する。酸化物半導体膜142は、ゲート電極144と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第1の領域147と、ソースまたはドレインとして機能し、第1の領域147を挟む第2の領域148及び第2の領域149とを有している。

【0076】

次いで、図4を用いて、図3に示したトランジスタ121の具体的な断面構造について説明する。

【0077】

図4(A)は、絶縁膜140及びトランジスタ121の断面図であり、図4(B)は、絶縁膜140及びトランジスタ121の上面図である。図4(B)の破線A1-A2における断面図が、図4(A)に相当する。また、図4(C)は、図4(B)の破線B1-B2における、絶縁膜140及びトランジスタ121の断面図である。

【0078】

トランジスタ121は、ゲート電極144の側部に、絶縁膜を有するサイドウォール150が設けられており、ゲート電極144の上部に、絶縁膜151が設けられている。そして、導電膜163及び導電膜164は、その一部がサイドウォール150に接している。導電膜163及び導電膜164は必ずしもサイドウォール150に接している必要は無いが、サイドウォール150に接するように導電膜163及び導電膜164を形成することで、導電膜163及び導電膜164の位置が多少ずれて形成されたとしても、導電膜163及び導電膜164と酸化物半導体膜142との接する面積が、変動するのを防ぐことができる。よって、導電膜163及び導電膜164の位置がずれることによる、トランジスタ121のオン電流の変動を防ぐことができる。

【0079】

なお、ゲート電極144の上部に位置する絶縁膜151は必ずしも設ける必要は無いが、絶縁膜151を設けることで、導電膜163及び導電膜164の位置がずれて形成され、ゲート電極144の上部にかかっても、導電膜163及び導電膜164とゲート電極144が導通するのを防ぐことができる。

【0080】

絶縁膜140では、下層に位置する第3の酸化絶縁膜140c上に、第1の酸化絶縁膜140aと、第2の酸化絶縁膜140bとが順に積層するように設けられている。そして、第1の酸化絶縁膜140a及び第2の酸化絶縁膜140bには開口部141が設けられており、上記開口部141には、トランジスタ121が有する酸化物半導体膜142が設け

られている。そして、第１の酸化絶縁膜１４０ aは、酸化物半導体膜１４２の端部に接するように、酸化物半導体膜１４２の周囲に設けられている。また、第２の酸化絶縁膜１４０ bは、第１の酸化絶縁膜１４０ aを間に挟んで酸化物半導体膜１４２の周囲に設けられている。第３の酸化絶縁膜１４０ cは、酸化物半導体膜１４２の下部に設けられている。

#### 【００８１】

上記構成により、加熱により第１の酸化絶縁膜１４０ aから放出された酸素が、第２の酸化絶縁膜１４０ bを通過するのを抑制することができるので、上記酸素が第１の領域１４７における酸化物半導体膜１４２の端部１５２に効率よく供給される。また、第３の酸化絶縁膜１４０ cから放出された酸素は、酸化物半導体膜１４２の下部に供給される。なお、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタ１２１は、酸化物半導体膜１４２を所望の形状にエッチングするためのエッチング処理、酸化物半導体膜１４２の端部の減圧雰囲気における暴露等により、酸化物半導体膜１４２の端部において酸素の脱離による酸素欠損が形成されやすい。そして、酸素欠損はキャリアの移動経路となるため、酸化物半導体膜１４２の端部に酸素欠損が形成されると、寄生チャネルが生じ、それによりトランジスタ１２１のオフ電流が大きくなる。しかし、本発明の一態様では、上記構成により、第１の領域１４７における酸化物半導体膜１４２の端部１５２に酸素欠損が形成されるのを防ぎ、オフ電流を小さくさせることができる。

#### 【００８２】

また、図３に示すように、容量素子１３６は、絶縁膜１４０上の導電膜１５３と、導電膜１５３上の絶縁膜１５４と、絶縁膜１５４を間に挟んで導電膜１５３と重なる位置に設けられた導電膜１５５とを有する。絶縁膜１５４は、トランジスタ１２１上にも設けられている。また、導電膜１５３と導電膜１６４とは電氣的に接続されていても良いし、或いは、導電膜１５３と導電膜１６４とが一の連続した導電膜で構成されていても良い。

#### 【００８３】

なお、図３では、容量素子１３６をトランジスタ１２１と共に絶縁膜１４０の上に設けている場合を例示しているが、容量素子１３６は、 $n$ チャネル型トランジスタ１０２ n及び $p$ チャネル型トランジスタ１０２ pと共に、絶縁膜１４０の下に設けられていても良い。

#### 【００８４】

また、トランジスタ１２１は、ゲート電極１４４を酸化物半導体膜１４２の片側において少なくとも有していれば良いが、酸化物半導体膜１４２を間に挟んで存在する一対のゲート電極を有していても良い。

#### 【００８５】

本発明の一態様では、記憶素子を構成する $n$ チャネル型トランジスタ１０２ n及び $p$ チャネル型トランジスタ１０２ pが、結晶性を有するシリコン、またはゲルマニウムなどの半導体をチャネル形成領域に有することで、半導体装置の高速動作を確保することができる。また、本発明の一態様では、オフ電流が極めて小さいトランジスタ１２１でスイッチング素子を構成することで、スイッチング素子を介して容量素子１３６からリークする電荷の量を小さく抑えることができる。すなわち、本発明の一態様では、記憶素子とスイッチング素子に要求される特性に合わせて、最適な構造のトランジスタを容易に作り分けることができる。また、本発明の一態様では、記憶素子を構成する $n$ チャネル型トランジスタ１０２ n及び $p$ チャネル型トランジスタ１０２ pと、スイッチング素子を構成するトランジスタ１２１とを積層することで、半導体装置の高集積化を実現することができる。

#### 【００８６】

よって、本発明の一態様では、上記構成により、高速動作を確保しつつ、消費電力を抑えることができる半導体装置を実現できる。或いは、本発明の一態様では、高速動作を確保しつつ、消費電力を抑えることができ、高集積化を実現できる半導体装置を実現できる。

#### 【００８７】

また、図３６に、記憶素子が有する $n$ チャネル型トランジスタ１０２ n及び $p$ チャネル型トランジスタ１０２ pと、容量素子１３６と、スイッチング素子が有するトランジスタ１２１との構成を断面図で一例として示す。

## 【0088】

図36に示す半導体装置は、その表面に絶縁膜101が形成された基板100上に、nチャネル型トランジスタ102nと、pチャネル型トランジスタ102pとを有する。

## 【0089】

nチャネル型トランジスタ102nは、結晶性を有するシリコンを有する半導体膜103nと、半導体膜103n上のゲート絶縁膜104nと、ゲート絶縁膜104nを間に挟んで半導体膜103nと重なる位置に設けられたゲート電極105nと、半導体膜103nに接続された導電膜106及び導電膜107とを有する。そして、半導体膜103nは、チャネル形成領域として機能する第1の領域108と、ソースまたはドレインとして機能する第2の領域109及び第2の領域110とを有する。第2の領域109及び第2の領域110は、第1の領域108を間に挟んでいる。なお、図36では、半導体膜103nが、第1の領域108と第2の領域109及び第2の領域110との間に、LDD(Lightly Doped Drain)領域として機能する第3の領域111及び第3の領域112を有している場合を例示している。

10

## 【0090】

また、pチャネル型トランジスタ102pは、結晶性を有するシリコンを有する半導体膜103pと、半導体膜103p上のゲート絶縁膜104pと、ゲート絶縁膜104pを間に挟んで半導体膜103pと重なる位置に設けられたゲート電極105pと、半導体膜103pに接続された導電膜107及び導電膜113とを有する。そして、半導体膜103pは、チャネル形成領域として機能する第1の領域114と、ソースまたはドレインとして機能する第2の領域115及び第2の領域116とを有する。第2の領域115及び第2の領域116は、第1の領域114を間に挟んでいる。なお、図36では、半導体膜103pが、第1の領域114と第2の領域115及び第2の領域116との間に、LDD領域として機能する第3の領域117及び第3の領域118を有している場合を例示している。

20

## 【0091】

なお、図36では、nチャネル型トランジスタ102nと、pチャネル型トランジスタ102pとが導電膜107を共有している場合を例示しているが、上記2つのトランジスタが互いに独立した導電膜を有していても良い。

## 【0092】

また、図36では、nチャネル型トランジスタ102nと、pチャネル型トランジスタ102pとが、薄膜の半導体膜を用いている場合を例示しているが、nチャネル型トランジスタ102nと、pチャネル型トランジスタ102pとが、バルクの半導体基板にチャネル形成領域を有するトランジスタであっても良い。

30

## 【0093】

また、図36に示す半導体装置では、導電膜106、導電膜107、及び導電膜113上に絶縁膜119が設けられている。そして、絶縁膜119上には、第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120bを有する絶縁膜120が設けられている。

## 【0094】

第1の酸化絶縁膜120aは、加熱により一部の酸素が脱離する酸化絶縁膜を用いて形成する。加熱により一部の酸素が脱離する酸化絶縁膜としては、化学量論的組成比を満たす酸素よりも多くの酸素を含む絶縁膜を用いることが好ましい。第1の酸化絶縁膜120aとして、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム等を用いることができる。

40

## 【0095】

第2の酸化絶縁膜120bは、酸素の拡散を防ぐ酸化絶縁膜で形成する。第2の酸化絶縁膜120bの一例としては、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム等がある。なお、酸化アルミニウムは、化学量論的組成比を満たす酸素を含む酸化アルミニウム、または化学量論的組成比を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化アルミニウム( $AlO_x$ 、 $x$ は $3/2$ 以上)とすることが好ましい。また、酸化窒化アルミニウムは、化学量論的組成比

50

を満たす酸素を含む酸化アルミニウムの一部の酸素が窒素で置換されている。

【0096】

絶縁膜120上には、スイッチング素子が有するトランジスタ121が設けられている。具体的に、トランジスタ121は、絶縁膜120上に位置する酸化物半導体膜122と、酸化物半導体膜122上のゲート絶縁膜123と、ゲート絶縁膜123を間に挟んで酸化物半導体膜122と重なる位置に設けられたゲート電極124と、酸化物半導体膜122に接続された導電膜125及び導電膜126とを有する。酸化物半導体膜122は、ゲート電極124と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第1の領域127と、ソースまたはドレインとして機能し、第1の領域127を挟む第2の領域128及び第2の領域129とを有している。

10

【0097】

次いで、図37を用いて、酸化物半導体膜122が有する第1の領域127、第2の領域128及び第2の領域129と、絶縁膜120が有する第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120bとの位置関係について説明する。

【0098】

図37(A)は、絶縁膜120及びトランジスタ121の断面図であり、図37(B)は、絶縁膜120及びトランジスタ121の上面図である。図37(B)の破線A1-A2における断面図が、図37(A)に相当する。また、図37(C)は、図37(B)の破線B1-B2における、絶縁膜120及びトランジスタ121の断面図である。

【0099】

トランジスタ121は、ゲート電極124の側部に、絶縁膜を有するサイドウォール130が設けられており、ゲート電極124の上部に、絶縁膜131が設けられている。そして、導電膜125及び導電膜126は、その一部がサイドウォール130に接している。導電膜125及び導電膜126は必ずしもサイドウォール130に接している必要は無いが、サイドウォール130に接するように導電膜125及び導電膜126を形成することで、導電膜125及び導電膜126の位置が多少ずれて形成されたとしても、導電膜125及び導電膜126と酸化物半導体膜122との接する面積が、変動するのを防ぐことができる。よって、導電膜125及び導電膜126の位置がずれることによる、トランジスタ121のオン電流の変動を防ぐことができる。

20

【0100】

なお、ゲート電極124の上部に位置する絶縁膜131は必ずしも設ける必要は無いが、絶縁膜131を設けることで、導電膜125及び導電膜126の位置がずれて形成され、ゲート電極124の上部にかかっても、導電膜125及び導電膜126とゲート電極124が導通するのを防ぐことができる。

30

【0101】

そして、絶縁膜120は、第1の酸化絶縁膜120aの周囲に第2の酸化絶縁膜120bが設けられている。そして、酸化物半導体膜122は、第1の領域127において上記第1の酸化絶縁膜120aに接し、第2の領域128及び第2の領域129において第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120bに接する。

【0102】

上記構成により、加熱により第1の酸化絶縁膜120aから放出された酸素が、第2の酸化絶縁膜120bを通過するのを抑制することができるので、上記酸素が第1の領域127における酸化物半導体膜122の端部132に効率よく供給される。なお、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタ121は、酸化物半導体膜122を所望の形状にエッチングするためのエッチング処理、酸化物半導体膜122の端部の減圧雰囲気における暴露等により、酸化物半導体膜122の端部において酸素の脱離による酸素欠損が形成されやすい。そして、酸素欠損はキャリアの移動経路となるため、酸化物半導体膜122の端部に酸素欠損が形成されると、寄生チャネルが生じ、それによりトランジスタ121のオフ電流が大きくなる。しかし、本発明の一態様では、上記構成により、第1の領域127における酸化物半導体膜122の端部132に酸素欠損が形成されるのを防ぎ、

40

50

オフ電流を小さくすることができる。

【0103】

また、図36に示すように、容量素子136は、絶縁膜120上の導電膜133と、導電膜133上の絶縁膜134と、絶縁膜134を間に挟んで導電膜133と重なる位置に設けられた導電膜135とを有する。絶縁膜134は、トランジスタ121上にも設けられている。また、導電膜133と導電膜125とは電氣的に接続されていても良いし、或いは、導電膜133と導電膜125とが一の連続した導電膜で構成されていても良い。

【0104】

なお、図36では、容量素子136をトランジスタ121と共に絶縁膜120の上に設けている場合を例示しているが、容量素子136は、nチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pと共に、絶縁膜120の下に設けられていても良い。

10

【0105】

また、図36では、絶縁膜120と、nチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pとの間に、絶縁膜119を設けている場合を例示しているが、絶縁膜119は必ずしも設ける必要は無い。絶縁膜119を設けない場合、導電膜106、導電膜107、及び導電膜113に接するように、絶縁膜120が設けられる。

【0106】

また、トランジスタ121は、ゲート電極124を酸化物半導体膜122の片側において少なくとも有していれば良いが、酸化物半導体膜122を間に挟んで存在する一対のゲート電極を有していても良い。

20

【0107】

図38に、図36に示した半導体装置において、トランジスタ121が、ゲート電極124に加えて、絶縁膜119と絶縁膜120の間にバックゲート電極137を有する場合を例示する。バックゲート電極137は、絶縁膜120を間に挟んで、酸化物半導体膜122と重なる位置に設けられている。

【0108】

バックゲート電極137は、電氣的に絶縁しているフローティングの状態であっても良いし、電位が他から与えられている状態であっても良い。後者の場合、バックゲート電極137には、ゲート電極124と同じ高さの電位が与えられていても良いし、バックゲート電極137にのみ接地電位などの固定の電位が与えられていても良い。バックゲート電極137に与える電位の高さを制御することで、トランジスタ121の閾値電圧を制御することができる。図38では、絶縁膜119に形成された開口部を介して、バックゲート電極137が、導電膜106、導電膜107及び導電膜113と同じ層に形成された導電膜138に接続されている場合を例示している。

30

【0109】

次いで、図36に示した構成とは異なる、本発明の一態様に係る半導体装置の構成について説明する。図39に、記憶素子が有するnチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pと、容量素子136と、スイッチング素子が有するトランジスタ121との構成を断面図で一例として示す。

40

【0110】

図39に示す半導体装置は、図36に示す半導体装置と同様に、その表面に絶縁膜101が形成された基板100上に、nチャネル型トランジスタ102nと、pチャネル型トランジスタ102pとを有する。nチャネル型トランジスタ102nと、pチャネル型トランジスタ102pの具体的な構成については、図36と同様である。

【0111】

そして、図39に示す半導体装置は、図36と同様に、導電膜106、導電膜107、及び導電膜113上に絶縁膜119が設けられている。そして、絶縁膜119上には、第1の酸化絶縁膜140a、第2の酸化絶縁膜140b、及び第3の酸化絶縁膜140cを有する絶縁膜140が設けられている。絶縁膜140上には、スイッチング素子が有するト

50

ランジスタ 1 2 1 が設けられている。

【 0 1 1 2 】

第 1 の酸化絶縁膜 1 4 0 a 及び第 3 の酸化絶縁膜 1 4 0 c は、加熱により一部の酸素が脱離する酸化絶縁膜を用いて形成する。加熱により一部の酸素が脱離する酸化絶縁膜としては、化学量論的組成比を満たす酸素よりも多くの酸素を含む絶縁膜を用いることが好ましい。第 1 の酸化絶縁膜 1 4 0 a として、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム等を用いることができる。

【 0 1 1 3 】

第 2 の酸化絶縁膜 1 4 0 b は、酸素の拡散を防ぐ酸化絶縁膜で形成する。第 2 の酸化絶縁膜 1 4 0 b の一例としては、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム等がある。なお、酸化アルミニウムは、化学量論的組成比を満たす酸素を含む酸化アルミニウム、または化学量論的組成比を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化アルミニウム ( $AlO_x$ 、 $x$  は  $3/2$  以上) とすることが好ましい。また、酸化窒化アルミニウムは、化学量論的組成比を満たす酸素を含む酸化アルミニウムの一部の酸素が窒素で置換されている。

【 0 1 1 4 】

また、具体的に、トランジスタ 1 2 1 は、酸化物半導体膜 1 4 2 と、酸化物半導体膜 1 4 2 上のゲート絶縁膜 1 4 3 と、ゲート絶縁膜 1 4 3 を間に挟んで酸化物半導体膜 1 4 2 と重なる位置に設けられたゲート電極 1 4 4 と、酸化物半導体膜 1 4 2 に接続された導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 とを有する。酸化物半導体膜 1 4 2 は、ゲート電極 1 4 4 と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第 1 の領域 1 4 7 と、ソースまたはドレインとして機能し、第 1 の領域 1 4 7 を挟む第 2 の領域 1 4 8 及び第 2 の領域 1 4 9 とを有している。

【 0 1 1 5 】

次いで、図 4 0 を用いて、図 3 9 に示したトランジスタ 1 2 1 の具体的な断面構造について説明する。

【 0 1 1 6 】

図 4 0 ( A ) は、絶縁膜 1 4 0 及びトランジスタ 1 2 1 の断面図であり、図 4 0 ( B ) は、絶縁膜 1 4 0 及びトランジスタ 1 2 1 の上面図である。図 4 0 ( B ) の破線 A 1 - A 2 における断面図が、図 4 0 ( A ) に相当する。また、図 4 0 ( C ) は、図 4 0 ( B ) の破線 B 1 - B 2 における、絶縁膜 1 4 0 及びトランジスタ 1 2 1 の断面図である。

【 0 1 1 7 】

トランジスタ 1 2 1 は、ゲート電極 1 4 4 の側部に、絶縁膜を有するサイドウォール 1 5 0 が設けられており、ゲート電極 1 4 4 の上部に、絶縁膜 1 5 1 が設けられている。そして、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 は、その一部がサイドウォール 1 5 0 に接している。導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 は必ずしもサイドウォール 1 5 0 に接している必要は無いが、サイドウォール 1 5 0 に接するように導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 を形成することで、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 の位置が多少ずれて形成されたとしても、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 と酸化物半導体膜 1 4 2 との接する面積が、変動するのを防ぐことができる。よって、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 の位置がずれることによる、トランジスタ 1 2 1 のオン電流の変動を防ぐことができる。

【 0 1 1 8 】

なお、ゲート電極 1 4 4 の上部に位置する絶縁膜 1 5 1 は必ずしも設ける必要は無いが、絶縁膜 1 5 1 を設けることで、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 の位置がずれて形成され、ゲート電極 1 4 4 の上部にかかっても、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 とゲート電極 1 4 4 が導通するのを防ぐことができる。

【 0 1 1 9 】

絶縁膜 1 4 0 では、下層に位置する第 3 の酸化絶縁膜 1 4 0 c 上に、第 1 の酸化絶縁膜 1 4 0 a と、第 2 の酸化絶縁膜 1 4 0 b とが順に積層するように設けられている。そして、第 1 の酸化絶縁膜 1 4 0 a 及び第 2 の酸化絶縁膜 1 4 0 b には開口部 1 4 1 が設けられており、上記開口部 1 4 1 には、トランジスタ 1 2 1 が有する酸化物半導体膜 1 4 2 が設け

られている。そして、第1の酸化絶縁膜140aは、酸化物半導体膜142の端部に接するように、酸化物半導体膜142の周囲に設けられている。また、第2の酸化絶縁膜140bは、第1の酸化絶縁膜140aを間に挟んで酸化物半導体膜142の周囲に設けられている。第3の酸化絶縁膜140cは、酸化物半導体膜142の下部に設けられている。

#### 【0120】

上記構成により、加熱により第1の酸化絶縁膜140aから放出された酸素が、第2の酸化絶縁膜140bを通過するのを抑制することができるので、上記酸素が第1の領域147における酸化物半導体膜142の端部152に効率よく供給される。また、第3の酸化絶縁膜140cから放出された酸素は、酸化物半導体膜142の下部に供給される。なお、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタ121は、酸化物半導体膜142を所望の形状にエッチングするためのエッチング処理、酸化物半導体膜142の端部の減圧雰囲気における暴露等により、酸化物半導体膜142の端部において酸素の脱離による酸素欠損が形成されやすい。そして、酸素欠損はキャリアの移動経路となるため、酸化物半導体膜142の端部に酸素欠損が形成されると、寄生チャネルが生じ、それによりトランジスタ121のオフ電流が大きくなる。しかし、本発明の一態様では、上記構成により、第1の領域147における酸化物半導体膜142の端部152に酸素欠損が形成されるのを防ぎ、オフ電流を小さくすることができる。

#### 【0121】

また、図39に示すように、容量素子136は、絶縁膜140上の導電膜153と、導電膜153上の絶縁膜154と、絶縁膜154を間に挟んで導電膜153と重なる位置に設けられた導電膜155とを有する。絶縁膜154は、トランジスタ121上にも設けられている。また、導電膜153と導電膜145とは電氣的に接続されていても良いし、或いは、導電膜153と導電膜145とが一の連続した導電膜で構成されていても良い。

#### 【0122】

なお、図39では、容量素子136をトランジスタ121と共に絶縁膜140の上に設けている場合を例示しているが、容量素子136は、nチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pと共に、絶縁膜140の下に設けられていても良い。

#### 【0123】

また、図39では、絶縁膜140と、nチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pとの間に、絶縁膜119を設けている場合を例示しているが、絶縁膜119は必ずしも設ける必要は無い。絶縁膜119を設けない場合、導電膜106、導電膜107、及び導電膜113に接するように、絶縁膜140が設けられる。

#### 【0124】

また、トランジスタ121は、ゲート電極144を酸化物半導体膜142の片側において少なくとも有していれば良いが、酸化物半導体膜142を間に挟んで存在する一対のゲート電極を有していても良い。

#### 【0125】

図41に、図39に示した半導体装置において、トランジスタ121が、ゲート電極144に加えて、絶縁膜119と絶縁膜140の間にバックゲート電極157を有する場合を例示する。バックゲート電極157は、絶縁膜140を間に挟んで、酸化物半導体膜142と重なる位置に設けられている。

#### 【0126】

バックゲート電極157は、電氣的に絶縁しているフローティングの状態であっても良いし、電位が他から与えられている状態であっても良い。後者の場合、バックゲート電極157には、ゲート電極144と同じ高さの電位が与えられていても良いし、バックゲート電極157にのみ接地電位などの固定の電位が与えられていても良い。バックゲート電極157に与える電位の高さを制御することで、トランジスタ121の閾値電圧を制御することができる。図41では、絶縁膜119に形成された開口部を介して、バックゲート電極157が、導電膜106、導電膜107及び導電膜113と同じ層に形成された導電膜

１５８に接続されている場合を例示している。

【０１２７】

本発明の一態様では、記憶素子を構成するｎチャネル型トランジスタ１０２ｎ及びｐチャネル型トランジスタ１０２ｐが、結晶性を有するシリコン、またはゲルマニウムなどの半導体をチャネル形成領域に有することで、半導体装置の高速動作を確保することができる。また、本発明の一態様では、オフ電流が極めて小さいトランジスタ１２１でスイッチング素子を構成することで、スイッチング素子を介して容量素子１３６からリークする電荷の量を小さく抑えることができる。すなわち、本発明の一態様では、記憶素子とスイッチング素子に要求される特性に合わせて、最適な構造のトランジスタを容易に作り分けることができる。また、本発明の一態様では、記憶素子を構成するｎチャネル型トランジスタ１０２ｎ及びｐチャネル型トランジスタ１０２ｐと、スイッチング素子を構成するトランジスタ１２１とを積層することで、半導体装置の高集積化を実現することができる。

10

【０１２８】

よって、本発明の一態様では、上記構成により、高速動作を確保しつつ、消費電力を抑えることができる半導体装置を実現できる。或いは、本発明の一態様では、高速動作を確保しつつ、消費電力を抑えることができ、高集積化を実現できる半導体装置を実現できる。

【０１２９】

次いで、本発明の一態様に係る半導体装置の、具体的な回路構成の一例について説明する。本発明の一態様に係る半導体装置は、１ビットのデータを記憶することができる記憶回路を、単数または複数、記憶装置に有する。図５に、上記記憶装置が有する記憶回路の、回路図の一例を示す。図５に示す記憶回路２００は、記憶素子２１１と、容量素子２０５と、スイッチング素子２０６とを有する。記憶素子２１１は、入力された信号の位相を反転させて出力する第１の位相反転素子２０１及び第２の位相反転素子２０２と、トランジスタ２０３と、トランジスタ２０４とを有する。

20

【０１３０】

記憶回路２００に入力されたデータを含む信号ＩＮは、トランジスタ２０３を介して第１の位相反転素子２０１の入力端子に与えられる。第１の位相反転素子２０１の出力端子は、第２の位相反転素子２０２の入力端子に接続されている。第２の位相反転素子２０２の出力端子は、トランジスタ２０４を介して、第１の位相反転素子２０１の入力端子に接続されている。第１の位相反転素子２０１の出力端子または第２の位相反転素子２０２の入力端子の電位が、信号ＯＵＴとして後段の記憶回路、或いは他の回路に出力される。

30

【０１３１】

なお、図５では、第１の位相反転素子２０１及び第２の位相反転素子２０２としてインバータを用いる例を示しているが、第１の位相反転素子２０１または第２の位相反転素子２０２として、インバータの他に、クロックドインバータを用いることもできる。

【０１３２】

容量素子２０５は、記憶回路２００に入力された信号ＩＮのデータを必要に応じて記憶できるように、トランジスタ２０３及びスイッチング素子２０６を介して、記憶回路２００の入力端子、すなわち信号ＩＮの電位が与えられるノードに接続されている。具体的に、容量素子２０５は、一对の電極間に誘電体を有するコンデンサであり、その一方の電極は、スイッチング素子２０６を介して第１の位相反転素子２０１の入力端子に接続され、他方の電極は、ローレベルの電源電位ＶＳＳ、グラウンドなどの固定電位が与えられているノードに接続されている。

40

【０１３３】

また、スイッチング素子２０６は、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタを用いる。酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタは、通常のシリコンやゲルマニウムなどの半導体で形成されたトランジスタに比べて、オフ電流が極めて小さい。さらに、本発明の一態様では、図２または図４に示したような、オフ電流をより小さくさせることができる構成のトランジスタ１２１をスイッチング素子２０６として用いる。容量素子２０５におけるデータの保持期間の長さは、容量素子２０５に蓄積されている

50

電荷が、スイッチング素子 206 を介してリークする量に依存する。よって、上述したような、オフ電流の著しく小さいスイッチング素子 206 により、容量素子 205 に蓄積された電荷を保持することで、容量素子 205 からの電荷のリークを防ぐことができ、データの保持期間を長く確保することができる。

【0134】

なお、図 5 では、スイッチング素子 206 を構成するトランジスタがシングルゲート構造である場合を例示しているが、上記トランジスタは、電氣的に接続された複数のゲート電極を有することで、チャネル形成領域を複数有する、マルチゲート構造であっても良い。

【0135】

また、図 5 では、スイッチング素子 206 がトランジスタを一つだけ有する構成を示しているが、本発明はこの構成に限定されない。本発明の一態様では、スイッチング素子 206 が、トランジスタを複数有していても良い。スイッチング素子 206 が、スイッチング素子として機能するトランジスタを複数有している場合、上記複数のトランジスタは並列に接続されていても良いし、直列に接続されていても良いし、直列と並列が組み合わせられて接続されていても良い。

10

【0136】

なお、本明細書において、トランジスタが直列に接続されている状態とは、第 1 のトランジスタのソースとドレインのいずれか一方のみが、第 2 のトランジスタのソースとドレインのいずれか一方のみに接続されている状態を意味する。また、トランジスタが並列に接続されている状態とは、第 1 のトランジスタのソースとドレインのいずれか一方が、第 2 のトランジスタのソースとドレインのいずれか一方に接続され、第 1 のトランジスタのソースとドレインの他方が第 2 のトランジスタのソースとドレインの他方に接続されている状態を意味する。

20

【0137】

なお、トランジスタが有するソースとドレインは、トランジスタの極性及びソースとドレインに与えられる電位の高低によって、その呼び方が入れ替わる。一般的に、n チャンネル型トランジスタでは、ソースとドレインのうち、低い電位が与えられる方がソースと呼ばれ、高い電位が与えられる方がドレインと呼ばれる。また、p チャンネル型トランジスタでは、ソースとドレインのうち、低い電位が与えられる方がドレインと呼ばれ、高い電位が与えられる方がソースと呼ばれる。本明細書では、便宜上、ソースとドレインとが固定されているものと仮定して、トランジスタの接続関係を説明する場合があるが、実際には上記電位の関係に従ってソースとドレインの呼び方が入れ替わる。

30

【0138】

また、記憶回路 200 は、必要に応じて、ダイオード、抵抗素子、インダクタなどのその他の回路素子を、さらに有していても良い。

【0139】

第 1 の位相反転素子 201 は、ゲート電極が互いに接続された p チャンネル型トランジスタ 207 と、n チャンネル型トランジスタ 208 とが、ハイレベルの電源電位 VDD が与えられる第 1 のノードと、ローレベルの電源電位 VSS が与えられる第 2 のノードの間において、直列に接続された構成を有する。具体的に、p チャンネル型トランジスタ 207 のソースが、電源電位 VDD の与えられる第 1 のノードに接続され、n チャンネル型トランジスタ 208 のソースが、電源電位 VSS の与えられる第 2 のノードに接続される。また、p チャンネル型トランジスタ 207 のドレインと、n チャンネル型トランジスタ 208 のドレインとが接続されており、上記 2 つのドレインの電位は、第 1 の位相反転素子 201 の出力端子の電位とみなすことができる。また、p チャンネル型トランジスタ 207 のゲート電極、及び n チャンネル型トランジスタ 208 のゲート電極の電位は、第 1 の位相反転素子 201 の入力端子の電位とみなすことができる。

40

【0140】

第 2 の位相反転素子 202 は、ゲート電極が互いに接続された p チャンネル型トランジスタ 209 と、n チャンネル型トランジスタ 210 とが、ハイレベルの電源電位 VDD が与えら

50

れる第1のノードと、ローレベルの電源電位VSSが与えられる第2のノードの間において、直列に接続された構成を有する。具体的に、pチャネル型トランジスタ209のソースが、電源電位VDDの与えられる第1のノードに接続され、nチャネル型トランジスタ210のソースが、電源電位VSSの与えられる第2のノードに接続される。また、pチャネル型トランジスタ209のドレインと、nチャネル型トランジスタ210のドレインとが接続されており、上記2つのドレインの電位は、第2の位相反転素子202の出力端子の電位とみなすことができる。また、pチャネル型トランジスタ209のゲート電極、及びnチャネル型トランジスタ210のゲート電極の電位は、第2の位相反転素子202の入力端子の電位とみなすことができる。

【0141】

10

また、トランジスタ203は、そのゲート電極に与えられる信号Sig1によりスイッチングが制御される。また、トランジスタ204は、そのゲート電極に与えられる信号Sig2によりスイッチングが制御される。スイッチング素子206に用いられるトランジスタは、そのゲート電極に与えられる信号Sig3によりスイッチングが制御される。

【0142】

また、本発明の一態様では、第1の位相反転素子201、第2の位相反転素子202には、高速動作が要求される。よって、図1、図3、図36、または図39に示したような、結晶性を有するシリコンを半導体膜に有するnチャネル型トランジスタ102n、またはpチャネル型トランジスタ102pを、第1の位相反転素子201が有するnチャネル型トランジスタ208、またはpチャネル型トランジスタ207として、或いは、第2の位

20

【0143】

なお、トランジスタ203、またはトランジスタ204として、図1、図3、図36、または図39に示したような、結晶性を有するシリコンを半導体膜に有するnチャネル型トランジスタ102n、またはpチャネル型トランジスタ102pを用いても良い。

【0144】

次いで、図5に示す記憶回路200の動作の一例について説明する。

【0145】

まず、データの書き込み時において、トランジスタ203はオン、トランジスタ204はオフ、スイッチング素子206はオフとする。そして、第1のノードに電源電位VDDを与え、第2のノードに電源電位VSSを与えることで、第1のノードと第2のノード間に電源電圧が印加される。記憶回路200に与えられる信号INの電位は、トランジスタ203を介して第1の位相反転素子201の入力端子に与えられるので、第1の位相反転素子201の出力端子は、信号INの位相が反転した電位になる。そして、トランジスタ204をオンにし、第1の位相反転素子201の入力端子と第2の位相反転素子202の出力端子とを接続することで、第1の位相反転素子201及び第2の位相反転素子202にデータが書き込まれる。

30

【0146】

次いで、入力されたデータの保持を、第1の位相反転素子201及び第2の位相反転素子202によって行う場合、トランジスタ204をオン、スイッチング素子206をオフの状態にしたままで、トランジスタ203をオフにする。トランジスタ203をオフにすることで、入力されたデータは、第1の位相反転素子201及び第2の位相反転素子202によって保持される。このとき、第1のノードに電源電位VDDを与え、第2のノードに電源電位VSSを与えることで、第1のノードと第2のノード間に電源電圧が印加されている状態を維持する。

40

【0147】

そして、第1の位相反転素子201の出力端子の電位には、第1の位相反転素子201及び第2の位相反転素子202によって保持されているデータが反映されている。よって、上記電位を読み取ることで、データを記憶回路200から読み出すことができる。

50

## 【 0 1 4 8 】

なお、データの保持時における消費電力を削減するために、入力されたデータの保持を、容量素子 2 0 5 において行う場合、まず、トランジスタ 2 0 3 はオフ、トランジスタ 2 0 4 はオン、スイッチング素子 2 0 6 はオンとする。そして、スイッチング素子 2 0 6 を介して、第 1 の位相反転素子 2 0 1 及び第 2 の位相反転素子 2 0 2 によって保持されているデータの値に見合った量の電荷が容量素子 2 0 5 に蓄積されることで、容量素子 2 0 5 へのデータの書き込みが行われる。容量素子 2 0 5 にデータが記憶された後、スイッチング素子 2 0 6 をオフにすることで、容量素子 2 0 5 に記憶されたデータは保持される。スイッチング素子 2 0 6 をオフにした後は、第 1 のノードと第 2 のノードとに、例えば電源電位  $V_{SS}$  を与えて等電位とすることで、第 1 のノードと第 2 のノード間の電源電圧の印加を停止する。なお、容量素子 2 0 5 にデータが記憶された後は、トランジスタ 2 0 4 をオフにしても良い。

10

## 【 0 1 4 9 】

このように、入力されたデータの保持を容量素子 2 0 5 において行う場合は、第 1 のノードと第 2 のノード間に電源電圧を印加する必要がないので、第 1 の位相反転素子 2 0 1 が有する p チャネル型トランジスタ 2 0 7 及び n チャネル型トランジスタ 2 0 8、或いは、第 2 の位相反転素子 2 0 2 が有する p チャネル型トランジスタ 2 0 9 及び n チャネル型トランジスタ 2 1 0 を介して、第 1 のノードと第 2 のノードの間に流れるオフ電流を限りなく 0 にすることができる。したがって、データの保持時における記憶素子のオフ電流に起因する消費電力を大幅に削減することができ、記憶装置、延いては記憶装置を用いた半導体装置全体の、消費電力を低く抑えることが可能となる。

20

## 【 0 1 5 0 】

また、上述したように、スイッチング素子 2 0 6 に用いられているトランジスタはオフ電流が著しく小さい。よって、上記トランジスタを用いたスイッチング素子 2 0 6 がオフである時、容量素子 2 0 5 に蓄積された電荷はリークしにくいいため、データは保持される。

## 【 0 1 5 1 】

また、容量素子 2 0 5 に記憶されているデータを読み出す場合は、トランジスタ 2 0 3 をオフとする。そして、再び、第 1 のノードに電源電位  $V_{DD}$  を与え、第 2 のノードに電源電位  $V_{SS}$  を与えることで、第 1 のノードと第 2 のノード間に電源電圧を印加する。そして、スイッチング素子 2 0 6 をオンにすることで、データが反映された電位を有する信号  $OUT$  を、記憶回路 2 0 0 から読み出すことができる。

30

## 【 0 1 5 2 】

なお、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタを用いて、第 1 のノードと第 2 のノード間の電源電圧の印加を制御する構成としても良い。図 6 ( A ) に、上記構成を有する記憶装置を一例として示す。

## 【 0 1 5 3 】

図 6 ( A ) に示す記憶装置は、スイッチング素子 4 0 1 と、記憶回路 4 0 2 を複数有する記憶回路群 4 0 3 とを有している。具体的に、各記憶回路 4 0 2 には、図 5 に示した記憶回路 2 0 0 を用いることができる。記憶回路群 4 0 3 が有する各記憶回路 4 0 2 には、スイッチング素子 4 0 1 を介して、ハイレベルの電源電位  $V_{DD}$  が供給されている。さらに、記憶回路群 4 0 3 が有する各記憶回路 4 0 2 には、信号  $IN$  の電位と、ローレベルの電源電位  $V_{SS}$  の電位が与えられている。

40

## 【 0 1 5 4 】

図 6 ( A ) では、スイッチング素子 4 0 1 として、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタを用いており、当該トランジスタは、そのゲート電極に与えられる信号  $SigA$  によりスイッチングが制御される。スイッチング素子 4 0 1 に用いるトランジスタは、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するため、そのオフ電流は、上述したとおり著しく小さい。

## 【 0 1 5 5 】

なお、図 6 ( A ) では、スイッチング素子 4 0 1 がトランジスタを一つだけ有する構成を

50

示しているが、本発明はこの構成に限定されない。本発明の一態様では、スイッチング素子401が、トランジスタを複数有していても良い。スイッチング素子401が、スイッチング素子として機能するトランジスタを複数有している場合、上記複数のトランジスタは並列に接続されていても良いし、直列に接続されていても良いし、直列と並列が組み合わされて接続されていても良い。

#### 【0156】

また、図6(A)では、スイッチング素子401により、記憶回路群403が有する各記憶回路402への、ハイレベルの電源電位VDDの供給が制御されているが、スイッチング素子401により、ローレベルの電源電位VSSの供給が制御されていても良い。図6(B)に、記憶回路群403が有する各記憶回路402に、スイッチング素子401を介して、ローレベルの電源電位VSSが供給されている、記憶装置の一例を示す。スイッチング素子401により、記憶回路群403が有する各記憶回路402への、ローレベルの電源電位VSSの供給を制御することができる。

#### 【0157】

ところで、不揮発性のランダムアクセスメモリとして磁気トンネル接合素子(MTJ素子)が知られている。MTJ素子は、絶縁膜を介して上下に配置している膜中のスピンの向きが平行であれば低抵抗状態、反平行であれば高抵抗状態となることで情報を記憶する素子である。したがって、本実施の形態で示す酸化物半導体を用いた記憶装置とは原理が全く異なっている。表1はMTJ素子と、本実施の形態に係る記憶装置との対比を示す。

#### 【0158】

#### 【表1】

	スピントロニクス(MTJ素子)	OS/Si
1) 耐熱性	キュリー温度	プロセス温度500℃ (信頼性150℃)
2) 駆動方式	電流駆動	電圧駆動
3) 書き込み原理	磁性体のスピンの向きを変える	FETのオン/オフ
4) Si LSI	バイポーラ LSI 向き (バイポーラは高集積化には不向きなため、高集積化回路では MOS の方が好ましい。ただし、W が大きくなる。)	MOSLSI 向き
5) オーバーヘッド	大きい (ジュール熱が大きいため)	2〜3桁以上小さい (寄生容量の充放電)
6) 不揮発性	スピンを利用	オフ電流が小さいことを利用
7) 読み出し回数	無制限	無制限
8) 3D 化	難(できても二層まで)	容易(何層でも可)
9) 集積化度(F <sup>2</sup> )	4F <sup>2</sup> 〜15F <sup>2</sup>	3D 化の積層数で決まる (上層 OSFET 工程のプロセス耐熱性の確保が必要)
10) 材料	磁性を有する希土類	OS 材料
11) ビットコスト	高い	低い (OS を構成する材料によっては(In など)、多少コスト高の可能性有り)
12) 磁界耐性	弱い	強い

#### 【0159】

MTJ素子は磁性材料を使用するためキュリー温度以上にすると磁性が失われてしまうという欠点がある。また、MTJ素子は電流駆動であるため、シリコンのバイポーラデバイスと相性が良いが、バイポーラデバイスは集積化に不向きである。そして、MTJ素子は書き込み電流が微少とはいえメモリの大容量化によって消費電力が増大してしまうといっ

た問題がある。

【0160】

原理的にMTJ素子は磁界耐性に弱く強磁界にさらされるとスピンの向きが狂いやすい。また、MTJ素子に用いる磁性体のナノスケール化によって生じる磁化揺らぎを制御する必要がある。

【0161】

さらに、MTJ素子は希土類元素を使用するため、金属汚染を嫌うシリコン半導体のプロセスに組み入れるには相当の注意を要する。MTJ素子はビット当たりの材料コストから見ても高価であると考えられる。

【0162】

一方、本実施の形態で示す酸化物半導体を用いたトランジスタは、チャネルを形成する半導体材料が金属酸化物であること以外は、素子構造や動作原理がシリコンMOSFETと同様である。また、酸化物半導体を用いたトランジスタは磁界の影響を受けず、ソフトエラーも生じ得ないといった特質を有する。このことからシリコン集積回路と非常に整合性が良いといえる。

【0163】

次いで、本発明の半導体装置の具体的な一形態について説明する。図7に、半導体装置の構成をブロックで一例として示す。

【0164】

半導体装置600は、制御装置601と、演算装置に相当するALU(Arithmetic logic unit)602と、データキャッシュ603と、命令キャッシュ604と、プログラムカウンタ605と、命令レジスタ606と、主記憶装置607と、レジスタファイル608とを有する。

【0165】

制御装置601は、入力された命令をデコードし、実行する機能を有する。ALU602は、四則演算、論理演算などの各種演算処理を行う機能を有する。データキャッシュ603は、使用頻度の高いデータを一時的に記憶しておく緩衝記憶装置である。命令キャッシュ604は、制御装置601に送られる命令(プログラム)のうち、使用頻度の高い命令を一時的に記憶しておく緩衝記憶装置である。プログラムカウンタ605は、次に実行する命令のアドレスを記憶するレジスタである。命令レジスタ606は、次に実行する命令を記憶するレジスタである。主記憶装置607には、ALU602における演算処理に用いられるデータや、制御装置601において実行される命令が記憶されている。レジスタファイル608は、汎用レジスタを含む複数のレジスタを有しており、主記憶装置607から読み出されたデータ、ALU602の演算処理の途中で得られたデータ、或いはALU602の演算処理の結果得られたデータ、などを記憶することができる。

【0166】

次いで、半導体装置600の動作について説明する。

【0167】

制御装置601は、プログラムカウンタ605に記憶されている、次に実行する命令のアドレスに従い、命令キャッシュ604の対応するアドレスから命令を読み出し、命令レジスタ606に上記命令を記憶させる。命令キャッシュ604の対応するアドレスに、該当する命令が記憶されていない場合は、主記憶装置607の対応するアドレスにアクセスし、主記憶装置607から命令を読み出し、命令レジスタ606に記憶させる。この場合、上記命令を命令キャッシュ604にも記憶させておく。

【0168】

制御装置601は、命令レジスタ606に記憶されている命令をデコードし、命令を実行する。具体的には、上記命令に従ってALU602の動作を制御するための各種信号を生成する。

【0169】

実行すべき命令が演算命令の場合は、レジスタファイル608に記憶されているデータを

10

20

30

40

50

用いてALU602に演算処理を行わせ、その演算処理の結果をレジスタファイル608に格納する。

【0170】

実行すべき命令がロード命令の場合は、制御装置601は、まずデータキャッシュ603の対応するアドレスにアクセスし、該当するデータがデータキャッシュ603中にあるか否かを確認する。該当するデータがある場合は、上記データをデータキャッシュ603の対応するアドレスからレジスタファイル608にコピーする。該当するデータがない場合は、上記データを主記憶装置607の対応するアドレスからデータキャッシュ603の対応するアドレスにコピーした後、データキャッシュ603の対応するアドレスからレジスタファイル608に上記データをコピーする。なお、該当するデータがない場合は、低速な主記憶装置607にアクセスする必要があるため、データキャッシュ603などの緩衝記憶装置にのみアクセスする場合よりも、命令の実行に時間を要する。しかし、上記データのコピーに加えて、主記憶装置607における当該データのアドレス及びその近傍のアドレスのデータも緩衝記憶装置にコピーしておくことで、主記憶装置607における当該データのアドレス及びその近傍のアドレスへの2度目以降のアクセスを、高速に行うことができる。

10

【0171】

実行すべき命令がストア命令の場合は、レジスタファイル608のデータを、データキャッシュ603の対応するアドレスに記憶させる。このとき、制御装置601は、まずデータキャッシュ603の対応するアドレスにアクセスし、該当するデータがデータキャッシュ603中に格納できるか否かを確認する。格納できる場合は、上記データをレジスタファイル608からデータキャッシュ603の対応するアドレスにコピーする。格納できない場合は、データキャッシュ603の一部領域に新たに対応するアドレスを割り振り、上記データをレジスタファイル608からデータキャッシュ603の対応するアドレスにコピーする。なお、データキャッシュ603にデータをコピーしたら直ちに、主記憶装置607にも上記データをコピーする構成も可能である。また、幾つかのデータをデータキャッシュ603にコピーした後、それらのデータをまとめて主記憶装置607にコピーする構成も可能である。

20

【0172】

そして、制御装置601は、命令の実行が終了すると、再度プログラムカウンタ605にアクセスし、命令レジスタ606から読み出した命令をデコード、実行するという上記動作を繰り返す。

30

【0173】

なお、図7に示す半導体装置600では、データキャッシュ603や命令キャッシュ604などの緩衝記憶装置に、上記構成を有する記憶装置が設けられている。ALU602は、上記データキャッシュ603や命令キャッシュ604などの緩衝記憶装置における保持動作の選択を行う。すなわち、データキャッシュ603や命令キャッシュ604において、記憶素子にデータを保持するか、容量素子にデータを保持するかを、選択する。記憶素子によるデータの保持が選択されている場合、データキャッシュ603や命令キャッシュ604内の記憶素子への、電源電圧の供給が行われる。容量素子におけるデータの保持が選択されている場合、容量素子へのデータの書き換えが行われ、データキャッシュ603や命令キャッシュ604内の記憶素子への電源電圧の供給が停止される。電源停止に関しては、図6に示すように、記憶回路群と、電源電位VDDまたは電源電位VSSの与えられているノード間に、スイッチング素子を設けることにより行うことができる。

40

【0174】

本発明の一態様では、高速駆動が要求される記憶素子においては、結晶性を有するシリコン、またはゲルマニウムなどの半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタを用いることで、半導体装置600の高速駆動を実現することができる。また、本発明の一態様では、酸化物半導体をチャネル形成領域に有するトランジスタを、容量素子の電荷を保持するためのスイッチング素子として用いる構成とすることで、容量素子からリークする電荷

50

の量を小さく抑えることができる。よって、本発明の一態様では、データキャッシュ 603 や命令キャッシュ 604 などの緩衝記憶装置に、上記構成を有する記憶装置を用いることで、電源の供給を停止してもデータの消失を防ぐことができる。よって、半導体装置 600 全体、もしくは半導体装置 600 を構成する制御装置 601、ALU 602 などの論理回路において、短い時間でも電源の供給を停止することができる。従って、半導体装置 600 の消費電力を小さく抑えることができる。そして、本発明の一態様では、記憶装置において、記憶素子を構成するトランジスタと、スイッチング素子を構成するトランジスタとを積層することで、半導体装置 600 の高集積化を実現することができる。

【0175】

なお、酸化物半導体をチャネル形成領域に用いたトランジスタに限らず、実際に測定されるトランジスタの移動度は、様々な理由によって本来の移動度よりも低くなる。実際に測定される移動度が低い要因として、半導体内部の欠陥や半導体と絶縁膜との界面の欠陥があるが、Levinson モデルを用いると、半導体内部に欠陥がないと仮定した場合の移動度を理論的に導き出せる。半導体の本来の移動度を  $\mu_0$  とし、半導体中に何らかのポテンシャル障壁（粒界等）が存在すると仮定すると、測定される移動度  $\mu$  は以下の数式 3 で表される。

【0176】

【数 2】

$$\mu = \mu_0 \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) \quad (\text{数式 3})$$

【0177】

なお、E はポテンシャル障壁の高さであり、k はボルツマン定数、T は絶対温度である。また、ポテンシャル障壁が欠陥に由来すると仮定すると、Levinson モデルを用いると、E は以下の数式 4 で表される。

【0178】

【数 3】

$$E = \frac{e^2 N^2}{8\epsilon n} = \frac{e^3 N^2 t}{8\epsilon C_{ox} V_{gs}} \quad (\text{数式 4})$$

【0179】

なお、e は電気素量、N はチャネル形成領域内の単位面積当たりの平均欠陥密度、 $\epsilon$  は半導体の誘電率、n はチャネル形成領域のキャリア面密度、 $C_{ox}$  は単位面積当たりの容量、 $V_{gs}$  はゲート電圧、t はチャネル形成領域の厚さである。なお、厚さ 30 nm 以下の半導体膜であれば、チャネル形成領域の厚さは半導体膜の厚さと同一として差し支えない。

【0180】

線形領域におけるドレイン電流  $I_{ds}$  は、以下の数式 5 で表される。

【0181】

【数 4】

$$I_{ds} = \frac{W \mu V_{gs} V_{ds} C_{ox}}{L} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) \quad (\text{数式 5})$$

【0182】

L はチャネル長、W はチャネル幅であり、 $L = W = 10 \mu m$  であるものとする。また、 $V_{ds}$  はドレイン電圧である。数式 5 の両辺を  $V_{gs}$  で除し、更に両辺の対数を取ると、以下の数式 6 が得られる。

【0183】

10

20

30

40

## 【数 5】

$$\ln\left(\frac{I_{ds}}{V_{gs}}\right) = \ln\left(\frac{W\mu V_{ds}C_{ox}}{L}\right) - \frac{E}{kT} = \ln\left(\frac{W\mu V_{ds}C_{ox}}{L}\right) - \frac{e^3 N^2 t}{8kT \epsilon C_{ox} V_{gs}} \quad (\text{数式 6})$$

となる。数式 6 の右辺は  $V_{gs}$  の関数である。数式 6 からわかるように、縦軸を  $\ln(I_{ds}/V_{gs})$ 、横軸を  $1/V_{gs}$  とする直線の傾きから、欠陥密度  $N$  が求められる。すなわち、トランジスタの  $I_{ds}$  -  $V_{gs}$  特性から、欠陥密度を評価できる。

## 【0184】

欠陥密度は酸化物半導体の成膜時の基板温度に依存する。図 21 に、基板加熱温度と欠陥密度の関係を示す。酸化物半導体としては、インジウム (In)、ガリウム (Ga)、亜鉛 (Zn) の比率が、 $In : Ga : Zn = 1 : 1 : 1$  のものを用いた。図 21 では、基板加熱温度が高いものは室温で成膜したものよりも欠陥密度が低下することが示される。

## 【0185】

このようにして求めた欠陥密度等をもとに、数式 3 及び数式 4 により、 $\mu_0 = 120 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$  が導出される。欠陥のある In - Sn - Zn 酸化物で測定される移動度は  $35 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$  程度である。しかし、半導体内部および半導体と絶縁膜との界面の欠陥が無い酸化物半導体の移動度  $\mu_0$  は  $120 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$  となると予想できる。

## 【0186】

ただし、半導体内部に欠陥がなくても、チャネル形成領域とゲート絶縁膜との界面での散乱によってトランジスタの移動度は影響を受ける。すなわち、ゲート絶縁膜界面から  $x$  だけ離れた場所における移動度  $\mu_1$  は、以下の数式 7 で表される。

## 【0187】

## 【数 6】

$$\frac{1}{\mu_1} = \frac{1}{\mu_0} + \frac{D}{B} \exp\left(-\frac{x}{G}\right) \quad (\text{数式 7})$$

## 【0188】

ここで、 $D$  はゲート方向の電界、 $B$ 、 $G$  は定数である。 $B$  および  $G$  は、実際の測定結果より求めることができ、上記の測定結果からは、 $B = 4.75 \times 10^7 \text{ cm/s}$ 、 $G = 10 \text{ nm}$  (界面散乱が及ぶ深さ) である。 $D$  が増加する (すなわち、ゲート電圧が高くなる) と数式 7 の第 2 項が増加するため、移動度  $\mu_1$  は低下することがわかる。

## 【0189】

半導体内部の欠陥が無い理想的な酸化物半導体をチャネル形成領域に用いたトランジスタの移動度  $\mu_2$  を計算した結果を図 22 に示す。なお、計算にはシノプシス社製デバイスシミュレーションソフト、Sentaurus Device を使用し、酸化物半導体のバンドギャップ、電子親和力、比誘電率、厚さをそれぞれ、2.8 電子ボルト、4.7 電子ボルト、15、15 nm とした。これらの値は、スパッタリング法により形成された薄膜を測定して得られたものである。

## 【0190】

さらに、ゲート、ソース、ドレインの仕事関数をそれぞれ、5.5 電子ボルト、4.6 電子ボルト、4.6 電子ボルトとした。また、ゲート絶縁膜の厚さは 100 nm、比誘電率は 4.1 とした。チャネル長およびチャネル幅はともに 10  $\mu\text{m}$ 、ドレイン電圧  $V_{ds}$  は 0.1 V である。

## 【0191】

図 22 で示されるように、ゲート電圧 1 V 強で移動度  $100 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$  以上のピークをつけるが、ゲート電圧がさらに高くなると、界面散乱が大きくなり、移動度が低下する。なお、界面散乱を低減するためには、半導体層表面を原子レベルで平坦にすること (Atomic Layer Flatness) が望ましい。

## 【0192】

10

20

30

40

50

このような移動度を有する酸化物半導体を用いて微細なトランジスタを作製した場合の特性を計算した結果を図23乃至図25に示す。なお、計算に用いたトランジスタの断面構造を図26に示す。図26に示すトランジスタは酸化物半導体層に $n^+$ の導電型を呈する半導体領域1103aおよび半導体領域1103cを有する。半導体領域1103aおよび半導体領域1103cの抵抗率は $2 \times 10^{-3} \text{ cm}$ とする。

#### 【0193】

図26(A)に示すトランジスタは、下地絶縁層1101と、下地絶縁層1101に埋め込まれるように形成された酸化アルミニウムよりなる埋め込み絶縁物1102の上に形成される。トランジスタは半導体領域1103a、半導体領域1103cと、それらに挟まれ、チャネル形成領域となる真性の半導体領域1103bと、ゲート電極1105を有する。ゲート電極1105の幅を33nmとする。

10

#### 【0194】

ゲート電極1105と半導体領域1103bの間には、ゲート絶縁膜1104を有し、また、ゲート電極1105の両側面には側壁絶縁物1106aおよび側壁絶縁物1106b、ゲート電極1105の上部には、ゲート電極1105と他の配線との短絡を防止するための絶縁物1107を有する。側壁絶縁物の幅は5nmとする。また、半導体領域1103aおよび半導体領域1103cに接して、ソース電極1108aおよびドレイン電極1108bを有する。なお、このトランジスタにおけるチャネル幅を40nmとする。

#### 【0195】

図26(B)に示すトランジスタは、下地絶縁層1101と、酸化アルミニウムよりなる埋め込み絶縁物1102の上に形成され、半導体領域1103a、半導体領域1103cと、それらに挟まれた真性の半導体領域1103bと、幅33nmのゲート電極1105とゲート絶縁膜1104と側壁絶縁物1106aおよび側壁絶縁物1106bと絶縁物1107とソース電極1108aおよびドレイン電極1108bを有する点で図26(A)に示すトランジスタと同じである。

20

#### 【0196】

図26(A)に示すトランジスタと図26(B)に示すトランジスタの相違点は、側壁絶縁物1106aおよび側壁絶縁物1106bの下の半導体領域の導電型である。図26(A)に示すトランジスタでは、側壁絶縁物1106aおよび側壁絶縁物1106bの下の半導体領域は $n^+$ の導電型を呈する半導体領域1103aおよび半導体領域1103cであるが、図26(B)に示すトランジスタでは、真性の半導体領域1103bである。すなわち、半導体領域1103a(半導体領域1103c)とゲート電極1105がLoFFだけ重ならない領域ができています。この領域をオフセット領域といい、その幅LoFFをオフセット長という。図から明らかなように、オフセット長は、側壁絶縁物1106a(側壁絶縁物1106b)の幅と同じである。

30

#### 【0197】

その他の計算に使用するパラメータは上述の通りである。計算にはシノプシス社製デバイスシミュレーションソフト、Sentaurus Deviceを使用した。図23は、図26(A)に示される構造のトランジスタのドレイン電流( $I_{ds}$ 、実線)および移動度( $\mu$ 、点線)のゲート電圧( $V_{gs}$ 、ゲートとソースの電位差)依存性を示す。ドレイン電流 $I_{ds}$ は、ドレイン電圧(ドレインとソースの電位差)を+1Vとし、移動度 $\mu$ はドレイン電圧を+0.1Vとして計算したものである。

40

#### 【0198】

図23(A)はゲート絶縁膜の厚さを15nmとしたものであり、図23(B)は10nmとしたものであり、図23(C)は5nmとしたものである。ゲート絶縁膜が薄くなるほど、特にオフ状態でのドレイン電流 $I_{ds}$ (オフ電流)が顕著に小さくなる。一方、移動度 $\mu$ のピーク値やオン状態でのドレイン電流 $I_{ds}$ (オン電流)には目立った変化が無い。ゲート電圧1V前後で、ドレイン電流はメモリ素子等で必要とされる10 $\mu$ Aを超えることが示された。

#### 【0199】

50

図24は、図26(B)に示される構造のトランジスタで、オフセット長 $L_{off}$ を5nmとしたもののドレイン電流 $I_{ds}$ （実線）および移動度 $\mu$ （点線）のゲート電圧 $V_{gs}$ 依存性を示す。ドレイン電流 $I_{ds}$ は、ドレイン電圧を+1Vとし、移動度 $\mu$ はドレイン電圧を+0.1Vとして計算したものである。図24(A)はゲート絶縁膜の厚さを15nmとしたものであり、図24(B)は10nmとしたものであり、図24(C)は5nmとしたものである。

#### 【0200】

また、図25は、図26(B)に示される構造のトランジスタで、オフセット長 $L_{off}$ を15nmとしたもののドレイン電流 $I_{ds}$ （実線）および移動度 $\mu$ （点線）のゲート電圧依存性を示す。ドレイン電流 $I_{ds}$ は、ドレイン電圧を+1Vとし、移動度 $\mu$ はドレイン電圧を+0.1Vとして計算したものである。図25(A)はゲート絶縁膜の厚さを15nmとしたものであり、図25(B)は10nmとしたものであり、図25(C)は5nmとしたものである。

10

#### 【0201】

いずれもゲート絶縁膜が薄くなるほど、オフ電流が顕著に小さくなる一方、移動度 $\mu$ のピーク値やオン電流には目立った変化が無い。

#### 【0202】

なお、移動度 $\mu$ のピークは、図23では $80\text{ cm}^2/\text{Vs}$ 程度であるが、図24では $60\text{ cm}^2/\text{Vs}$ 程度、図25では $40\text{ cm}^2/\text{Vs}$ と、オフセット長 $L_{off}$ が増加するほど低下する。また、オフ電流も同様な傾向がある。一方、オン電流にはオフセット長 $L_{off}$ の増加にともなって小さくなるが、オフ電流が小さくなるのに比べるとはるかに緩やかである。また、いずれもゲート電圧1V前後で、ドレイン電流はメモリ素子等で必要とされる $10\text{ }\mu\text{A}$ を超えることが示された。

20

#### 【0203】

また、In、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体をチャネル形成領域とするトランジスタは、該酸化物半導体を形成する際に基板を加熱して成膜すること、或いは酸化物半導体膜を形成した後に熱処理を行うことで良好な特性を得ることができる。なお、主成分とは組成比で5at. %以上含まれる元素をいう。

#### 【0204】

In、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体膜の成膜後に基板を意図的に加熱することで、トランジスタの移動度を向上させることが可能となる。また、トランジスタのしきい値電圧をプラスシフトさせ、ノーマリ・オフ化させることが可能となる。

30

#### 【0205】

例えば、図27(A)～図27(C)は、In、Sn、Znを主成分とし、チャネル長 $L$ が $3\text{ }\mu\text{m}$ 、チャネル幅 $W$ が $10\text{ }\mu\text{m}$ である酸化物半導体膜と、厚さ $100\text{ nm}$ のゲート絶縁膜を用いたトランジスタの特性である。なお、 $V_{ds}$ は10Vとした。

#### 【0206】

図27(A)は基板を意図的に加熱せずにスパッタリング法でIn、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体膜を形成したときのトランジスタ特性である。このとき移動度は $18.8\text{ cm}^2/\text{Vs}$ が得られている。一方、基板を意図的に加熱してIn、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体膜を形成すると移動度を向上させることが可能となる。図27(B)は基板を $200^\circ\text{C}$ に加熱してIn、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体膜を形成したときのトランジスタ特性を示すが、移動度は $32.2\text{ cm}^2/\text{Vs}$ が得られている。

40

#### 【0207】

移動度は、In、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体膜を形成した後に熱処理をすることによって、さらに高めることができる。図27(C)は、In、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体膜を $200^\circ\text{C}$ でスパッタリング成膜した後、 $650^\circ\text{C}$ で熱処理をしたときのトランジスタ特性を示す。このとき移動度は $34.5\text{ cm}^2/\text{Vs}$ が得られている。

#### 【0208】

50

基板を意図的に加熱することでスパッタリング成膜中の水分が酸化物半導体膜中に取り込まれるのを低減する効果が期待できる。また、成膜後に熱処理をすることによっても、酸化物半導体膜から水素や水酸基若しくは水分を放出させ除去することができ、上記のように移動度を向上させることができる。このような移動度の向上は、脱水化・脱水素化による不純物の除去のみならず、高密度化により原子間距離が短くなるためとも推定される。また、酸化物半導体から不純物を除去して高純度化することで結晶化を図ることができる。このように高純度化された非単結晶酸化物半導体は、理想的には  $100 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$  を超える移動度を実現することも可能になると推定される。

#### 【0209】

In、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体に酸素イオンを注入し、熱処理により該酸化物半導体に含まれる水素や水酸基若しくは水分を放出させ、その熱処理と同時に又はその後の熱処理により酸化物半導体を結晶化させても良い。このような結晶化若しくは再結晶化の処理により結晶性の良い非単結晶酸化物半導体を得ることができる。

10

#### 【0210】

基板を意図的に加熱して成膜すること及び／又は成膜後に熱処理することの効果は、移動度の向上のみならず、トランジスタのノーマリ・オフ化を図ることにも寄与している。基板を意図的に加熱しないで形成されたIn、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体膜をチャネル形成領域としたトランジスタは、しきい値電圧がマイナスシフトしてしまう傾向がある。しかし、基板を意図的に加熱して形成された酸化物半導体膜を用いた場合、このしきい値電圧のマイナスシフト化は解消される。つまり、しきい値電圧はトランジスタがノーマリ・オフとなる方向に動き、このような傾向は図27(A)と図27(B)の対比からも確認することができる。

20

#### 【0211】

なお、しきい値電圧はIn、Sn及びZnの比率を変えることによっても制御することが可能であり、組成比としてIn:Sn:Zn=2:1:3とすることでトランジスタのノーマリ・オフ化を期待することができる。また、ターゲットの組成比をIn:Sn:Zn=2:1:3とすることで結晶性の高い酸化物半導体膜を得ることができる。

#### 【0212】

意図的な基板加熱温度若しくは熱処理温度は、150 以上、好ましくは200 以上、より好ましくは400 以上であり、より高温で成膜し或いは熱処理することでトランジスタのノーマリ・オフ化を図ることが可能となる。

30

#### 【0213】

また、意図的に基板を加熱した成膜及び／又は成膜後に熱処理をすることで、ゲートバイアス・ストレスに対する安定性を高めることができる。例えば、2MV/cm、150、1時間印加の条件において、ドリフトがそれぞれ±1.5V未満、好ましくは1.0V未満を得ることができる。

#### 【0214】

実際に、酸化物半導体膜成膜後に加熱処理を行っていない試料1と、650 の加熱処理を行った試料2のトランジスタに対してBT試験を行った。

#### 【0215】

まず基板温度を25 とし、 $V_{ds}$ を10Vとし、トランジスタの $V_{gs} - I_{ds}$ 特性の測定を行った。次に、基板温度を150 とし、 $V_{ds}$ を0.1Vとした。次に、ゲート絶縁膜に印加される電界強度が2MV/cmとなるように $V_{gs}$ に20Vを印加し、そのまま1時間保持した。次に、 $V_{gs}$ を0Vとした。次に、基板温度25 とし、 $V_{ds}$ を10Vとし、トランジスタの $V_{gs} - I_{ds}$ 測定を行った。これをプラスBT試験と呼ぶ。

40

#### 【0216】

同様に、まず基板温度を25 とし、 $V_{ds}$ を10Vとし、トランジスタの $V_{gs} - I_{ds}$ 特性の測定を行った。次に、基板温度を150 とし、 $V_{ds}$ を0.1Vとした。次に、ゲート絶縁膜に印加される電界強度が-2MV/cmとなるように $V_{gs}$ に-20Vを

50

印加し、そのまま1時間保持した。次に、 $V_{gs}$ を0Vとした。次に、基板温度25とし、 $V_{ds}$ を10Vとし、トランジスタの $V_{gs} - I_{ds}$ 測定を行った。これをマイナスBT試験と呼ぶ。

#### 【0217】

試料1のプラスBT試験の結果を図28(A)に、マイナスBT試験の結果を図28(B)に示す。また、試料2のプラスBT試験の結果を図29(A)に、マイナスBT試験の結果を図29(B)に示す。

#### 【0218】

試料1のプラスBT試験およびマイナスBT試験によるしきい値電圧の変動は、それぞれ1.80Vおよび-0.42Vであった。また、試料2のプラスBT試験およびマイナスBT試験によるしきい値電圧の変動は、それぞれ0.79Vおよび0.76Vであった。試料1および試料2のいずれも、BT試験前後におけるしきい値電圧の変動が小さく、信頼性が高いことがわかる。

#### 【0219】

熱処理は酸素雰囲気中で行うことができるが、まず窒素若しくは不活性ガス、または減圧下で熱処理を行ってから酸素を含む雰囲気中で熱処理を行っても良い。最初に脱水化・脱水素化を行ってから酸素を酸化物半導体に加えることで、熱処理の効果をより高めることができる。また、後から酸素を加えるには、酸素イオンを電界で加速して酸化物半導体膜に注入する方法を適用しても良い。

#### 【0220】

酸化物半導体中及び積層される膜との界面には、酸素欠損による欠陥が生成されやすいが、かかる熱処理により酸化物半導体中に酸素を過剰に含ませることにより、定常的に生成される酸素欠損を過剰な酸素によって補償することが可能となる。過剰酸素は主に格子間に存在する酸素であり、その酸素濃度は $1 \times 10^{16} / \text{cm}^3$ 以上 $2 \times 10^{20} / \text{cm}^3$ 以下とすれば、結晶に歪み等を与えることなく酸化物半導体中に含ませることができる。

#### 【0221】

また、熱処理によって酸化物半導体に結晶が少なくとも一部に含まれるようにすることで、より安定な酸化物半導体膜を得ることができる。例えば、組成比 $\text{In} : \text{Sn} : \text{Zn} = 1 : 1 : 1$ のターゲットを用いて、基板を意図的に加熱せずにスパッタリング成膜した酸化物半導体膜は、X線回折(XRD: X-Ray Diffraction)でハローパターンが観測される。この成膜された酸化物半導体膜を熱処理することによって結晶化させることができる。熱処理温度は任意であるが、例えば650の熱処理を行うことで、X線回折により明確な回折ピークを観測することができる。

#### 【0222】

実際に、 $\text{In} - \text{Sn} - \text{Zn}$ 系酸化物半導体膜のXRD分析を行った。XRD分析には、Bruker AXS社製X線回折装置D8 ADVANCEを用い、Out-of-Plane法で測定した。

#### 【0223】

XRD分析を行った試料として、試料Aおよび試料Bを用意した。以下に試料Aおよび試料Bの作製方法を説明する。

#### 【0224】

脱水素化処理済みの石英基板上に $\text{In} - \text{Sn} - \text{Zn}$ 系酸化物半導体膜を100nmの厚さで成膜した。

#### 【0225】

$\text{In} - \text{Sn} - \text{Zn}$ 系酸化物半導体膜は、スパッタリング装置を用い、酸素雰囲気中で電力を100W(DC)として成膜した。ターゲットは、 $\text{In} : \text{Sn} : \text{Zn} = 1 : 1 : 1$  [原子数比]の $\text{In} - \text{Sn} - \text{Zn}$ 系酸化物ターゲットを用いた。なお、成膜時の基板加熱温度は200とした。このようにして作製した試料を試料Aとした。

#### 【0226】

次に、試料Aと同様の方法で作製した試料に対し加熱処理を650の温度で行った。加

10

20

30

40

50

熱処理は、はじめに窒素雰囲気中で1時間の加熱処理を行い、温度を下げずに酸素雰囲気中でさらに1時間の加熱処理を行っている。このようにして作製した試料を試料Bとした。

【0227】

図30に試料Aおよび試料BのXRDスペクトルを示す。試料Aでは、結晶由来のピークが観測されなかったが、試料Bでは、 $2\theta$ が $35^\circ$ 近傍および $37^\circ \sim 38^\circ$ に結晶由来のピークが観測された。

【0228】

このように、In、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体は成膜時に意図的に加熱すること及び/又は成膜後に熱処理することによりトランジスタの特性を向上させることができる。

10

【0229】

この基板加熱や熱処理は、酸化物半導体にとって悪性の不純物である水素や水酸基を膜中に含まないようにすること、或いは膜中から除去する作用がある。すなわち、酸化物半導体中でドナー不純物となる水素を除去することで高純度化を図ることができ、それによってトランジスタのノーマリ・オフ化を図ることができ、酸化物半導体が高純度化されることによりオフ電流を $1\text{ aA}/\mu\text{m}$ 以下にすることができる。ここで、上記オフ電流値の単位は、チャンネル幅 $1\mu\text{m}$ あたりの電流値を示す。

【0230】

図31に、トランジスタのオフ電流と測定時の基板温度（絶対温度）の逆数との関係を示す。ここでは、簡単のため測定時の基板温度の逆数に $1000$ を掛けた数値（ $1000/T$ ）を横軸としている。

20

【0231】

具体的には、図31に示すように、基板温度が $125^\circ\text{C}$ の場合には $1\text{ aA}/\mu\text{m}$ （ $1 \times 10^{-18}\text{ A}/\mu\text{m}$ ）以下、 $85^\circ\text{C}$ の場合には $100\text{ zA}/\mu\text{m}$ （ $1 \times 10^{-19}\text{ A}/\mu\text{m}$ ）以下、室温（ $27^\circ\text{C}$ ）の場合には $1\text{ zA}/\mu\text{m}$ （ $1 \times 10^{-21}\text{ A}/\mu\text{m}$ ）以下にすることができる。好ましくは、 $125^\circ\text{C}$ において $0.1\text{ aA}/\mu\text{m}$ （ $1 \times 10^{-19}\text{ A}/\mu\text{m}$ ）以下に、 $85^\circ\text{C}$ において $10\text{ zA}/\mu\text{m}$ （ $1 \times 10^{-20}\text{ A}/\mu\text{m}$ ）以下に、室温において $0.1\text{ zA}/\mu\text{m}$ （ $1 \times 10^{-22}\text{ A}/\mu\text{m}$ ）以下にすることができる。これらのオフ電流値は、Siを半導体膜として用いたトランジスタに比べて、極めて小さいものであることは明らかである。

30

【0232】

もっとも、酸化物半導体膜の成膜時に水素や水分が膜中に混入しないように、成膜室外部からのリークや成膜室内の内壁からの脱ガスを十分抑え、スパッタガスの高純度化を図ることが好ましい。例えば、スパッタガスは水分が膜中に含まれないように露点 $-70^\circ\text{C}$ 以下であるガスを用いることが好ましい。また、ターゲットそのものに水素や水分などの不純物が含まれていていないように、高純度化されたターゲットを用いることが好ましい。In、Sn、Znを主成分とする酸化物半導体は熱処理によって膜中の水分を除去することができるが、In、Ga、Znを主成分とする酸化物半導体と比べて水分の放出温度が高いため、好ましくは最初から水分の含まれない膜を形成しておくことが好ましい。

【0233】

また、酸化物半導体膜成膜後に $650^\circ\text{C}$ の加熱処理を行った試料Bのトランジスタにおいて、基板温度と電気的特性の関係について評価した。

40

【0234】

測定に用いたトランジスタは、チャンネル長 $L$ が $3\mu\text{m}$ 、チャンネル幅 $W$ が $10\mu\text{m}$ 、 $L_{ov}$ が $0\mu\text{m}$ 、 $dW$ が $0\mu\text{m}$ である。なお、 $V_{ds}$ は $10\text{ V}$ とした。なお、基板温度は $-40^\circ\text{C}$ 、 $-25^\circ\text{C}$ 、 $25^\circ\text{C}$ 、 $75^\circ\text{C}$ 、 $125^\circ\text{C}$ および $150^\circ\text{C}$ で行った。ここで、トランジスタにおいて、ゲート電極と一对の電極との重畳する幅を $L_{ov}$ と呼び、酸化物半導体膜に対する一对の電極のはみ出しを $dW$ と呼ぶ。

【0235】

図32に、 $I_{ds}$ （実線）および移動度（点線）の $V_{gs}$ 依存性を示す。また、図33（

50

A) に基板温度としきい値電圧の関係を、図 3 3 ( B ) に基板温度と移動度の関係を示す。

【 0 2 3 6 】

図 3 3 ( A ) より、基板温度が高いほどしきい値電圧は低くなることがわかる。なお、その範囲は - 4 0 ~ 1 5 0 で 1 . 0 9 V ~ - 0 . 2 3 V であった。

【 0 2 3 7 】

また、図 3 3 ( B ) より、基板温度が高いほど移動度が低くなることがわかる。なお、その範囲は - 4 0 ~ 1 5 0 で  $36 \text{ cm}^2 / \text{Vs} \sim 32 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$  であった。従って、上述の温度範囲において電気的特性の変動が小さいことがわかる。

【 0 2 3 8 】

上記のような  $I_n$ 、 $S_n$ 、 $Z_n$  を主成分とする酸化物半導体をチャネル形成領域とするトランジスタによれば、オフ電流を  $1 \text{ aA} / \mu\text{m}$  以下に保ちつつ、移動度を  $30 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$  以上、好ましくは  $40 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$  以上、より好ましくは  $60 \text{ cm}^2 / \text{Vs}$  以上とし、 $LSI$  で要求されるオン電流の値を満たすことができる。例えば、 $L/W = 33 \text{ nm} / 40 \text{ nm}$  の  $FET$  で、ゲート電圧  $2.7 \text{ V}$ 、ドレイン電圧  $1.0 \text{ V}$  のとき  $12 \mu\text{A}$  以上のオン電流を流すことができる。またトランジスタの動作に求められる温度範囲においても、十分な電気的特性を確保することができる。このような特性であれば、 $Si$  半導体で作られる集積回路の中に酸化物半導体で形成されるトランジスタを混載しても、動作速度を犠牲にすることなく新たな機能を有する集積回路を実現することができる。

【 0 2 3 9 】

( 実施の形態 2 )

本実施の形態では、図 3 に示す構成をその一部に有する半導体装置の、作製方法の一例について説明する。

【 0 2 4 0 】

ただし、記憶素子が有する  $n$  チャネル型トランジスタ  $102n$  及び  $p$  チャネル型トランジスタ  $102p$  は、シリコンの他、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、単結晶炭化シリコンなどの半導体材料を用いても良い。また、例えば、シリコンを用いた  $n$  チャネル型トランジスタ  $102n$  及び  $p$  チャネル型トランジスタ  $102p$  は、シリコンウェハなどの単結晶半導体基板、 $SOI$  法により作製されたシリコン薄膜、気相成長法により作製されたシリコン薄膜などを用いて形成することができる。

【 0 2 4 1 】

本実施の形態では、まず、図 8 ( A ) に示すように、基板  $100$  上に絶縁膜  $101$  と、島状である単結晶の半導体膜  $103n$  及び半導体膜  $103p$  を形成する。

【 0 2 4 2 】

基板  $100$  として使用することができる素材に大きな制限はないが、少なくとも、後の加熱処理に耐えうる程度の耐熱性を有していることが必要となる。例えば、基板  $100$  には、フュージョン法やフロート法で作製されるガラス基板、石英基板、半導体基板、セラミック基板等を用いることができる。ガラス基板としては、後の加熱処理の温度が高い場合には、歪み点が  $730$  以上のものを用いると良い。

【 0 2 4 3 】

本実施の形態では、単結晶シリコンの半導体基板を基板  $100$  として用いる。単結晶の半導体基板はガラス基板よりも表面の平坦性が高い。よって、基板のうねりに起因して絶縁膜や導電膜などの膜厚がばらつくのを防ぐことができるため、トランジスタなどの半導体素子を微細化しても半導体素子の電気的特性を均一にすることができる。

【 0 2 4 4 】

絶縁膜  $101$  は、酸化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン等の絶縁性を有する材料を用いて形成する。絶縁膜  $101$  は、単数の絶縁膜を用いたものであっても、複数の絶縁膜を積層して用いたものであっても良い。

【 0 2 4 5 】

例えば酸化シリコンを絶縁膜  $101$  として用いる場合、絶縁膜  $101$  はシランと酸素、 $T$

10

20

30

40

50

EOS（テトラエトキシシラン）と酸素等の混合ガスを用い、熱CVD、プラズマCVD、常圧CVD、バイアスECRCVD等の気相成長法によって形成することができる。この場合、絶縁膜101の表面を酸素プラズマ処理で緻密化しても良い。また、窒化シリコンを絶縁膜101として用いる場合、シランとアンモニアの混合ガスを用い、プラズマCVD等の気相成長法によって形成することができる。また、窒化酸化シリコンを絶縁膜101として用いる場合、シランとアンモニアの混合ガス、またはシランと酸化窒素の混合ガスを用い、プラズマCVD等の気相成長法によって形成することができる。

#### 【0246】

また絶縁膜101として、有機シランガスを用いて化学気相成長法により作製される酸化シリコンを用いても良い。有機シランガスとしては、珪酸エチル（TEOS：化学式 $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ）、テトラメチルシラン（TMS：化学式 $\text{Si}(\text{CH}_3)_4$ ）、テトラメチルシクロテトラシロキサン（TMCTS）、オクタメチルシクロテトラシロキサン（OMCTS）、ヘキサメチルジシラザン（HMDS）、トリエトキシシラン（ $\text{SiH}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ ）、トリスジメチルアミノシラン（ $\text{SiH}(\text{N}(\text{CH}_3)_2)_3$ ）等のシリコン含有化合物を用いることができる。

#### 【0247】

また、基板100が単結晶シリコンの半導体基板である場合、基板100の表面を酸化することで得られる酸化膜で、絶縁膜101を構成することもできる。上記酸化膜を形成するための、熱酸化処理には、ドライ酸化でも良いが、酸化雰囲気中にハロゲンを含むガスを添加しても良い。ハロゲンを含むガスとして、 $\text{HCl}$ 、 $\text{HF}$ 、 $\text{NF}_3$ 、 $\text{HBr}$ 、 $\text{Cl}$ 、 $\text{ClF}$ 、 $\text{BCl}_3$ 、 $\text{F}$ 、 $\text{Br}_2$ などから選ばれた一種又は複数種ガスを用いることができる。

#### 【0248】

例えば $\text{HCl}$ を用いる場合、酸素に対し $\text{HCl}$ を0.5～10体積%（好ましくは3体積%）の割合で含む雰囲気中で、700以上の温度で熱処理を行う。950以上1100以下の加熱温度で熱酸化を行うとよい。処理時間は0.1～6時間、好ましくは0.5～1時間とすればよい。形成される絶縁膜101の膜厚は、15nm～1100nm（好ましくは60nm～300nm）、例えば150nmとすることができる。

#### 【0249】

このハロゲンを含む雰囲気での熱酸化処理により、絶縁膜101にハロゲンを含ませることができる。ハロゲン元素を $1 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3 \sim 5 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度で絶縁膜101に含ませることにより、金属などの不純物を絶縁膜101が捕獲するので、後に形成される半導体膜103n及び半導体膜103pの汚染を防止することができる。例えば、塩素の作用により、金属などの不純物が揮発性の塩化物となって気相中へ離脱して、半導体膜103n及び半導体膜103pから除去される。

#### 【0250】

また、本実施の形態では、半導体膜103n及び半導体膜103pが単結晶のシリコンである場合を例に挙げて、以下、記憶素子が有するトランジスタの作製方法について説明する。なお、具体的な単結晶の半導体膜103n及び半導体膜103pの作製方法の一例について、簡単に説明する。まず、単結晶シリコンの半導体基板であるボンド基板に、電界で加速されたイオンでなるイオンビームを注入し、ボンド基板の表面から一定の深さの領域に、結晶構造が乱されることで局所的に脆弱化された脆化層を形成する。脆化層が形成される領域の深さは、イオンビームの加速エネルギーとイオンビームの入射角によって調節することができる。そして、ボンド基板と、表面に絶縁膜が形成された基板100とを、間に当該絶縁膜が挟まるように貼り合わせる。貼り合わせは、ボンド基板と基板100とを重ね合わせた後、ボンド基板と基板100の一部に、 $1 \text{ N/cm}^2$ 以上 $500 \text{ N/cm}^2$ 以下、好ましくは $11 \text{ N/cm}^2$ 以上 $20 \text{ N/cm}^2$ 以下程度の圧力を加える。圧力を加えると、その部分からボンド基板と絶縁膜101とが接合を開始し、最終的には密着した面全体に接合が及ぶ。次いで、加熱処理を行うことで、脆化層に存在する微小ボイド同士が結合して、微小ボイドの体積が増大する。その結果、脆化層においてボンド基板の

10

20

30

40

50

一部である単結晶半導体膜が、ボンド基板から分離する。上記加熱処理の温度は、基板 100 の歪み点を越えない温度とする。そして、上記単結晶半導体膜をエッチング等により所望の形状に加工することで、半導体膜 103 n 及び半導体膜 103 p を形成することができる。

#### 【0251】

本実施の形態では、単結晶シリコンの半導体基板である基板 100 に、酸素雰囲気中で 950 の温度で加熱処理を施すことで、基板 100 上に膜厚 400 nm の酸化シリコン膜を形成する。次いで、酸化シリコン膜上に、プラズマ CVD により、膜厚 50 nm の窒化酸化シリコン膜を形成する。一方、単結晶シリコンの半導体基板であるボンド基板に、酸素に HCl を含ませた雰囲気中で、950 の温度で加熱処理を行うことで、ボンド基板上に膜厚 100 nm の酸化シリコン膜を形成する。そして、上記基板 100 と、ボンド基板とを、基板 100 上の窒化酸化シリコン膜と、ボンド基板上の酸化シリコン膜とが接するように貼り合わせる。そして、脆化層においてボンド基板の一部である単結晶の半導体膜を、ボンド基板から分離させる。従って、本実施の形態では、絶縁膜 101 が、基板 100 側から、膜厚 400 nm の酸化シリコン膜、膜厚 50 nm の窒化酸化シリコン膜、膜厚 100 nm の酸化シリコン膜が、順に積層された構成を有する。

#### 【0252】

半導体膜 103 n 及び半導体膜 103 p には、閾値電圧を制御するために、硼素、アルミニウム、ガリウムなどの p 型の導電性を付与する不純物元素、若しくはリン、砒素などの n 型の導電性を付与する不純物元素を添加しても良い。閾値電圧を制御するための不純物元素の添加は、パターニングする前の半導体膜に対して行っても良いし、パターニング後に形成された半導体膜 103 n 及び半導体膜 103 p に対して行っても良い。また、閾値電圧を制御するための不純物元素の添加を、ボンド基板に対して行っても良い。若しくは、不純物元素の添加を、閾値電圧を大まかに調整するためにボンド基板に対して行った上で、閾値電圧を微調整するために、パターニング前の半導体膜に対して、又はパターニングにより形成された半導体膜 103 n 及び半導体膜 103 p に対しても行っても良い。

#### 【0253】

なお、本実施の形態では、単結晶の半導体膜を用いる例について説明しているが、本発明はこの構成に限定されない。例えば、絶縁膜 101 上に気相成長法を用いて形成された多結晶の半導体膜を用いても良いし、気相成長法を用いて形成された半導体膜を公知の技術により結晶化して多結晶の半導体膜を形成しても良い。公知の結晶化方法としては、レーザー光を用いたレーザー結晶化法、触媒元素を用いる結晶化法がある。或いは、触媒元素を用いる結晶化法とレーザー結晶化法とを組み合わせることもできる。また、石英基板のような耐熱性に優れている基板を用いる場合、電熱炉を使用した熱結晶化方法、赤外光を用いたランプアニール結晶化法、触媒元素を用いる結晶化法、950 程度の高温アニール法を用いた結晶化法を用いても良い。

#### 【0254】

次に、図 8 (B) に示すように、半導体膜 103 n 及び半導体膜 103 p 上にゲート絶縁膜 104 n 及びゲート絶縁膜 104 p をそれぞれ形成した後、半導体膜 103 n と重なる位置においてゲート絶縁膜 104 n 上にゲート電極 105 n を、半導体膜 103 p と重なる位置においてゲート絶縁膜 104 p 上にゲート電極 105 p を形成する。そして、ゲート電極 105 n 及びゲート電極 105 p をマスクとして、一導電性を付与する不純物元素を半導体膜 103 n 及び半導体膜 103 p に添加する。具体的には、まず、半導体膜 103 n を覆うようにマスクを形成した後、半導体膜 103 p に、p 型の導電性を付与する不純物元素を添加する。上記不純物元素の添加により、半導体膜 103 p には、ゲート電極 105 p と重なる第 1 の領域 114 と、第 1 の領域 114 を間に挟む低濃度不純物領域 117 a 及び低濃度不純物領域 118 a とが形成される。次いで、半導体膜 103 p を覆うようにマスクを形成した後、半導体膜 103 n に、n 型の導電性を付与する不純物元素を添加する。上記不純物元素の添加により、半導体膜 103 n には、ゲート電極 105 n と重なる第 1 の領域 108 と、第 1 の領域 108 を間に挟む低濃度不純物領域 111 a 及び

低濃度不純物領域 1 1 2 a とが形成される。

【 0 2 5 5 】

ゲート絶縁膜 1 0 4 n 及びゲート絶縁膜 1 0 4 p は、高密度プラズマ処理、熱酸化処理などを行うことにより半導体膜 1 0 3 n 及び半導体膜 1 0 3 p の表面を酸化又は窒化することで形成することができる。ゲート絶縁膜 1 0 4 n 及びゲート絶縁膜 1 0 4 p の厚さは、例えば、1 nm 以上 1 0 0 nm 以下、好ましくは 1 0 nm 以上 5 0 nm 以下とすることができる。

【 0 2 5 6 】

本実施の形態では、酸素雰囲気中において 2 5 分間 9 5 0 にて加熱処理を行った後、酸素雰囲気中において 1 時間 9 5 0 にて加熱処理を行うことにより、半導体膜 1 0 3 n 及び半導体膜 1 0 3 p の表面を熱酸化し、膜厚 1 5 nm の酸化シリコン膜で構成されるゲート絶縁膜 1 0 4 n 及びゲート絶縁膜 1 0 4 p を形成する。

【 0 2 5 7 】

高密度プラズマ処理を用いる場合は、例えば H e 、 A r 、 K r 、 X e などの希ガスと酸素、酸化窒素、アンモニア、窒素などの混合ガスとを用いる。この場合、プラズマの励起をマイクロ波の導入により行うことで、低電子温度で高密度のプラズマを生成することができる。このような高密度のプラズマで生成された酸素ラジカル ( O H ラジカルを含む場合もある ) や窒素ラジカル ( N H ラジカルを含む場合もある ) によって、半導体膜の表面を酸化又は窒化することにより、1 ~ 2 0 nm、望ましくは 5 ~ 1 0 nm の絶縁膜が半導体膜に接するように形成できる。例えば、亜酸化窒素 ( N <sub>2</sub> O ) を A r で 1 ~ 3 倍 ( 流量比 ) に希釈して、1 0 P a ~ 3 0 P a の圧力にて 3 k W ~ 5 k W のマイクロ波 ( 2 . 4 5 G H z ) 電力を印加して半導体膜 1 0 3 n 及び半導体膜 1 0 3 p の表面を酸化若しくは窒化させる。この処理により 1 nm ~ 1 0 nm ( 好ましくは 2 nm ~ 6 nm ) の絶縁膜を形成する。更に亜酸化窒素 ( N <sub>2</sub> O ) とシラン ( S i H <sub>4</sub> ) を導入し、1 0 P a ~ 3 0 P a の圧力にて 3 k W ~ 5 k W のマイクロ波 ( 2 . 4 5 G H z ) 電力を印加して気相成長法により酸化窒化シリコン膜を形成することにより、ゲート絶縁膜を形成する。固相反応と気相成長法による反応を組み合わせることにより界面準位密度が低く絶縁耐压の優れたゲート絶縁膜を形成することができる。

【 0 2 5 8 】

上述した高密度プラズマ処理による半導体膜の酸化又は窒化は固相反応で進むため、ゲート絶縁膜 1 0 4 n 及びゲート絶縁膜 1 0 4 p と半導体膜 1 0 3 n 及び半導体膜 1 0 3 p との界面準位密度を極めて低くすることができる。また高密度プラズマ処理により半導体膜 1 0 3 n 及び半導体膜 1 0 3 p を直接酸化又は窒化することで、形成される絶縁膜の厚さのばらつきを抑えることができる。また半導体膜が結晶性を有する場合、高密度プラズマ処理を用いて半導体膜の表面を固相反応で酸化させることにより、結晶粒界においてのみ酸化が速く進んでしまうのを抑え、均一性が良く、界面準位密度の低いゲート絶縁膜を形成することができる。高密度プラズマ処理により形成された絶縁膜を、ゲート絶縁膜の一部又は全部に含んで形成されるトランジスタは、電気的特性のばらつきを抑えることができる。

【 0 2 5 9 】

また、プラズマ C V D 法又はスパッタ法などを用い、酸化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム又は酸化タンタル、酸化イットリウム、ハフニウムシリケート ( H f S i <sub>x</sub> O <sub>y</sub> ( x > 0 、 y > 0 ) ) 、窒素が添加されたハフニウムシリケート ( H f S i <sub>x</sub> O <sub>y</sub> ( x > 0 、 y > 0 ) ) 、窒素が添加されたハフニウムアルミネート ( H f A l <sub>x</sub> O <sub>y</sub> ( x > 0 、 y > 0 ) ) 等を含む膜を、単層で、又は積層させることで、ゲート絶縁膜を形成しても良い。

【 0 2 6 0 】

なお、本明細書において酸化窒化物とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多い物質であり、また、窒化酸化物とは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多い物質を意味する。

## 【0261】

ゲート電極105n及びゲート電極105pは、ゲート絶縁膜104n及びゲート絶縁膜104pを覆うように導電膜を形成した後、該導電膜を所定の形状に加工（パターニング）することで、形成することができる。上記導電膜の形成にはCVD法、スパッタ法、蒸着法、スピンコート法等を用いることができる。また、導電膜は、タンタル（Ta）、タングステン（W）、チタン（Ti）、モリブデン（Mo）、アルミニウム（Al）、銅（Cu）、クロム（Cr）、ニオブ（Nb）等を用いることができる。上記金属を主成分とする合金を用いても良いし、上記金属を含む化合物を用いても良い。又は、半導体膜に導電性を付与するリン等の不純物元素をドーピングした、多結晶シリコンなどの半導体を用いて形成しても良い。

10

## 【0262】

なお、ゲート電極105n及びゲート電極105pは、単層の導電膜で構成されていても良いし、積層された複数の導電膜で構成されていても良い。

## 【0263】

2つの導電膜の組み合わせとして、1層目に窒化タンタル又はタンタルを、2層目にタングステンを用いることができる。上記例の他に、窒化タングステンとタングステン、窒化モリブデンとモリブデン、アルミニウムとタンタル、アルミニウムとチタン等が挙げられる。タングステンや窒化タンタルは、耐熱性が高いため、2層の導電膜を形成した後の工程において、熱活性化を目的とした加熱処理を行うことができる。また、2層の導電膜の組み合わせとして、例えば、n型の導電性を付与する不純物元素がドーピングされたシリコンとニッケルシリサイド、n型の導電性を付与する不純物元素がドーピングされたシリコンとタングステンシリサイド等も用いることができる。

20

## 【0264】

3つの導電膜を積層する3層構造の場合は、モリブデン膜とアルミニウム膜とモリブデン膜の積層構造を採用するとよい。

## 【0265】

また、ゲート電極105n及びゲート電極105pに酸化インジウム、酸化インジウム酸化スズ混合物、酸化インジウム酸化亜鉛混合物、酸化亜鉛、酸化亜鉛アルミニウム、酸化亜鉛アルミニウム、又は酸化亜鉛ガリウム等の透光性を有する酸化物導電膜を用いることもできる。

30

## 【0266】

本実施の形態では、膜厚30nm程度の窒化タンタル上に、膜厚170nm程度のタングステンを積層したゲート電極105n及びゲート電極105pを用いる。

## 【0267】

なお、マスクを用いずに、液滴吐出法を用いて選択的にゲート電極105n及びゲート電極105pを形成しても良い。液滴吐出法とは、所定の組成物を含む液滴を細孔から吐出又は噴出することで所定のパターンを形成する方法を意味し、インクジェット法などがその範疇に含まれる。

## 【0268】

また、ゲート電極105n及びゲート電極105pは、導電膜を形成後、ICP（Inductively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法を用い、エッチング条件（コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電力量、基板側の電極温度等）を適宜調節することにより、所望のテーパー形状を有するようにエッチングすることができる。また、テーパー形状は、マスクの形状によっても角度等を制御することができる。なお、エッチング用ガスとしては、塩素、塩化硼素、塩化シリコンもしくは四塩化炭素などの塩素系ガス、四弗化炭素、弗化硫黄もしくは弗化酸素などのフッ素系ガス又は酸素を適宜用いることができる。

40

## 【0269】

次いで、ゲート絶縁膜104n及びゲート絶縁膜104pと、ゲート電極105n及びゲート電極105pとを覆うように絶縁膜を形成した後、エッチング等により、上記絶縁膜

50

の形状を加工することで、図8(C)に示すように、サイドウォール170nをゲート電極105nの側部に、サイドウォール170pをゲート電極105pの側部に、それぞれ形成する。本実施の形態では、膜厚100nmの酸化窒化シリコン膜と、膜厚200nmの酸化シリコン膜とが順に積層された絶縁膜を、ゲート電極105n及びゲート電極105pを覆うように形成した後、ドライエッチングによりその形状を加工することで、サイドウォール170n及びサイドウォール170pを形成する。

#### 【0270】

なお、上記エッチングにより、ゲート絶縁膜104nのうち、サイドウォール170nの下部以外の部分が除去され、また、ゲート絶縁膜104pのうち、サイドウォール170pの下部以外の部分が除去される。

10

#### 【0271】

次に、図8(D)に示すように、ゲート電極105n及びゲート電極105pと、サイドウォール170n及びサイドウォール170pとをマスクとして、一導電性を付与する不純物元素を半導体膜103n及び半導体膜103pに添加する。具体的には、まず、半導体膜103nを覆うようにマスクを形成した後、半導体膜103pに、p型の導電性を付与する不純物元素を添加する。上記不純物元素の添加により、半導体膜103pにおいて、一部の低濃度不純物領域117a及び低濃度不純物領域118aにさらに不純物が添加され、ゲート電極105pと重なる第1の領域114と、サイドウォール170pと重なり、なおかつ第1の領域114を間に挟む第3の領域117及び第3の領域118と、第1の領域114、第3の領域117及び第3の領域118を間に挟む第2の領域115及び第2の領域116とが形成される。次いで、半導体膜103pを覆うようにマスクを形成した後、半導体膜103nに、n型の導電性を付与する不純物元素を添加する。上記不純物元素の添加により、半導体膜103nにおいて、一部の低濃度不純物領域111a及び低濃度不純物領域112aにさらに不純物が添加され、ゲート電極105nと重なる第1の領域108と、サイドウォール170nと重なり、なおかつ第1の領域108を間に挟む第3の領域111及び第3の領域112と、第1の領域108、第3の領域111及び第3の領域112を間に挟む第2の領域109及び第2の領域110とが形成される。

20

#### 【0272】

第3の領域117及び第3の領域118は、サイドウォール170pと重なっていることにより、第2の領域115及び第2の領域116よりも、p型の導電性を付与する不純物元素の濃度が低い。また、第3の領域111及び第3の領域112は、サイドウォール170nと重なっていることにより、第2の領域109及び第2の領域110よりも、n型の導電性を付与する不純物元素の濃度が低い。

30

#### 【0273】

なお、本実施の形態では、1回目の不純物の添加により低濃度不純物領域111a及び低濃度不純物領域112aと、低濃度不純物領域117a及び低濃度不純物領域118aとを形成してから、2回目の不純物の添加を行うことでLDD領域として機能する第3の領域111及び第3の領域112と、第3の領域117及び第3の領域118とを形成しているが、本発明の一態様はこの構成に限定されない。例えば、上記1回目の不純物の添加を行わずに、2回目の不純物の添加を、サイドウォール170n及びサイドウォール170pの下部に不純物が回り込むような条件で行うことで、LDD領域として機能する第3の領域111及び第3の領域112と、第3の領域117及び第3の領域118とを形成することも可能である。また、上記1回目の不純物の添加を行わず、なおかつ2回目の不純物の添加を、サイドウォール170n及びサイドウォール170pの下部に不純物が入りにくい条件で行うことで、第1の領域108と第2の領域109及び第2の領域110との間に、または、第1の領域114と第2の領域115及び第2の領域116との間に、オフセット領域を設けても良い。オフセット領域における不純物濃度は、第1の領域108または第1の領域114と同程度であることが望ましい。

40

#### 【0274】

次いで、図8(E)に示すように、半導体膜103n及び半導体膜103pと、ゲート電

50

極 105 n 及びゲート電極 105 p と、サイドウォール 170 p 及びサイドウォール 170 n と、絶縁膜 101 とを覆うように、絶縁膜 119 を形成する。

【0275】

具体的に、絶縁膜 119 は、酸化シリコン、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウムなどの無機の絶縁膜を用いることができる。特に、誘電率の低い (low - k) 材料を絶縁膜 119 に用いることで、各種電極や配線の重なり起因する容量を十分に低減することが可能になるため好ましい。なお、絶縁膜 119 に、上記材料を用いた多孔性の絶縁膜を適用しても良い。多孔性の絶縁膜では、密度の高い絶縁膜と比較して誘電率が低下するため、電極や配線に起因する寄生容量を更に低減することが可能である。

10

【0276】

また、絶縁膜 119 として、有機シランを用いて化学気相成長法により作製される酸化シリコン膜を用いることもできる。有機シランとしては、珪酸エチル ( $\text{TEOS} : \text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ )、トリメチルシラン ( $\text{TMS} : (\text{CH}_3)_3\text{SiH}$ )、テトラメチルシクロテトラシロキサン ( $\text{TMCTS}$ )、オクタメチルシクロテトラシロキサン ( $\text{OMCTS}$ )、ヘキサメチルジシラザン ( $\text{HMDS}$ )、トリエトキシシラン ( $\text{SiH}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ )、トリスジメチルアミノシラン ( $\text{SiH}(\text{N}(\text{CH}_3)_2)_3$ ) 等を用いることができる。もちろん、モノシラン、ジシラン、又はトリシラン等の無機シランを用いて、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン、窒化酸化シリコンなどを形成しても良い。

【0277】

20

本実施の形態では、絶縁膜 119 として膜厚 500 nm の酸化窒化シリコン膜を用いる。なお、本実施の形態では、絶縁膜 119 が単層の絶縁膜で構成されている場合を例示しているが、絶縁膜 119 は、積層された複数の絶縁膜で構成されていても良い。

【0278】

次いで、絶縁膜 119 の表面を表面に平坦化処理を施した後、図 9 (A) に示すように、絶縁膜 119 上に絶縁膜 173 と、酸化物半導体膜 142 b とを、順に積層するように形成する。

【0279】

なお、後に形成されるトランジスタ 121 の、電気的特性のばらつきを抑えるためには、酸化物半導体膜 142 b の表面は高い平坦性を有していることが望ましい。そして、酸化物半導体膜 142 b の平坦性を高めるためには、絶縁膜 173 の表面が高い平坦性が確保していることが望ましい。しかし、絶縁膜 173 と酸化物半導体膜 142 b の界面近傍に水素などの不純物が混入するのを防ぐためには、絶縁膜 173 を形成した後、絶縁膜 173 を大気にさらすことなく、連続的に酸化物半導体膜 142 b を形成することが望ましい。よって、本実施の形態のように、絶縁膜 173 の下に位置する絶縁膜 119 の表面に平坦化処理を施しておくことにより、絶縁膜 173 の表面に平坦化処理を施さなくとも、絶縁膜 173 の表面の平坦性を確保することができる。そして、絶縁膜 173 の表面の平坦性を確保しつつ、絶縁膜 173 と酸化物半導体膜 142 b の連続成膜を実現することができる。

30

【0280】

40

絶縁膜 119 の平坦化処理は、化学的機械研磨法 (Chemical Mechanical Polishing : CMP 法)、液体ジェット研磨法等の研磨処理、ドライエッチング又はウェットエッチング等のエッチング処理、または研磨処理とエッチング処理を組み合わせで行うことができる。

【0281】

本実施の形態では、CMP 法を用いて、絶縁膜 119 に平坦化処理を施す場合について説明する。絶縁膜 119 の平坦化処理は、例えば、ポリウレタン地の研磨布を用い、スラリーはシリカ系スラリー (粒径 60 nm)、スラリー流量 100 ml/min 以上 500 ml/min 以下、研磨圧 0.005 MPa 以上 0.08 MPa 以下、スピンドル回転数 20 rpm 以上 50 rpm 以下、テーブル回転数 20 rpm 以上 50 rpm 以下で行うこと

50

ができる。

【0282】

本実施の形態では、上記CMP法による研磨後の絶縁膜119の膜厚を、300nmとする。

【0283】

また、絶縁膜173は、スパッタ法、CVD法等により形成する。絶縁膜173は、熱が与えられることにより酸素が脱離する絶縁膜であることが好ましい。熱が与えられることにより酸素が脱離する絶縁膜としては、化学量論的組成比を満たす酸素よりも多くの酸素を含む絶縁膜を用いることが好ましい。熱が与えられることにより酸素が脱離する絶縁膜は、加熱処理の際に、酸素が脱離することにより、後に形成される酸化物半導体膜に酸素を拡散（又は供給）させることができる。絶縁膜173として、例えば、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム等を用いることができる。スパッタ法を用いて絶縁膜173を形成することにより、熱が与えられることにより酸素が脱離しやすい絶縁膜とすることができるため、好ましい。絶縁膜173は、単数の絶縁膜で構成されていても良いし、積層された複数の絶縁膜で構成されていても良い。

10

【0284】

絶縁膜173は、50nm以上800nm以下、好ましくは200nm以上500nm以下とする。絶縁膜173を厚く形成することで、絶縁膜173から放出される酸素の量を増加させることができると共に、絶縁膜173及び後に形成される酸化物半導体膜142bとの界面における界面準位を低減することが可能である。

20

【0285】

本実施の形態では、スパッタ法を用いて形成した、膜厚200nmの酸化シリコン膜を、絶縁膜173として用いる。絶縁膜173をスパッタ法により形成する場合は、成膜ガスとして、酸素ガス、又は酸素及び希ガスの混合ガス等を用いることができる。また、成膜ガス中の酸素量を高くすることにより、絶縁膜173に含まれる酸素の量を増加させることができるため、好ましい。代表的には、成膜ガス中の酸素濃度を6%以上100%以下にするとよい。

【0286】

絶縁膜173として、酸化シリコン膜を形成する場合、石英（好ましくは合成石英）をターゲットに用い、基板温度30℃以上450℃以下（好ましくは70℃以上200℃以下）、ターゲットと基板の間の距離（T-S間距離）を20mm以上400mm以下（好ましくは40mm以上200mm以下）、圧力を0.1Pa以上4Pa以下（好ましくは0.2Pa以上1.2Pa以下）、高周波電源を0.5kW以上12kW以下（好ましくは1kW以上5kW以下）、成膜ガス中の $O_2 / (O_2 + Ar)$ 割合を1%以上100%以下（好ましくは6%以上100%以下）として、RFスパッタ法を用いることが好ましい。なお、石英（好ましくは合成石英）ターゲットに代えてシリコンターゲットを用いることもできる。なお、成膜ガスとしては、酸素のみを用いてもよい。

30

【0287】

上記酸化物半導体膜142bの膜厚は、2nm以上200nm以下、好ましくは3nm以上50nm以下、更に好ましくは3nm以上20nm以下とする。酸化物半導体膜は、酸化物半導体をターゲットとして用い、スパッタ法により成膜する。また、酸化物半導体膜は、希ガス（例えばアルゴン）雰囲気下、酸素雰囲気下、又は希ガス（例えばアルゴン）及び酸素混合雰囲気下においてスパッタ法により形成することができる。

40

【0288】

なお、酸化物半導体膜をスパッタ法により成膜する前に、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパッタを行い、絶縁膜173の表面に付着している塵埃を除去することが好ましい。逆スパッタとは、ターゲット側に電圧を印加せずに、アルゴン雰囲気下で基板側にRF電源を用いて電圧を印加して基板近傍にプラズマを形成して表面を改質する方法である。なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウムなどを用いてもよい。また、

50

アルゴン雰囲気中に酸素、亜酸化窒素などを加えた雰囲気で行ってもよい。また、アルゴン雰囲気中に塩素、四フッ化炭素などを加えた雰囲気で行ってもよい。

【0289】

酸化物半導体膜には、上述したような材料を用いることができる。本実施の形態では、In（インジウム）、Ga（ガリウム）、及びZn（亜鉛）を含むターゲットを用いたスパッタ法により得られる膜厚20nmのIn-Ga-Zn系酸化物半導体の薄膜を、酸化物半導体膜として用いる。上記ターゲットとして、例えば、 $\text{In}_2\text{O}_3 : \text{Ga}_2\text{O}_3 : \text{ZnO} = 1 : 1 : 1$  [mol数比]の組成比を有するターゲットを用いる。また、 $\text{In}_2\text{O}_3 : \text{Ga}_2\text{O}_3 : \text{ZnO} = 1 : 1 : 2$  [mol数比]の組成比を有するターゲット、または $\text{In}_2\text{O}_3 : \text{Ga}_2\text{O}_3 : \text{ZnO} = 1 : 1 : 4$  [mol数比]を有するターゲットを用いることができる。また、In、Ga、及びZnを含むターゲットの充填率は90%以上100%以下、好ましくは95%以上100%未満である。充填率の高いターゲットを用いることにより、成膜した酸化物半導体膜は緻密な膜となる。

10

【0290】

なお、酸化物半導体としてIn-Zn系酸化物半導体の材料を用いる場合、用いるターゲットの組成比は、原子数比で、 $\text{In} : \text{Zn} = 50 : 1 \sim 1 : 2$ （モル数比に換算すると $\text{In}_2\text{O}_3 : \text{ZnO} = 25 : 1 \sim 1 : 4$ ）、好ましくは $\text{In} : \text{Zn} = 20 : 1 \sim 1 : 1$ （モル数比に換算すると $\text{In}_2\text{O}_3 : \text{ZnO} = 10 : 1 \sim 1 : 2$ ）、さらに好ましくは $\text{In} : \text{Zn} = 1.5 : 1 \sim 15 : 1$ （モル数比に換算すると $\text{In}_2\text{O}_3 : \text{ZnO} = 3 : 4 \sim 15 : 2$ ）とする。例えば、In-Zn系酸化物半導体の形成に用いるターゲットは、原子数比が $\text{In} : \text{Zn} : \text{O} = X : Y : Z$ のとき、 $Z > 1.5X + Y$ とする。Znの比率を上記範囲に収めることで、移動度の向上を実現することができる。

20

【0291】

また、酸化物半導体としてIn-Sn-Zn系酸化物半導体の材料を用いる場合、用いるターゲットの組成比は、 $\text{In} : \text{Sn} : \text{Zn}$ の原子数比を、1 : 2 : 2、2 : 1 : 3、1 : 1 : 1、または4 : 9 : 7とすれば良い。

【0292】

本実施の形態では、減圧状態に保持された処理室内に基板を保持し、処理室内の残留水分を除去しつつ水素及び水分が除去されたスパッタガスを導入し、上記ターゲットを用いて酸化物半導体膜を成膜する。成膜時に、基板温度を100℃以上600℃以下、好ましくは200℃以上400℃以下としても良い。基板を加熱しながら成膜することにより、成膜した酸化物半導体膜に含まれる不純物濃度を低減することができる。また、スパッタによる損傷が軽減される。処理室内の残留水分を除去するためには、吸着型の真空ポンプを用いることが好ましい。例えば、クライオポンプ、イオンポンプ、チタンサブリメーションポンプを用いることが好ましい。また、排気手段としては、ターボポンプにコールドトラップを加えたものであってもよい。クライオポンプを用いて処理室を排気すると、例えば、水素原子、水（ $\text{H}_2\text{O}$ ）など水素原子を含む化合物（より好ましくは炭素原子を含む化合物も）等が排気されるため、当該処理室で成膜した酸化物半導体膜に含まれる不純物の濃度を低減できる。

30

【0293】

成膜条件の一例としては、基板とターゲットの間との距離を100mm、圧力0.4Pa、直流（DC）電源0.5kW、アルゴンと酸素の流量比が30sccm/15sccm雰囲気下の条件が適用される。なお、パルス直流（DC）電源を用いると、成膜時に発生する塵埃が軽減でき、膜厚分布も均一となるために好ましい。

40

【0294】

また、スパッタ装置の処理室のリークレートを $1 \times 10^{-10} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{秒}$ 以下とすることで、スパッタ法による成膜途中における酸化物半導体膜への、アルカリ金属、水素化物等の不純物の混入を低減することができる。また、排気系として上述した吸着型の真空ポンプを用いることで、排気系からのアルカリ金属、水素原子、水素分子、水、水酸基、または水素化物等の不純物の逆流を低減することができる。

50

## 【0295】

また、ターゲットの純度を、99.99%以上とすることで、酸化物半導体膜に混入するアルカリ金属、水素原子、水素分子、水、水酸基、または水素化物等を低減することができる。また、当該ターゲットを用いることで、酸化物半導体膜において、リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属の濃度を低減することができる。

## 【0296】

なお、酸化物半導体膜に水素、水酸基及び水分がなるべく含まれないようにするために、成膜の前処理として、スパッタ装置の予備加熱室で絶縁膜173までが形成された基板100を予備加熱し、基板100上に形成された各種絶縁膜及び導電膜に吸着した水分又は水素などの不純物を、脱離し排気することが好ましい。なお、予備加熱の温度は、100  
10 以上400 以下、好ましくは150 以上300 以下である。また、予備加熱室に設ける排気手段はクライオポンプが好ましい。なお、この予備加熱の処理は省略することもできる。また、この予備加熱は、後に行われる絶縁膜143aの形成前にも同様に行ってもよい。

## 【0297】

なお、スパッタ等で成膜された酸化物半導体膜中には、不純物としての水分又は水素（水酸基を含む）が多量に含まれていることがある。水分又は水素はドナー準位を形成しやすいため、酸化物半導体にとっては不純物である。そこで、本発明の一態様では、酸化物半導体膜142b中の水分又は水素などの不純物を低減（脱水化または脱水素化）するために、酸化物半導体膜142bに対して、減圧雰囲気下、窒素や希ガスなどの不活性ガス雰  
20 囲気下、酸素ガス雰囲気下、又は超乾燥エア（CRDS（キャビティリングダウンレーザー分光法）方式の露点計を用いて測定した場合の水分量が20ppm（露点換算で-55）以下、好ましくは1ppm以下、好ましくは10ppb以下の空気）雰囲気下で、酸化物半導体膜142bに加熱処理を施す。

## 【0298】

酸化物半導体膜142bに加熱処理を施すことで、酸化物半導体膜142b中の水分又は水素を脱離させることができる。具体的には、250 以上750 以下、好ましくは400 以上基板の歪み点未満の温度で加熱処理を行えば良い。例えば、500 、3分間以上6分間以下程度で行えばよい。加熱処理にRTA法を用いれば、短時間に脱水化又は脱水素化が行えるため、ガラス基板の歪点を超える温度でも処理することができる。  
30

## 【0299】

本実施の形態では、加熱処理装置の一つである電気炉を用いる。

## 【0300】

なお、加熱処理装置は電気炉に限られず、抵抗発熱体などの発熱体からの熱伝導又は熱輻射によって、被処理物を加熱する装置を備えていてもよい。例えば、GRTA（Gas Rapid Thermal Anneal）装置、LRTA（Lamp Rapid Thermal Anneal）装置等のRTA（Rapid Thermal Anneal）装置を用いることができる。LRTA装置は、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧水銀ランプなどのランプから発する光（電磁波）の輻射により、被処理物を加熱する装置で  
40 ある。GRTA装置は、高温のガスを用いて加熱処理を行う装置である。気体には、アルゴンなどの希ガス、又は窒素のような、加熱処理によって被処理物と反応しない不活性気体が用いられる。

## 【0301】

加熱処理においては、窒素、又はヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスに、水分又は水素などが含まれないことが好ましい。又は、加熱処理装置に導入する窒素、又はヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの純度を、6N（99.9999%）以上、好ましくは7N（99.99999%）以上、（即ち不純物濃度を1ppm以下、好ましくは0.1ppm以下）とすることが好ましい。

## 【0302】

10

20

30

40

50

なお、酸化物半導体は不純物に対して鈍感であり、膜中にはかなりの金属不純物が含まれていても問題がなく、ナトリウムのようなアルカリ金属が多量に含まれる廉価なソーダ石灰ガラスも使えると指摘されている（神谷、野村、細野、「アモルファス酸化物半導体の物性とデバイス開発の現状」、固体物理、2009年9月号、Vol. 44、pp. 621 - 633.）。しかし、このような指摘は適切でない。アルカリ金属は酸化物半導体を構成する元素ではないため、不純物である。アルカリ土類金属も、酸化物半導体を構成する元素ではない場合において、不純物となる。特に、アルカリ金属のうちNaは、酸化物半導体膜に接する絶縁膜が酸化物である場合、当該絶縁膜中に拡散して $\text{Na}^+$ となる。また、Naは、酸化物半導体膜内において、酸化物半導体を構成する金属と酸素の結合を分断する、或いは、その結合中に割り込む。その結果、例えば、閾値電圧がマイナス方向にシフトすることによるノーマリオン化、移動度の低下等の、トランジスタの電気的特性の劣化が起こり、加えて、電気的特性のばらつきも生じる。この不純物によりもたらされるトランジスタの電気的特性の劣化と、電気的特性のばらつきは、酸化物半導体膜中の水素濃度が十分に低い場合において顕著に現れる。従って、酸化物半導体膜中の水素濃度が $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ 以下、より好ましくは $1 \times 10^{17} / \text{cm}^3$ 以下である場合には、上記不純物の濃度を低減することが望ましい。具体的に、二次イオン質量分析法によるNa濃度の測定値は、 $5 \times 10^{16} / \text{cm}^3$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{16} / \text{cm}^3$ 以下、更に好ましくは $1 \times 10^{15} / \text{cm}^3$ 以下とするとよい。同様に、Li濃度の測定値は、 $5 \times 10^{15} / \text{cm}^3$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{15} / \text{cm}^3$ 以下とするとよい。同様に、K濃度の測定値は、 $5 \times 10^{15} / \text{cm}^3$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{15} / \text{cm}^3$ 以下とするとよい。

#### 【0303】

以上の工程により、酸化物半導体膜142b中の水素の濃度を低減することができる。また、当該水素濃度が低減された酸化物半導体膜を用いることで、耐圧性が高く、オフ電流の著しく小さいトランジスタを作製することができる。上記加熱処理は、酸化物半導体膜142bの成膜以降であれば、いつでも行うことができる。

#### 【0304】

なお、酸化物半導体膜142bは非晶質であっても良いが、結晶性を有していても良い。結晶性を有する酸化物半導体膜としては、c軸配向し、かつab面、表面または界面の方向から見て三角形または六角形状の原子配列を有し、c軸においては金属原子が層状または金属原子と酸素原子とが層状に配列しており、ab面においてはa軸またはb軸の向きが異なる（c軸を中心に回転した）結晶を含む結晶性酸化物半導体（C Axis Aligned Crystalline Oxide Semiconductor: CAAC-OSとも呼ぶ）であっても、トランジスタの信頼性を高めるという効果を得ることができるので、好ましい。

#### 【0305】

CAAC-OSで構成された酸化物半導体膜は、スパッタ法によっても作製することができる。スパッタ法によってCAAC-OSを得るには酸化物半導体膜の堆積初期段階において六方晶の結晶が形成されるようにすることと、当該結晶を種として結晶が成長されるようにすることが肝要である。そのためには、ターゲットと基板の距離を広くとり（例えば、150mm～200mm程度）、基板加熱温度を100～500、好適には200～400、さらに好適には250～300にすると好ましい。また、これに加えて、成膜時の基板加熱温度よりも高い温度で、堆積された酸化物半導体膜を熱処理することで膜中に含まれるミクロな欠陥や、積層界面の欠陥を修復することができる。

#### 【0306】

具体的に、CAAC-OSは、非単結晶であって、そのab面に垂直な方向から見て、三角形、六角形、正三角形、または正六角形の原子配列を有する。なおかつ、CAAC-OSは、c軸方向に垂直な方向から見て、金属原子が層状に配列した相、または、金属原子と酸素原子が層状に配列した相を含む。

#### 【0307】

C A A C - O S は単結晶ではないが、非晶質のみから形成されているものでもない。また、C A A C - O S は結晶化した部分（結晶部分）を含むが、結晶部分どうしの境界を明確に判別できないこともある。

【 0 3 0 8 】

C A A C - O S を構成する酸素の一部は窒素で置換されてもよい。また、C A A C - O S を構成する個々の結晶部分の c 軸は一定の方向（例えば、C A A C - O S が形成される基板面、C A A C - O S の表面などに垂直な方向）に揃っていてもよい。または、C A A C - O S を構成する個々の結晶部分の a b 面の法線は一定の方向（例えば、C A A C - O S が形成される基板面、C A A C - O S の表面などに垂直な方向）を向いていてもよい。

【 0 3 0 9 】

C A A C - O S は、その組成などに応じて、導体であったり、半導体であったり、絶縁体であったりする。また、その組成などに応じて、可視光に対して透明であったり不透明であったりする。

【 0 3 1 0 】

このような C A A C - O S の例として、膜状に形成され、膜表面または支持する基板面に垂直な方向から観察すると三角形または六角形の原子配列が認められ、かつその膜断面を観察すると金属原子または金属原子および酸素原子（または窒素原子）の層状配列が認められる結晶を挙げることができる。

【 0 3 1 1 】

C A A C - O S に含まれる結晶構造の一例について図 1 8 乃至図 2 0 を用いて詳細に説明する。なお、特に断りがない限り、図 1 8 乃至図 2 0 は上方向を c 軸方向とし、c 軸方向と直交する面を a b 面とする。なお、単に上半分、下半分という場合、a b 面を境にした場合の上半分、下半分をいう。また、図 1 8 において丸で囲まれた O は 4 配位の O を示し、二重丸で囲まれた O は 3 配位の O を示す。

【 0 3 1 2 】

図 1 8 ( A ) に、1 個の 6 配位の I n と、I n に近接の 6 個の 4 配位の酸素原子（以下 4 配位の O ）と、を有する構造を示す。ここでは、金属原子が 1 個に対して、近接の酸素原子のみ示した構造を小グループと呼ぶ。図 1 8 ( A ) の構造は、八面体構造をとるが、簡単のため平面構造で示している。なお、図 1 8 ( A ) の上半分および下半分にはそれぞれ 3 個ずつ 4 配位の O がある。図 1 8 ( A ) に示す小グループは電荷が 0 である。

【 0 3 1 3 】

図 1 8 ( B ) に、1 個の 5 配位の G a と、G a に近接の 3 個の 3 配位の酸素原子（以下 3 配位の O ）と、G a に近接の 2 個の 4 配位の O と、を有する構造を示す。3 配位の O は、いずれも a b 面に存在する。図 1 8 ( B ) の上半分および下半分にはそれぞれ 1 個ずつ 4 配位の O がある。また、I n も 5 配位をとるため、図 1 8 ( B ) に示す構造をとりうる。図 1 8 ( B ) に示す小グループは電荷が 0 である。

【 0 3 1 4 】

図 1 8 ( C ) に、1 個の 4 配位の Z n と、Z n に近接の 4 個の 4 配位の O と、による構造を示す。図 1 8 ( C ) の上半分には 1 個の 4 配位の O があり、下半分には 3 個の 4 配位の O がある。または、図 1 8 ( C ) の上半分に 3 個の 4 配位の O があり、下半分に 1 個の 4 配位の O があってもよい。図 1 8 ( C ) に示す小グループは電荷が 0 である。

【 0 3 1 5 】

図 1 8 ( D ) に、1 個の 6 配位の S n と、S n に近接の 6 個の 4 配位の O と、を有する構造を示す。図 1 8 ( D ) の上半分には 3 個の 4 配位の O があり、下半分には 3 個の 4 配位の O がある。図 1 8 ( D ) に示す小グループは電荷が + 1 となる。

【 0 3 1 6 】

図 1 8 ( E ) に、2 個の Z n を含む小グループを示す。図 1 8 ( E ) の上半分には 1 個の 4 配位の O があり、下半分には 1 個の 4 配位の O がある。図 1 8 ( E ) に示す小グループは電荷が - 1 となる。

【 0 3 1 7 】

なお、複数の小グループ集合体を中グループと呼び、複数の中グループの集合体を大グループ（ユニットセルともいう。）と呼ぶ。

#### 【0318】

ここで、これらの小グループ同士が結合する規則について説明する。図18(A)に示す6配位の $I_n$ の上半分の3個のOは、下方向にそれぞれ3個の近接 $I_n$ を有し、下半分の3個のOは、上方向にそれぞれ3個の近接 $I_n$ を有する。図18(B)に示す5配位の $G_a$ の上半分の1個のOは下方向に1個の近接 $G_a$ を有し、下半分の1個のOは上方向に1個の近接 $G_a$ を有する。図18(C)に示す4配位の $Z_n$ の上半分の1個のOは、下方向に1個の近接 $Z_n$ を有し、下半分の3個のOは、上方向にそれぞれ3個の近接 $Z_n$ を有する。この様に、金属原子の上方向の4配位のOの数と、そのOの下方向にある近接金属原子の数は等しく、同様に金属原子の下方向の4配位のOの数と、そのOの上方向にある近接金属原子の数は等しい。Oは4配位なので、下方向にある近接金属原子の数と、上方向にある近接金属原子の数の和は4になる。従って、金属原子の上方向にある4配位のOの数と、別の金属原子の下方向にある4配位のOの数との和が4個のとき、金属原子を有する二種の小グループ同士は結合することができる。例えば、6配位の金属原子( $I_n$ または $S_n$ )が下半分の4配位のOを介して結合する場合、4配位のOが3個であるため、5配位の金属原子( $G_a$ または $I_n$ )、4配位の金属原子( $Z_n$ )のいずれかと結合することになる。

10

#### 【0319】

これらの配位数を有する金属原子は、c軸方向において、4配位のOを介して結合する。また、このほかにも、層構造の合計の電荷が0となるように複数の小グループが結合して中グループを構成する。

20

#### 【0320】

図19(A)に、 $I_n - S_n - Z_n$ 系酸化物半導体の層構造を構成する中グループのモデル図を示す。図19(B)に、3つの中グループで構成される大グループを示す。なお、図19(C)は、図19(B)の層構造をc軸方向から観察した場合の原子配列を示す。

#### 【0321】

図19(A)においては、簡単のため、3配位のOは省略し、4配位のOは個数のみ示し、例えば、 $S_n$ 原子の上半分および下半分にはそれぞれ3個ずつ4配位のOがあることを丸枠の3として示している。同様に、図19(A)において、 $I_n$ の上半分および下半分にはそれぞれ1個ずつ4配位のOがあり、丸枠の1として示している。また、同様に、図19(A)において、下半分には1個の4配位のOがあり、上半分には3個の4配位のOがある $Z_n$ と、上半分には1個の4配位のOがあり、下半分には3個の4配位のOがある $Z_n$ とを示している。

30

#### 【0322】

図19(A)において、 $I_n - S_n - Z_n$ 系酸化物半導体の層構造を構成する中グループは、上から順に4配位のOが3個ずつ上半分および下半分にある $S_n$ が、4配位のOが1個ずつ上半分および下半分にある $I_n$ と結合し、その $I_n$ が、上半分に3個の4配位のOがある $Z_n$ と結合し、その $Z_n$ の下半分の1個の4配位のOを介して4配位のOが3個ずつ上半分および下半分にある $I_n$ と結合し、その $I_n$ が、上半分に1個の4配位のOがある $Z_n$ 2個からなる小グループと結合し、この小グループの下半分の1個の4配位のOを介して4配位のOが3個ずつ上半分および下半分にある $S_n$ と結合している構成である。この中グループが複数結合して大グループを構成する。

40

#### 【0323】

ここで、3配位のOおよび4配位のOの場合、結合1本当当たりの電荷はそれぞれ-0.667、-0.5と考えることができる。例えば、 $I_n$ (6配位または5配位)、 $Z_n$ (4配位)、 $S_n$ (5配位または6配位)の電荷は、それぞれ+3、+2、+4である。従って、 $S_n$ を含む小グループは電荷が+1となる。そのため、 $S_n$ を含む層構造を形成するためには、電荷+1を打ち消す電荷-1が必要となる。電荷-1をとる構造として、図18(E)に示すように、2個の $Z_n$ を含む小グループが挙げられる。例えば、 $S_n$ を含む

50

小グループが1個に対し、2個のZnを含む小グループが1個あれば、電荷が打ち消されるため、層構造の合計の電荷を0とすることができる。

【0324】

具体的には、図19(B)に示した大グループが繰り返されることで、In-Sn-Zn系酸化物半導体の結晶( $\text{In}_2\text{SnZn}_3\text{O}_8$ )を得ることができる。なお、得られるIn-Sn-Zn系酸化物半導体の層構造は、 $\text{In}_2\text{SnZn}_2\text{O}_7(\text{ZnO})_m$ (mは0または自然数。)とする組成式で表すことができる。

【0325】

また、このほかにも、四元系金属の酸化物であるIn-Sn-Ga-Zn-O系酸化物や、三元系金属の酸化物であるIn-Ga-Zn-O系酸化物(IGZOとも表記する。)、In-Al-Zn-O系酸化物、Sn-Ga-Zn-O系酸化物、Al-Ga-Zn-O系酸化物、Sn-Al-Zn-O系酸化物や、In-Hf-Zn-O系酸化物、In-La-Zn-O系酸化物、In-Ce-Zn-O系酸化物、In-Pr-Zn-O系酸化物、In-Nd-Zn-O系酸化物、In-Sm-Zn-O系酸化物、In-Eu-Zn-O系酸化物、In-Gd-Zn-O系酸化物、In-Tb-Zn-O系酸化物、In-Dy-Zn-O系酸化物、In-Ho-Zn-O系酸化物、In-Er-Zn-O系酸化物、In-Tm-Zn-O系酸化物、In-Yb-Zn-O系酸化物、In-Lu-Zn-O系酸化物や、二元系金属の酸化物であるIn-Zn-O系酸化物、Sn-Zn-O系酸化物、Al-Zn-O系酸化物、Zn-Mg-O系酸化物、Sn-Mg-O系酸化物、In-Mg-O系酸化物や、In-Ga-O系酸化物などを用いた場合も同様である。

【0326】

例えば、図20(A)に、In-Ga-Zn系酸化物半導体の層構造を構成する中グループのモデル図を示す。

【0327】

図20(A)において、In-Ga-Zn-O系酸化物半導体の層構造を構成する中グループは、上から順に4配位のOが3個ずつ上半分および下半分にあるInが、4配位のOが1個上半分にあるZnと結合し、そのZnの下半分の3個の4配位のOを介して、4配位のOが1個ずつ上半分および下半分にあるGaと結合し、そのGaの下半分の1個の4配位のOを介して、4配位のOが3個ずつ上半分および下半分にあるInと結合している構成である。この中グループが複数結合して大グループを構成する。

【0328】

図20(B)に3つの中グループで構成される大グループを示す。なお、図20(C)は、図20(B)の層構造をc軸方向から観察した場合の原子配列を示している。

【0329】

ここで、In(6配位または5配位)、Zn(4配位)、Ga(5配位)の電荷は、それぞれ+3、+2、+3であるため、In、ZnおよびGaのいずれかをを含む小グループは、電荷が0となる。そのため、これらの小グループの組み合わせであれば中グループの合計の電荷は常に0となる。

【0330】

また、In-Ga-Zn系酸化物半導体の層構造を構成する中グループは、図20(A)に示した中グループに限定されず、In、Ga、Znの配列が異なる中グループを組み合わせた大グループも取りうる。

【0331】

次いで、図9(B)に示すように、エッチング等により、酸化物半導体膜142bと、絶縁膜173の形状を加工することで、島状の酸化物半導体膜142と、後に形成される絶縁膜140の一部である第3の酸化絶縁膜140cが形成される。第3の酸化絶縁膜140cは、島状の酸化物半導体膜142と重なる領域以外が、部分的にエッチングされている。

【0332】

なお、酸化物半導体膜142を形成するためのエッチングは、ドライエッチングでもウェ

10

20

30

40

50

ットエッチングでもよく、両方を用いてもよい。ドライエッチングに用いるエッチングガスとしては、塩素を含むガス（塩素系ガス、例えば塩素（ $\text{Cl}_2$ ）、三塩化硼素（ $\text{BCl}_3$ ）、四塩化シリコン（ $\text{SiCl}_4$ ）、四塩化炭素（ $\text{CCl}_4$ ）など）が好ましい。また、フッ素を含むガス（フッ素系ガス、例えば四弗化炭素（ $\text{CF}_4$ ）、六弗化硫黄（ $\text{SF}_6$ ）、三弗化窒素（ $\text{NF}_3$ ）、トリフルオロメタン（ $\text{CHF}_3$ ）など）、臭化水素（ $\text{HBr}$ ）、酸素（ $\text{O}_2$ ）、これらのガスにヘリウム（ $\text{He}$ ）やアルゴン（ $\text{Ar}$ ）などの希ガスを添加したガス、などを用いることができる。

#### 【0333】

ドライエッチング法としては、平行平板型 RIE（Reactive Ion Etching）法や、ICP（Inductively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法を用いることができる。所望の形状にエッチングできるように、エッチング条件（コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電力量、基板側の電極温度等）を適宜調節する。

10

#### 【0334】

ウェットエッチングに用いるエッチング液として、燐酸と酢酸と硝酸を混ぜた溶液、クエン酸やシュウ酸などの有機酸を用いることができる。

#### 【0335】

酸化物半導体膜 142 を形成するためのレジストマスクをインクジェット法で形成してもよい。レジストマスクをインクジェット法で形成するとフォトマスクを使用しないため、製造コストを低減できる。

20

#### 【0336】

なお、次工程の導電膜を形成する前に逆スパッタを行い、酸化物半導体膜 142 b 及び絶縁膜 173 の表面に付着しているレジスト残渣などを除去することが好ましい。

#### 【0337】

本実施の形態では、酸化物半導体膜 142 b 及び絶縁膜 173 の形状の加工を、ドライエッチングで行う。例えば、ドライエッチングの条件として、例えば、 $\text{ICP} / \text{Bias} = 45 / 100 \text{ W}$ 、圧力  $1.9 \text{ Pa}$ 、エッチングガスは、 $\text{BCl}_3$  及び  $\text{Cl}_2$  の混合ガスとし、流量比は、 $\text{BCl}_3 / \text{Cl}_2 = 60 \text{ sccm} / 20 \text{ sccm}$  とする。このような条件を採用することにより、島状の酸化物半導体膜 142 を形成した後、絶縁膜 173 から第 3 の酸化絶縁膜 140 c を形成することができる。エッチングの際に、水素を含む不純物が含まれないように行うことが望ましい。

30

#### 【0338】

なお、酸化物半導体膜 142 をドライエッチングで形成する場合、酸化物半導体膜 142 の側面近傍、すなわち端部が、塩素ラジカル、フッ素ラジカル等を含むプラズマに曝されると、酸化物半導体膜 142 の端部に露出する金属原子と、塩素ラジカル、フッ素ラジカル等とが結合する。このとき、金属原子と塩素原子、フッ素原子が結合して脱離するため、酸化物半導体膜 142 中に当該金属原子と結合していた酸素原子が活性となる。活性となった酸素原子は容易に反応し、脱離しやすい。そのため、酸化物半導体膜 142 の端部には酸素欠損が生じやすい。

#### 【0339】

エッチング工程により露出された酸化物半導体膜の端部が活性であると、減圧雰囲気または還元雰囲気、更には減圧雰囲気での加熱処理において、酸素を引き抜かれ、該酸化物半導体膜の端部で酸素欠損を生じる。当該酸素欠損の一部はドナーとなり、キャリアである電子を生成するため、該酸化物半導体膜 142 の端部は n 型化する。

40

#### 【0340】

後に形成される導電膜 163 及び導電膜 164 が、n 型化した酸化物半導体膜 142 の端部と接する場合、当該端部を介して、導電膜 163 と導電膜 164 の間にリーク電流が発生してしまう。当該リーク電流は、トランジスタのオフ電流の上昇の原因となる。

#### 【0341】

次いで、図 9（C）に示すように、第 3 の酸化絶縁膜 140 c 及び酸化物半導体膜 142

50

上に、絶縁膜 174 及び絶縁膜 175 を形成する。絶縁膜 174 は、絶縁膜 173 と同様に、熱が与えられることにより酸素が脱離する絶縁膜を用いて形成することが好ましい。また、絶縁膜 175 は、酸素の拡散を防ぐ絶縁膜で形成する。絶縁膜 175 の一例として、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム等がある。

#### 【0342】

絶縁膜 174 及び絶縁膜 175 の成膜方法は、絶縁膜 173 と同様の成膜方法を適宜選択することができる。なお、絶縁膜 174 及び絶縁膜 175 を成膜する際に、酸化物半導体膜 142 の端部から酸素の脱離量を低減するため、絶縁膜 174 及び絶縁膜 175 の成膜温度は、可能な限り低い温度、好ましくは室温で成膜することが望ましい。

#### 【0343】

酸化物半導体膜 142 の端部に酸素欠損が生じたとしても、熱が与えられることにより酸素が脱離する絶縁膜 174 が酸化物半導体膜 142 の端部に接しており、なおかつ酸素の拡散を防ぐ絶縁膜 175 が絶縁膜 174 を間に挟んで酸化物半導体膜 142 の端部と重なっていることにより、後の加熱処理にて絶縁膜 174 から酸化物半導体膜 142 の端部に酸素を供給することができる。よって、酸化物半導体膜 142 の端部における酸素欠損を低減することができる。

#### 【0344】

本実施の形態では、絶縁膜 174 として膜厚 20 nm 程度の酸化シリコン膜を用い、絶縁膜 175 として膜厚 100 nm 程度の酸化アルミニウム膜を用いる。

#### 【0345】

次いで、図 9 (D) に示すように、絶縁膜 175 に平坦化処理を施すことにより、絶縁膜 175 から第 2 の酸化絶縁膜 140b を形成する。平坦化処理は、化学的機械研磨法 (Chemical Mechanical Polishing: CMP 法)、液体ジェット研磨法等の研磨処理、ドライエッチング又はウェットエッチング等のエッチング処理、または研磨処理とエッチング処理を組み合わせで行うことができる。本実施の形態では、CMP 法を用いて、絶縁膜 175 に平坦化処理を施す。絶縁膜 175 の平坦化処理は、絶縁膜 174 が露出するまで行う。なお、酸化物半導体膜 142 の膜厚が数 nm ~ 数十 nm と薄い場合、酸化物半導体膜 142 が、平坦化処理によって除去されないようにすることが望ましい。

#### 【0346】

絶縁膜 175 に CMP 法を施す条件は、例えば、ポリウレタン地の研磨布を用い、スラリーはシリカ系スラリー (粒径 60 nm)、スラリー流量 100 ml/min 以上 500 ml/min 以下、研磨圧 0.005 MPa 以上 0.08 MPa 以下、スピンドル回転数 20 rpm 以上 50 rpm 以下、テーブル回転数 20 rpm 以上 50 rpm 以下とする。

#### 【0347】

次いで、図 10 (A) に示すように、絶縁膜 174 の露出した箇所を除去して、酸化物半導体膜 142 の表面を露出させる。上記工程により、絶縁膜 174 から第 1 の酸化絶縁膜 140a を形成する。絶縁膜 174 の除去は、エッチング処理を用いて行う。但し、酸化物半導体膜 142 に対して絶縁膜 174 の選択比が高いエッチング条件を採用することが必要である。絶縁膜 174 の露出した箇所を除去した後、酸化物半導体膜 142 の表面を平坦にしておくことで、後に形成されるトランジスタ 121 の電気的特性を向上させることができる。

#### 【0348】

ドライエッチングの条件として、例えば、ICP/Bias = 500/50 W、圧力 1.5 Pa、エッチングガスは、CF<sub>4</sub> 及び O<sub>2</sub> の混合ガスとし、流量比は、CF<sub>4</sub>/O<sub>2</sub> = 70/30 sccm とする。このような条件を採用することにより、絶縁膜 174 を選択的に除去して第 1 の酸化絶縁膜 140a を形成することができる。また、酸化物半導体膜 142 が除去されてしまうことを抑制することができる。エッチングの際に、水素を含む不純物が含まれないように行うことが望ましい。

#### 【0349】

第1の酸化絶縁膜140aを形成した後、加熱処理を行ってもよい。加熱処理を行うことで、酸化物半導体膜142中の水素を含む不純物を除去することができる。また、第1の酸化絶縁膜140a、第3の酸化絶縁膜140cから酸素が脱離することにより、酸化物半導体膜142の端部と下部に酸素を供給することができ、酸素欠損を低減することができる。

#### 【0350】

次いで、図10(B)に示すように、第1の酸化絶縁膜140a、第2の酸化絶縁膜140b、及び酸化物半導体膜142を覆うように、絶縁膜143a、導電膜144a、絶縁膜151aを、順に積層するように形成する。

#### 【0351】

絶縁膜143a及び絶縁膜151aは、ゲート絶縁膜104nまたはゲート絶縁膜104pと同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。なお、後にゲート絶縁膜143となる絶縁膜143aは、水分や、水素などの不純物を極力含まないことが望ましく、単層の絶縁膜であっても良いし、積層された複数の絶縁膜で構成されていても良い。ゲート絶縁膜143に水素が含まれると、その水素が酸化物半導体膜142へ侵入し、又は水素が酸化物半導体膜142中の酸素を引き抜き、酸化物半導体膜142が低抵抗化(n型化)してしまい、寄生チャネルが形成されるおそれがある。よって、ゲート絶縁膜143はできるだけ水素を含まない膜になるように、成膜方法に水素を用いないことが重要である。上記ゲート絶縁膜143には、バリア性の高い材料を用いるのが望ましい。例えば、バリア性の高い絶縁膜として、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、窒化アルミニウム膜、又は窒化酸化アルミニウム膜などを用いることができる。複数の積層された絶縁膜を用いる場合、窒素の含有比率が低い酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜などの絶縁膜を、上記バリア性の高い絶縁膜よりも、酸化物半導体膜142に近い側に形成する。そして、窒素の含有比率が低い絶縁膜を間に挟んで酸化物半導体膜142と重なるように、バリア性の高い絶縁膜を形成する。バリア性の高い絶縁膜を用いることで、酸化物半導体膜142内、ゲート絶縁膜143内、或いは、酸化物半導体膜142と他の絶縁膜の界面とその近傍に、水分又は水素などの不純物が入り込むのを防ぐことができる。また、酸化物半導体膜142に接するように窒素の比率が低い酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜などの絶縁膜を形成することで、バリア性の高い材料を用いた絶縁膜が酸化物半導体膜142に直接接するのを防ぐことができる。

#### 【0352】

本実施の形態では、プラズマCVD法で形成された膜厚20nmの酸化窒化シリコン膜を絶縁膜143aとして用い、スパッタ法で形成された膜厚100nmの酸化シリコン膜を絶縁膜151aとして用いる。

#### 【0353】

なお、絶縁膜143aを形成した後に、加熱処理を施しても良い。加熱処理は、窒素、超乾燥空気、又は希ガス(アルゴン、ヘリウムなど)の雰囲気下において、好ましくは200以上400以下、例えば250以上350以下で行う。上記ガスは、水の含有量が20ppm以下、好ましくは1ppm以下、より好ましくは10ppb以下であることが望ましい。

#### 【0354】

また、酸素雰囲気下で酸化物半導体膜142に加熱処理を施すことで、酸化物半導体に酸素を添加し、酸化物半導体膜142中においてドナーとなる酸素欠損を低減させても良い。加熱処理の温度は、例えば100以上350未満、好ましくは150以上250未満で行う。上記酸素雰囲気下の加熱処理に用いられる酸素ガスには、水、水素などが含まれないことが好ましい。又は、加熱処理装置に導入する酸素ガスの純度を、6N(99.9999%)以上、好ましくは7N(99.99999%)以上、(即ち酸素中の不純物濃度を1ppm以下、好ましくは0.1ppm以下)とすることが好ましい。

#### 【0355】

或いは、イオン注入法又はイオンドーピング法などを用いて、酸化物半導体膜142に酸

10

20

30

40

50

素を添加することで、ドナーとなる酸素欠損を低減させても良い。例えば、2.45 GHzのマイクロ波でプラズマ化した酸素を酸化物半導体膜142に添加すれば良い。

【0356】

導電膜144aは、スパッタ法や真空蒸着法で形成することができる。導電膜144aとなる導電膜は、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた元素、又は上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜等が挙げられる。また、アルミニウム、銅などの金属膜の下側もしくは上側にクロム、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンなどの高融点金属膜を積層させた構成としても良い。また、アルミニウム又は銅は、耐熱性や腐食性の問題を回避するために、高融点金属材料と組み合わせて用いると良い。高融点金属材料としては、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、ネオジム、スカンジウム、イットリウム等を用いることができる。

10

【0357】

また、導電膜144aとなる導電膜は、単層構造でも、2層以上の積層構造としてもよい。導電膜144aは、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた元素、又は上述した元素を成分とする合金膜か、上述した元素を組み合わせた合金膜等を用いることができる。また、アルミニウム、銅などの金属膜の下側もしくは上側にクロム、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンなどの高融点金属膜を積層させた構成としても良い。また、アルミニウム又は銅は、耐熱性や腐食性の問題を回避するために、高融点金属材料と組み合わせて用いると良い。高融点金属材料としては、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、ネオジム、スカンジウム、イットリウム等を用いることができる。また、Cu-Mg-Al合金、Mo-Ti合金、Ti、Mo、は、酸化膜との密着性が高い。よって、絶縁膜143aが酸化物である場合、絶縁膜143a上の導電膜144aに、上述した酸化膜との密着性が高い材料を用いることが望ましい。例えば、導電膜144aとして、下層にCu-Mg-Al合金、Mo-Ti合金、Ti、或いはMoで構成される導電膜、上層に抵抗値の低いCuで構成される導電膜を積層して用いることで、酸化物である絶縁膜143aとの密着性を高め、なおかつ、抵抗値を下げるることができる。

20

【0358】

また、導電膜144aとなる導電膜としては、導電性の金属酸化物で形成しても良い。導電性の金属酸化物としては酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム酸化スズ混合物、酸化インジウム酸化亜鉛混合物又は前記金属酸化物材料にシリコン若しくは酸化シリコンを含ませたものを用いることができる。

30

【0359】

導電膜形成後に加熱処理を行う場合には、この加熱処理に耐える耐熱性を導電膜に持たせることが好ましい。

【0360】

本実施の形態では、膜厚30nmの窒化タンタル膜上に、膜厚135nmのタングステン膜を積層させ、導電膜144aとして用いる。

【0361】

次に、絶縁膜151a上にマスクを形成し、導電膜144a及び絶縁膜151aをエッチングすることで、図10(C)に示すように、ゲート電極144、及びゲート電極144上の絶縁膜151を形成する。

40

【0362】

導電膜144a及び絶縁膜151aのエッチングには、ウェットエッチングまたはドライエッチングを用いることができ、ウェットエッチングとドライエッチングを組み合わせる用いてもよい。導電膜144a及び絶縁膜151aを所望の形状にエッチングできるよう、材料に合わせてエッチング条件(エッチングガスやエッチング液、エッチング時間、温度等)を適宜設定する。ただし、トランジスタ121のチャネル長(L)を微細に加工するためには、ドライエッチングを用いることが好ましい。

50

## 【0363】

絶縁膜151aのエッチング用ガスとしては、例えば、六フッ化硫黄( $\text{SF}_6$ )、三フッ化窒素( $\text{NF}_3$ )、トリフルオロメタン( $\text{CHF}_3$ )などのフッ素を含むガス、又は、四フッ化炭素( $\text{CF}_4$ )と水素の混合ガス等を用いることができ、希ガス(ヘリウム( $\text{He}$ )、アルゴン( $\text{Ar}$ )、キセノン( $\text{Xe}$ ))、一酸化炭素、又は二酸化炭素等を添加しても良い。また、導電膜144aのエッチング用ガスとしては、塩素、塩化硼素、塩化シリコン、四塩化炭素などの塩素系ガス、四弗化炭素、弗化硫黄、弗化窒素などのフッ素系ガス、または酸素などを適宜用いることができる。

## 【0364】

次に、図10(D)に示すように、ゲート電極144及び絶縁膜151をマスクとして酸化物半導体膜142にドーパントを添加することで、ゲート電極144と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第1の領域147と、ソースまたはドレインとして機能し、第1の領域147を挟む第2の領域148及び第2の領域149とを形成する。

10

## 【0365】

酸化物半導体膜142にドーパントを添加する方法として、イオンドーピング法またはイオンインプランテーション法を用いることができる。また、添加するドーパントは、例えばヘリウム、アルゴン、キセノンなどの希ガスや、窒素、リン、ヒ素、アンチモンなどの15族原子などを少なくとも一つ用いることができる。

## 【0366】

例えば、窒素をドーパントとして用いた場合、第2の領域148及び第2の領域149中の窒素原子の濃度は、 $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以上 $1 \times 10^{22} / \text{cm}^3$ 以下であることが望ましい。

20

## 【0367】

さらに、上記ドーパントの添加はイオンドーピング法またはイオンインプランテーション法以外の方法でも行うことができる。例えば、添加する元素を含むガス雰囲気にてプラズマを発生させて、被添加物に対してプラズマ処理を行うことによって、ドーパントを添加することができる。上記プラズマを発生させる装置としては、ドライエッチング装置やプラズマCVD装置、高密度プラズマCVD装置などを用いることができる。

## 【0368】

ドーピングの条件として、例えば、ドーパントが窒素の場合、加速電圧を20kVとして行う。また、ドーパントがリンの場合、加速電圧を40kVとして行う。窒素又はリンのドーズ量を $1 \times 10^{14} / \text{cm}^2$ 以下の場合、450 未満で熱処理を行うことが好ましい。これにより、ドーパントを含む第2の領域148及び第2の領域149におけるシート抵抗を $1 \times 10^7 / \text{sq}$ 以下とすることができる。また、ドーズ量が $5 \times 10^{14} / \text{cm}^2$ 以上 $5 \times 10^{15} / \text{cm}^2$ 未満の場合、450 以上600 以下で熱処理を行うことが好ましい。これにより、第2の領域148及び第2の領域149においてシート抵抗を $1 \times 10^5 / \text{sq}$ 以下とすることができる。さらに、ドーズ量が $5 \times 10^{15} / \text{cm}^2$ 以上の場合、600 以上で熱処理を行うことがこのましい。これにより、ドーパントを含む第2の領域148及び第2の領域149においてシート抵抗を $1 \times 10^5 / \text{sq}$ 以下とすることができる。

30

40

## 【0369】

第2の領域148及び第2の領域149において、シート抵抗を低減することにより、第2の領域148及び第2の領域149と、後に形成される導電膜163及び導電膜164の間の抵抗を低減することができる。よって、トランジスタ121の微細化を進めても、高いオン電流と、高速動作を確保することができる。また、トランジスタ121の微細化により、記憶装置の単位面積あたりの記憶容量を高めることができる。

## 【0370】

次に、絶縁膜143a、ゲート電極144、及び絶縁膜151等を覆うように絶縁膜を形成した後、当該絶縁膜及び絶縁膜143aの形状をエッチング等により加工する。上記工

50

程により、図 1 1 ( A ) に示すように、当該絶縁膜からゲート電極 1 4 4 の側部に設けられたサイドウォール 1 5 0 が形成され、絶縁膜 1 4 3 a からゲート電極 1 4 4 及びサイドウォール 1 5 0 の下部に設けられたゲート絶縁膜 1 4 3 が形成される。サイドウォール 1 5 0 となる絶縁膜は、絶縁膜 1 7 3 と同様の材料及び成膜方法を用いて形成することができる。例えば、窒化シリコン膜上に酸化シリコン膜が成膜された積層構造を採用することもできる。本実施の形態では、サイドウォール 1 5 0 となる絶縁膜を、酸化シリコン膜で形成する。

#### 【 0 3 7 1 】

次に、加熱処理を行ってもよい。当該加熱処理の温度は、代表的には、1 5 0 以上 4 5 0 以下、好ましくは 2 5 0 以上 3 2 5 以下とする。または、2 5 0 から 3 2 5

10

#### 【 0 3 7 2 】

加熱処理を行うことにより、酸化物半導体膜 1 4 2 に接している絶縁膜から酸化物半導体膜 1 4 2 に酸素が拡散し、酸化物半導体膜 1 4 2 の絶縁膜に接する面とその近傍における酸素欠損を低減することができる。また、ドーパントを含む第 2 の領域 1 4 8 及び第 2 の領域 1 4 9 の抵抗を低減することができる。

#### 【 0 3 7 3 】

次いで、エッチング等により絶縁膜 1 1 9 及び絶縁膜 1 4 0 に開口部を形成し、一部の第 2 の領域 1 0 9 及び第 2 の領域 1 1 0 と、一部の第 2 の領域 1 1 5 及び第 2 の領域 1 1 6 とを露出させる。そして、導電膜を形成し、当該導電膜の形状をエッチング等により加工

20

#### 【 0 3 7 4 】

導電膜 1 6 1 乃至導電膜 1 6 4 と、導電膜 1 5 3 とを形成するためのエッチングには、ウェットエッチングまたはドライエッチングを用いることができる。上記エッチングに、ウェットエッチングとドライエッチングを組み合わせ用いてもよい。導電膜 1 6 1 乃至導電膜 1 6 4 と、導電膜 1 5 3 とを所望の形状にエッチングできるよう、材料に合わせてエッチング条件（エッチングガスやエッチング液、エッチング時間、温度等）を適宜設定する。ただし、トランジスタを微細に加工するためには、ドライエッチングを用いるのが好ましい。ドライエッチングに用いるエッチングガスとしては、例えば、六フッ化硫黄（ $\text{SF}_6$ ）、三フッ化窒素（ $\text{NF}_3$ ）、トリフルオロメタン（ $\text{CHF}_3$ ）などのフッ素を含むガス、又は、四フッ化炭素（ $\text{CF}_4$ ）と水素の混合ガス等を用いることができ、希ガス（ヘリウム（ $\text{He}$ ）、アルゴン（ $\text{Ar}$ ）、キセノン（ $\text{Xe}$ ））、一酸化炭素、又は二酸化炭素等を添加してもよい。

30

#### 【 0 3 7 5 】

本実施の形態では、膜厚 1 0 0 nm 程度のタンゲステン膜を、導電膜 1 6 1 乃至導電膜 1 6 4 と、導電膜 1 5 3 として用いる。導電膜 1 6 1 乃至導電膜 1 6 4 と、導電膜 1 5 3 としてタンゲステン膜を用いる場合のエッチング条件として、例えば、 $\text{ICP/Bias} = 500 / 150 \text{ W}$ 、圧力 1 . 0 Pa、エッチングガスは、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{Cl}_2$ 、及び  $\text{O}_2$  の混合ガスとし、流量比は、 $\text{CF}_4 / \text{Cl}_2 / \text{O}_2 = 25 / 25 / 10 \text{ sccm}$  とすれば良い。

40

#### 【 0 3 7 6 】

なお、本実施の形態では、導電膜 1 6 3 及び導電膜 1 6 4 を、サイドウォール 1 5 0 に接して設ける。上記構成により、導電膜 1 6 3 及び導電膜 1 6 4 を形成するためのマスクに多少位置ずれが生じたとしても、導電膜 1 6 3 及び導電膜 1 6 4 と酸化物半導体膜 1 4 2 との接する面積が、変動するのを防ぐことができる。よって、導電膜 1 6 3 及び導電膜 1

50

64の位置がずれることによる、導電膜163及び導電膜164と酸化物半導体膜142との間の抵抗の変動を抑制し、トランジスタ121のオン電流の変動を防ぐことができる。さらに、導電膜163及び導電膜164を形成するためのエッチングの際に、酸化物半導体膜142がエッチングガスに曝されにくいため、好ましい。

【0377】

以上の工程により、記憶素子が有するnチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pと、トランジスタ121とを作製することができる。

【0378】

次に、図11(C)に示すように、第2の酸化絶縁膜140b、導電膜161乃至導電膜164、導電膜153、サイドウォール150、及び絶縁膜151上に、絶縁膜154を形成した後、絶縁膜154上において、導電膜153と重なる位置に導電膜155を形成する。

10

【0379】

絶縁膜154は、酸化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化タンタル等の無機絶縁材料を含む材料を用いて形成することができる。また、ポリイミド、アクリル等の有機絶縁材料を用いて形成することも可能である。

【0380】

本実施の形態では、絶縁膜154を、スパッタ法で形成された膜厚50nmの酸化アルミニウム膜と、プラズマCVD法で形成された膜厚300nmの酸化窒化シリコン膜とを、順に積層させた構造を有している。なお、絶縁膜154は、単層の絶縁膜で構成されていても良いし、3層以上の積層された絶縁膜で構成されていても良い。

20

【0381】

導電膜155は、導電膜144aと同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。本実施の形態では、膜厚20nmのチタン膜と、膜厚50nmのタンゲステン膜と、膜厚200nmのアルミニウム膜と、膜厚5nmのチタン膜とが順に積層された構造を有する導電膜155を、スパッタ法にて形成する。

【0382】

以上の工程により、容量素子136を作製することができる。

【0383】

次いで、図11(D)に示すように、導電膜155と、絶縁膜154とを覆うように、絶縁膜160を形成した後、絶縁膜160にエッチング等により開口部を形成することで、導電膜162の一部を露出させる。次いで、開口部において導電膜162と接する導電膜158を、絶縁膜160上に形成する。

30

【0384】

絶縁膜160はその表面が平坦化されていることが望ましい。絶縁膜160は、酸化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化タンタル等の無機絶縁材料を含む材料を用いて形成することができる。また、絶縁膜160は、ポリイミド、アクリル等の有機絶縁材料を用いて形成することも可能である。本実施の形態では、膜厚1500nmのポリイミド膜を、絶縁膜160として用いる。

【0385】

導電膜158は、導電膜144aと同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。本実施の形態では、膜厚20nmのチタン膜と、膜厚50nmのタンゲステン膜と、膜厚300nmのアルミニウム膜と、膜厚5nmのチタン膜とが順に積層された構造を有する導電膜158を、スパッタ法にて形成する。

40

【0386】

以上の工程により、図11(D)に示すような、本発明の一態様に係る半導体装置を作製することができる。

【0387】

なお、本実施の形態では、ゲート電極144及び絶縁膜151をマスクとして酸化物半導体膜142にドーパントを添加しているが、酸化物半導体膜142へのドーパントの添加

50

は、サイドウォール 150 を形成した後、導電膜 163 及び導電膜 164 を形成する前に行って良い。

【0388】

図 15 (A) に、ドーパントの添加が行われる前の酸化物半導体膜 142 と、当該酸化物半導体膜 142 上のゲート絶縁膜 143 と、ゲート絶縁膜 143 上のゲート電極 144 と、ゲート電極 144 上の絶縁膜 151 と、ゲート絶縁膜 143 上においてゲート電極 144 の側部に設けられたサイドウォール 150 とを示す。上記状態において、ゲート電極 144、絶縁膜 151、及びサイドウォール 150 をマスクとして酸化物半導体膜 142 にドーパントを添加することで、図 15 (B) に示すように、ゲート電極 144 と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第 1 の領域 147 と、LDD 領域として機能し、サイドウォール 150 と重なり、なおかつ第 1 の領域 147 を挟む第 3 の領域 190 及び第 3 の領域 191 と、ソースまたはドレインとして機能し、第 1 の領域 147、第 3 の領域 190 及び第 3 の領域 191 を挟む第 2 の領域 148 及び第 2 の領域 149 とを、酸化物半導体膜 142 に形成することができる。

10

【0389】

例えば、窒素をドーパントとして用いた場合、第 2 の領域 148 及び第 2 の領域 149 中の窒素原子の濃度は、 $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$  以上  $1 \times 10^{22} / \text{cm}^3$  以下であることが望ましい。また、例えば、窒素をドーパントとして用いた場合、第 3 の領域 190 及び第 3 の領域 191 中の窒素原子の濃度は、 $5 \times 10^{18} / \text{cm}^3$  以上  $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$  未満であることが望ましい。第 2 の領域 148 及び第 2 の領域 149 よりもドーパントの濃度が低い第 3 の領域 190 及び第 3 の領域 191 を設けることで、短チャネル効果による閾値電圧のマイナスシフトを軽減することができる。

20

【0390】

本実施の形態は、上記実施の形態と適宜組み合わせることで実施することが可能である。

【0391】

(実施の形態 3)

本実施の形態では、図 1 に示す構成をその一部に有する半導体装置の、作製方法の一例について説明する。

【0392】

ただし、記憶素子が有する n チャネル型トランジスタ 102 n 及び p チャネル型トランジスタ 102 p は、シリコンの他、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、単結晶炭化シリコンなどの半導体材料を用いても良い。また、例えば、シリコンを用いた n チャネル型トランジスタ 102 n 及び p チャネル型トランジスタ 102 p は、シリコンウェハなどの単結晶半導体基板、SOI 法により作製されたシリコン薄膜、気相成長法により作製されたシリコン薄膜などを用いて形成することができる。

30

【0393】

なお、n チャネル型トランジスタ 102 n 及び p チャネル型トランジスタ 102 p の作製方法については、実施の形態 2 と同様に行うことができる。よって、本実施の形態では、図 8 (D) に示した工程まで、実施の形態 2 の説明を参照することができる。

【0394】

図 8 (E) に示した工程まで終了した後、絶縁膜 119 の表面に平坦化処理を施し、次いで、図 12 (A) に示すように、絶縁膜 119 上に絶縁膜 180 を形成する。

40

【0395】

絶縁膜 119 の材料、構成、作製方法、平坦化処理の方法については、実施の形態 2 を参照することができる。また、絶縁膜 180 の材料、積層構造、及び作製方法は、実施の形態 2 に記載の絶縁膜 173 と同様とすることができる。

【0396】

次いで、図 12 (B) に示すように、エッチング等により、絶縁膜 180 の一部を除去することで、凸部を有する第 1 の酸化絶縁膜 120 a が形成される。第 1 の酸化絶縁膜 120 a は、後に形成される絶縁膜 120 の一部となる。絶縁膜 180 のエッチングは、ドラ

50

イエッチングまたはウェットエッチング、或いはその両方を用いて行うことができる。エッチングの際に、水素を含む不純物が含まれないように行うことが望ましい。

【0397】

次いで、図12(C)に示すように、第1の酸化絶縁膜120aを覆うように、絶縁膜181を形成する。絶縁膜181の材料、積層構造、及び作製方法は、実施の形態2に記載の絶縁膜175と同様とすることができる。ただし、絶縁膜181は、第1の酸化絶縁膜120aの凸部の高さよりも、その膜厚が大きくなるように形成する。上記構成により、後の平坦化工程において、平坦性の高い第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120bを形成することができる。

【0398】

次いで、図12(D)に示すように、絶縁膜181に平坦化処理を施すことにより、絶縁膜181から第2の酸化絶縁膜120bを形成する。上記平坦化処理は、実施の形態2に記載の絶縁膜175に施した平坦化処理と同様に行うことができる。絶縁膜181に平坦化処理を施すことで、第1の酸化絶縁膜120aの凸部が露出する。なお、当該平坦化処理において、第1の酸化絶縁膜120aの凸部が、一部除去されても良い。

【0399】

次いで、図13(A)に示すように、第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120b上に、島状の酸化物半導体膜122を形成する。酸化物半導体膜122の材料、積層構造、及び作製方法は、実施の形態2に記載の酸化物半導体膜142と同様とすることができる。ただし、酸化物半導体膜122は、後に酸化物半導体膜122内に形成される第1の領域127が上記第1の酸化絶縁膜120aに接するように、なおかつ、後に酸化物半導体膜122内に形成される第2の領域128が第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120bに接するように、その形成される位置を定める。

【0400】

次いで、図13(B)に示すように、第1の酸化絶縁膜120a、第2の酸化絶縁膜120b、及び酸化物半導体膜122上を覆うように、絶縁膜123a、導電膜124a、絶縁膜131aを、順に積層するように形成する。

【0401】

絶縁膜123a及び絶縁膜131aは、実施の形態2における絶縁膜143a及び絶縁膜151aと、それぞれ同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。なお、絶縁膜123aを形成した後に、加熱処理を施しても良い。上記加熱処理は、実施の形態2において絶縁膜143aを形成した後に行われる加熱処理と同様の条件で行うことができる。

【0402】

また、導電膜124aは、実施の形態2における導電膜144aと、同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。

【0403】

次に、絶縁膜131a上にマスクを形成し、導電膜124a及び絶縁膜131aをエッチングすることで、ゲート電極124、及びゲート電極124上の絶縁膜131を形成する。次いで、図13(C)に示すように、ゲート電極124及び絶縁膜131をマスクとして酸化物半導体膜122にドーパントを添加することで、ゲート電極124と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第1の領域127と、ソースまたはドレインとして機能し、第1の領域127を挟む第2の領域128及び第2の領域129とを形成する。導電膜124a及び絶縁膜131aのエッチングは、実施の形態2における導電膜144a及び絶縁膜151aのエッチングと同様の条件で行うことができる。

【0404】

酸化物半導体膜122へのドーパントの添加と、その後に行われる加熱処理については、実施の形態2における酸化物半導体膜142へのドーパントの添加と加熱処理と同様に行うことができる。上記ドーパントの添加と加熱処理により、第2の領域128及び第2の領域129において、シート抵抗を低減させることができる。よって、第2の領域128

10

20

30

40

50

及び第2の領域129と、後に形成される導電膜163及び導電膜164の間の抵抗を低減することができる。そのため、トランジスタ121の微細化を進めても、高いオン電流と、高速動作を確保することができる。また、トランジスタ121の微細化により、記憶装置の単位面積あたりの記憶容量を高めることができる。

#### 【0405】

次に、絶縁膜123a、ゲート電極124、及び絶縁膜131等を覆うように絶縁膜を形成した後、当該絶縁膜及び絶縁膜123aの形状をエッチング等により加工する。上記工程により、図13(D)に示すように、当該絶縁膜からゲート電極124の側部に設けられたサイドウォール130が形成され、絶縁膜123aからゲート電極124及びサイドウォール130の下部に設けられたゲート絶縁膜123が形成される。サイドウォール130となる絶縁膜は、絶縁膜180と同様の材料、積層構造、及び作製方法を用いて形成することができる。

10

#### 【0406】

次に、加熱処理を行ってもよい。当該加熱処理の温度は、代表的には、150 以上450 以下、好ましくは250 以上325 以下とする。または、250 から325 まで徐々に温度上昇させながら加熱してもよい。

#### 【0407】

加熱処理を行うことにより、酸化物半導体膜122に接している絶縁膜から酸化物半導体膜122に酸素が拡散し、酸化物半導体膜122の絶縁膜に接する面とその近傍における酸素欠損を低減することができる。また、ドーパントを含む第2の領域128及び第2の領域129の抵抗を低減することができる。

20

#### 【0408】

次いで、エッチング等により絶縁膜119及び絶縁膜120に開口部を形成し、一部の第2の領域109及び第2の領域110と、一部の第2の領域115及び第2の領域116とを露出させる。そして、導電膜を形成し、当該導電膜の形状をエッチング等により加工することで、図14(A)に示すように、第2の領域109に接する導電膜161と、第2の領域110及び第2の領域115に接する導電膜162と、第2の領域116及び第2の領域128に接する導電膜163と、第2の領域129に接する導電膜164と、導電膜133とを、絶縁膜120上に形成する。導電膜161乃至導電膜164と、導電膜133とは、導電膜124aと同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。

30

#### 【0409】

導電膜161乃至導電膜164と、導電膜133とを形成するためのエッチングは、実施の形態2における導電膜161乃至導電膜164と、導電膜153とを形成するためのエッチングと同様の条件で行うことができる。

#### 【0410】

なお、本実施の形態では、導電膜163及び導電膜164を、サイドウォール130に接して設ける。上記構成により、導電膜163及び導電膜164を形成するためのマスクに多少位置ずれが生じたとしても、導電膜163及び導電膜164と酸化物半導体膜122との接する面積が、変動するのを防ぐことができる。よって、導電膜163及び導電膜164の位置がずれることによる、導電膜163及び導電膜164と酸化物半導体膜122との間の抵抗の変動を抑制し、トランジスタ121のオン電流の変動を防ぐことができる。さらに、導電膜163及び導電膜164を形成するためのエッチングの際に、酸化物半導体膜122がエッチングガスに曝されにくいいため、好ましい。

40

#### 【0411】

以上の工程により、記憶素子が有するnチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pと、トランジスタ121を作製することができる。

#### 【0412】

次に、図14(B)に示すように、第2の酸化絶縁膜120b、導電膜161乃至導電膜164、導電膜133、サイドウォール130、及び絶縁膜131上に、絶縁膜134を

50

形成した後、絶縁膜 1 3 4 上において、導電膜 1 3 3 と重なる位置に導電膜 1 3 5 を形成する。

【 0 4 1 3 】

絶縁膜 1 3 4 は、実施の形態 2 における絶縁膜 1 5 4 と同様の材料、同様の積層構造、同様の作製方法を用いて形成することができる。また、導電膜 1 3 5 は、導電膜 1 2 4 a と同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。

【 0 4 1 4 】

以上の工程により、容量素子 1 3 6 を作製することができる。

【 0 4 1 5 】

次いで、図 1 4 ( C ) に示すように、導電膜 1 3 5 と、絶縁膜 1 3 4 とを覆うように、絶縁膜 1 8 7 を形成した後、絶縁膜 1 8 7 にエッチング等により開口部を形成することで、導電膜 1 6 2 の一部を露出させる。次いで、開口部において導電膜 1 6 2 と接する導電膜 1 8 8 を、絶縁膜 1 8 7 上に形成する。

10

【 0 4 1 6 】

絶縁膜 1 8 7 は、実施の形態 2 における絶縁膜 1 6 0 と同様の材料、同様の積層構造、同様の作製方法を用いて形成することができる。導電膜 1 8 8 は、導電膜 1 2 4 a と同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。

【 0 4 1 7 】

以上の工程により、図 1 4 ( C ) に示すような、本発明の一態様に係る半導体装置を作製することができる。

20

【 0 4 1 8 】

なお、本実施の形態では、ゲート電極 1 2 4 及び絶縁膜 1 3 1 をマスクとして酸化物半導体膜 1 2 2 にドーパントを添加しているが、酸化物半導体膜 1 2 2 へのドーパントの添加は、サイドウォール 1 3 0 を形成した後、導電膜 1 6 3 及び導電膜 1 6 4 を形成する前に行っても良い。

【 0 4 1 9 】

図 1 6 ( A ) に、ドーパントの添加が行われる前の酸化物半導体膜 1 2 2 と、当該酸化物半導体膜 1 2 2 上のゲート絶縁膜 1 2 3 と、ゲート絶縁膜 1 2 3 上のゲート電極 1 2 4 と、ゲート電極 1 2 4 上の絶縁膜 1 3 1 と、ゲート絶縁膜 1 2 3 上においてゲート電極 1 2 4 の側部に設けられたサイドウォール 1 3 0 とを示す。上記状態において、ゲート電極 1 2 4、絶縁膜 1 3 1、及びサイドウォール 1 3 0 をマスクとして酸化物半導体膜 1 2 2 にドーパントを添加することで、図 1 6 ( B ) に示すように、ゲート電極 1 2 4 と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第 1 の領域 1 2 7 と、LDD 領域として機能し、サイドウォール 1 3 0 と重なり、なおかつ第 1 の領域 1 2 7 を挟む第 3 の領域 1 9 2 及び第 3 の領域 1 9 3 と、ソースまたはドレインとして機能し、第 1 の領域 1 2 7、第 3 の領域 1 9 2 及び第 3 の領域 1 9 3 を挟む第 2 の領域 1 2 8 及び第 2 の領域 1 2 9 とを、酸化物半導体膜 1 2 2 に形成することができる。

30

【 0 4 2 0 】

例えば、窒素をドーパントとして用いた場合、第 2 の領域 1 2 8 及び第 2 の領域 1 2 9 中の窒素原子の濃度は、 $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$  以上  $1 \times 10^{22} / \text{cm}^3$  以下であることが望ましい。また、例えば、窒素をドーパントとして用いた場合、第 3 の領域 1 9 2 及び第 3 の領域 1 9 3 中の窒素原子の濃度は、 $5 \times 10^{18} / \text{cm}^3$  以上  $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$  未満であることが望ましい。第 2 の領域 1 2 8 及び第 2 の領域 1 2 9 よりもドーパントの濃度が低い第 3 の領域 1 9 2 及び第 3 の領域 1 9 3 を設けることで、短チャネル効果による閾値電圧のマイナスシフトを軽減することができる。

40

【 0 4 2 1 】

本実施の形態は、上記実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。

【 0 4 2 2 】

( 実施の形態 4 )

本実施の形態では、図 3 9 に示す構成をその一部に有する半導体装置の、作製方法の一例

50

について説明する。

【0423】

ただし、記憶素子が有するnチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pは、シリコンの他、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、単結晶炭化シリコンなどの半導体材料を用いても良い。また、例えば、シリコンを用いたnチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pは、シリコンウェハなどの単結晶半導体基板、SOI法により作製されたシリコン薄膜、気相成長法により作製されたシリコン薄膜などを用いて形成することができる。

【0424】

本実施の形態では、まず、図42(A)に示すように、基板100上に絶縁膜101と、島状である単結晶の半導体膜103n及び半導体膜103pを形成する。

10

【0425】

基板100として使用することができる素材に大きな制限はないが、少なくとも、後の加熱処理に耐えうる程度の耐熱性を有していることが必要となる。例えば、基板100には、フュージョン法やフロート法で作製されるガラス基板、石英基板、半導体基板、セラミック基板等を用いることができる。ガラス基板としては、後の加熱処理の温度が高い場合には、歪み点が730以上のものを用いると良い。

【0426】

本実施の形態では、単結晶シリコンの半導体基板を基板100として用いる。単結晶の半導体基板はガラス基板よりも表面の平坦性が高い。よって、基板のうねりに起因して絶縁膜や導電膜などの膜厚がばらつくのを防ぐことができるため、トランジスタなどの半導体素子を微細化しても半導体素子の電気的特性を均一にすることができる。

20

【0427】

絶縁膜101は、酸化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン等の絶縁性を有する材料を用いて形成する。絶縁膜101は、単数の絶縁膜を用いたものであっても、複数の絶縁膜を積層して用いたものであっても良い。

【0428】

例えば酸化シリコンを絶縁膜101として用いる場合、絶縁膜101はシランと酸素、TEOS(テトラエトキシシラン)と酸素等の混合ガスを用い、熱CVD、プラズマCVD、常圧CVD、バイアスECRCVD等の気相成長法によって形成することができる。この場合、絶縁膜101の表面を酸素プラズマ処理で緻密化しても良い。また、窒化シリコンを絶縁膜101として用いる場合、シランとアンモニアの混合ガスを用い、プラズマCVD等の気相成長法によって形成することができる。また、窒化酸化シリコンを絶縁膜101として用いる場合、シランとアンモニアの混合ガス、またはシランと酸化窒素の混合ガスを用い、プラズマCVD等の気相成長法によって形成することができる。

30

【0429】

また絶縁膜101として、有機シランガスを用いて化学気相成長法により作製される酸化シリコンを用いても良い。有機シランガスとしては、珪酸エチル(TEOS:化学式 $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ )、テトラメチルシラン(TMS:化学式 $\text{Si}(\text{CH}_3)_4$ )、テトラメチルシクロテトラシロキサン(TMCTS)、オクタメチルシクロテトラシロキサン(OMCTS)、ヘキサメチルジシラザン(HMDS)、トリエトキシシラン( $\text{SiH}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ )、トリスジメチルアミノシラン( $\text{SiH}(\text{N}(\text{CH}_3)_2)_3$ )等のシリコン含有化合物を用いることができる。

40

【0430】

また、基板100が単結晶シリコンの半導体基板である場合、基板100の表面を酸化することで得られる酸化膜で、絶縁膜101を構成することもできる。上記酸化膜を形成するための、熱酸化処理には、ドライ酸化でも良いが、酸化雰囲気中にハロゲンを含むガスを添加しても良い。ハロゲンを含むガスとして、 $\text{HCl}$ 、 $\text{HF}$ 、 $\text{NF}_3$ 、 $\text{HBr}$ 、 $\text{Cl}$ 、 $\text{ClF}$ 、 $\text{BCl}_3$ 、 $\text{F}$ 、 $\text{Br}_2$ などから選ばれた一種又は複数種ガスを用いることができる。

50

## 【0431】

例えばHClを用いる場合、酸素に対しHClを0.5~10体積%（好ましくは3体積%）の割合で含む雰囲気中で、700以上の温度で熱処理を行う。950以上1100以下の加熱温度で熱酸化を行うとよい。処理時間は0.1~6時間、好ましくは0.5~1時間とすればよい。形成される絶縁膜101の膜厚は、15nm~1100nm（好ましくは60nm~300nm）、例えば150nmとすることができる。

## 【0432】

このハロゲンを含む雰囲気での熱酸化処理により、絶縁膜101にハロゲンを含ませることができる。ハロゲン元素を $1 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3 \sim 5 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度で絶縁膜101に含ませることにより、金属などの不純物を絶縁膜101が捕獲するので、後に形成される半導体膜103n及び半導体膜103pの汚染を防止することができる。例えば、塩素の作用により、金属などの不純物が揮発性の塩化物となって気相中へ離脱して、半導体膜103n及び半導体膜103pから除去される。

## 【0433】

また、本実施の形態では、半導体膜103n及び半導体膜103pが単結晶のシリコンである場合を例に挙げて、以下、記憶素子が有するトランジスタの作製方法について説明する。なお、具体的な単結晶の半導体膜103n及び半導体膜103pの作製方法の一例について、簡単に説明する。まず、単結晶シリコンの半導体基板であるボンド基板に、電界で加速されたイオンでなるイオンビームを注入し、ボンド基板の表面から一定の深さの領域に、結晶構造が乱されることで局所的に脆弱化された脆化層を形成する。脆化層が形成される領域の深さは、イオンビームの加速エネルギーとイオンビームの入射角によって調節することができる。そして、ボンド基板と、表面に絶縁膜が形成された基板100とを、間に当該絶縁膜が挟まるように貼り合わせる。貼り合わせは、ボンド基板と基板100とを重ね合わせた後、ボンド基板と基板100の一部に、 $1 \text{ N/cm}^2$ 以上 $500 \text{ N/cm}^2$ 以下、好ましくは $11 \text{ N/cm}^2$ 以上 $20 \text{ N/cm}^2$ 以下程度の圧力を加える。圧力を加えると、その部分からボンド基板と絶縁膜101とが接合を開始し、最終的には密着した面全体に接合が及ぶ。次いで、加熱処理を行うことで、脆化層に存在する微小ボイド同士が結合して、微小ボイドの体積が増大する。その結果、脆化層においてボンド基板の一部である単結晶半導体膜が、ボンド基板から分離する。上記加熱処理の温度は、基板100の歪み点を越えない温度とする。そして、上記単結晶半導体膜をエッチング等により所望の形状に加工することで、半導体膜103n及び半導体膜103pを形成することができる。

## 【0434】

本実施の形態では、単結晶シリコンの半導体基板である基板100に、酸素雰囲気中で950の温度で加熱処理を施すことで、基板100上に膜厚400nmの酸化シリコン膜を形成する。次いで、酸化シリコン膜上に、プラズマCVDにより、膜厚50nmの窒化酸化シリコン膜を形成する。一方、単結晶シリコンの半導体基板であるボンド基板に、酸素にHClを含ませた雰囲気中で、950の温度で加熱処理を行うことで、ボンド基板上に膜厚100nmの酸化シリコン膜を形成する。そして、上記基板100と、ボンド基板とを、基板100上の窒化酸化シリコン膜と、ボンド基板上の酸化シリコン膜とが接するように貼り合わせる。そして、脆化層においてボンド基板の一部である単結晶半導体膜を、ボンド基板から分離させる。従って、本実施の形態では、絶縁膜101が、基板100側から、膜厚400nmの酸化シリコン膜、膜厚50nmの窒化酸化シリコン膜、膜厚100nmの酸化シリコン膜が、順に積層された構成を有する。

## 【0435】

半導体膜103n及び半導体膜103pには、閾値電圧を制御するために、硼素、アルミニウム、ガリウムなどのp型の導電性を付与する不純物元素、若しくはリン、砒素などのn型の導電性を付与する不純物元素を添加しても良い。閾値電圧を制御するための不純物元素の添加は、パターニングする前の半導体膜に対して行っても良いし、パターニング後に形成された半導体膜103n及び半導体膜103pに対して行っても良い。また、閾値

電圧を制御するための不純物元素の添加を、ボンド基板に対して行っても良い。若しくは、不純物元素の添加を、閾値電圧を大まかに調整するためにボンド基板に対して行った上で、閾値電圧を微調整するために、パターニング前の半導体膜に対して、又はパターニングにより形成された半導体膜 103n 及び半導体膜 103p に対しても行っても良い。

#### 【0436】

なお、本実施の形態では、単結晶の半導体膜を用いる例について説明しているが、本発明はこの構成に限定されない。例えば、絶縁膜 101 上に気相成長法を用いて形成された多結晶の半導体膜を用いても良いし、気相成長法を用いて形成された半導体膜を公知の技術により結晶化して多結晶の半導体膜を形成しても良い。公知の結晶化方法としては、レーザ光を用いたレーザ結晶化法、触媒元素を用いる結晶化法がある。或いは、触媒元素を用いる結晶化法とレーザ結晶化法とを組み合わせることもできる。また、石英基板のような耐熱性に優れている基板を用いる場合、電熱炉を使用した熱結晶化方法、赤外光を用いたランプアニール結晶化法、触媒元素を用いる結晶化法、950 程度の高温アニール法を用いた結晶化法を用いても良い。

#### 【0437】

次に、図 42 (B) に示すように、半導体膜 103n 及び半導体膜 103p 上にゲート絶縁膜 104n 及びゲート絶縁膜 104p をそれぞれ形成した後、半導体膜 103n と重なる位置においてゲート絶縁膜 104n 上にゲート電極 105n を、半導体膜 103p と重なる位置においてゲート絶縁膜 104p 上にゲート電極 105p を形成する。そして、ゲート電極 105n 及びゲート電極 105p をマスクとして、一導電性を付与する不純物元素を半導体膜 103n 及び半導体膜 103p に添加する。具体的には、まず、半導体膜 103n を覆うようにマスクを形成した後、半導体膜 103p に、p 型の導電性を付与する不純物元素を添加する。上記不純物元素の添加により、半導体膜 103p には、ゲート電極 105p と重なる第 1 の領域 114 と、第 1 の領域 114 を間に挟む低濃度不純物領域 117a 及び低濃度不純物領域 118a とが形成される。次いで、半導体膜 103p を覆うようにマスクを形成した後、半導体膜 103n に、n 型の導電性を付与する不純物元素を添加する。上記不純物元素の添加により、半導体膜 103n には、ゲート電極 105n と重なる第 1 の領域 108 と、第 1 の領域 108 を間に挟む低濃度不純物領域 111a 及び低濃度不純物領域 112a とが形成される。

#### 【0438】

ゲート絶縁膜 104n 及びゲート絶縁膜 104p は、高密度プラズマ処理、熱酸化処理などを行うことにより半導体膜 103n 及び半導体膜 103p の表面を酸化又は窒化することで形成することができる。ゲート絶縁膜 104n 及びゲート絶縁膜 104p の厚さは、例えば、1nm 以上 100nm 以下、好ましくは 10nm 以上 50nm 以下とすることができる。

#### 【0439】

本実施の形態では、酸素雰囲気中において 25 分間 950 にて加熱処理を行った後、酸素雰囲気中において 1 時間 950 にて加熱処理を行うことにより、半導体膜 103n 及び半導体膜 103p の表面を熱酸化し、膜厚 15nm の酸化シリコン膜で構成されるゲート絶縁膜 104n 及びゲート絶縁膜 104p を形成する。

#### 【0440】

高密度プラズマ処理を用いる場合は、例えば He、Ar、Kr、Xe などの希ガスと酸素、酸化窒素、アンモニア、窒素などの混合ガスとを用いる。この場合、プラズマの励起をマイクロ波の導入により行うことで、低電子温度で高密度のプラズマを生成することができる。このような高密度のプラズマで生成された酸素ラジカル (OH ラジカルを含む場合もある) や窒素ラジカル (NH ラジカルを含む場合もある) によって、半導体膜の表面を酸化又は窒化することにより、1 ~ 20nm、望ましくは 5 ~ 10nm の絶縁膜が半導体膜に接するように形成できる。例えば、亜酸化窒素 (N<sub>2</sub>O) を Ar で 1 ~ 3 倍 (流量比) に希釈して、10Pa ~ 30Pa の圧力にて 3kW ~ 5kW のマイクロ波 (2.45GHz) 電力を印加して半導体膜 103n 及び半導体膜 103p の表面を酸化若しくは窒化

させる。この処理により  $1\text{ nm} \sim 10\text{ nm}$  (好ましくは  $2\text{ nm} \sim 6\text{ nm}$ ) の絶縁膜を形成する。更に亜酸化窒素 ( $\text{N}_2\text{O}$ ) とシラン ( $\text{SiH}_4$ ) を導入し、 $10\text{ Pa} \sim 30\text{ Pa}$  の圧力にて  $3\text{ kW} \sim 5\text{ kW}$  のマイクロ波 ( $2.45\text{ GHz}$ ) 電力を印加して気相成長法により酸化窒化シリコン膜を形成することにより、ゲート絶縁膜を形成する。固相反応と気相成長法による反応を組み合わせることにより界面準位密度が低く絶縁耐压の優れたゲート絶縁膜を形成することができる。

#### 【0441】

上述した高密度プラズマ処理による半導体膜の酸化又は窒化は固相反応で進むため、ゲート絶縁膜  $104\text{ n}$  及びゲート絶縁膜  $104\text{ p}$  と半導体膜  $103\text{ n}$  及び半導体膜  $103\text{ p}$  との界面準位密度を極めて低くすることができる。また高密度プラズマ処理により半導体膜  $103\text{ n}$  及び半導体膜  $103\text{ p}$  を直接酸化又は窒化することで、形成される絶縁膜の厚さのばらつきを抑えることができる。また半導体膜が結晶性を有する場合、高密度プラズマ処理を用いて半導体膜の表面を固相反応で酸化させることにより、結晶粒界においてのみ酸化が速く進んでしまうのを抑え、均一性が良く、界面準位密度の低いゲート絶縁膜を形成することができる。高密度プラズマ処理により形成された絶縁膜を、ゲート絶縁膜の一部又は全部に含んで形成されるトランジスタは、電気的特性のばらつきを抑えることができる。

#### 【0442】

また、プラズマ CVD 法又はスパッタ法などを用い、酸化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム又は酸化タンタル、酸化イットリウム、ハフニウムシリケート ( $\text{HfSi}_x\text{O}_y$  ( $x > 0$ ,  $y > 0$ ))、窒素が添加されたハフニウムシリケート ( $\text{HfSi}_x\text{O}_y$  ( $x > 0$ ,  $y > 0$ ))、窒素が添加されたハフニウムアルミネート ( $\text{HfAl}_x\text{O}_y$  ( $x > 0$ ,  $y > 0$ )) 等を含む膜を、単層で、又は積層させることで、ゲート絶縁膜を形成しても良い。

#### 【0443】

なお、本明細書において酸化窒化物とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多い物質であり、また、窒化酸化物とは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多い物質を意味する。

#### 【0444】

ゲート電極  $105\text{ n}$  及びゲート電極  $105\text{ p}$  は、ゲート絶縁膜  $104\text{ n}$  及びゲート絶縁膜  $104\text{ p}$  を覆うように導電膜を形成した後、該導電膜を所定の形状に加工 (パターニング) することで、形成することができる。上記導電膜の形成には CVD 法、スパッタ法、蒸着法、スピンコート法などを用いることができる。また、導電膜は、タンタル ( $\text{Ta}$ )、タングステン ( $\text{W}$ )、チタン ( $\text{Ti}$ )、モリブデン ( $\text{Mo}$ )、アルミニウム ( $\text{Al}$ )、銅 ( $\text{Cu}$ )、クロム ( $\text{Cr}$ )、ニオブ ( $\text{Nb}$ ) 等を用いることができる。上記金属を主成分とする合金を用いても良いし、上記金属を含む化合物を用いても良い。又は、半導体膜に導電性を付与するリン等の不純物元素をドーピングした、多結晶シリコンなどの半導体を用いて形成しても良い。

#### 【0445】

なお、ゲート電極  $105\text{ n}$  及びゲート電極  $105\text{ p}$  は、単層の導電膜で構成されていても良いし、積層された複数の導電膜で構成されていても良い。

#### 【0446】

2つの導電膜の組み合わせとして、1層目に窒化タンタル又はタンタルを、2層目にタングステンをを用いることができる。上記例の他に、窒化タングステンとタングステン、窒化モリブデンとモリブデン、アルミニウムとタンタル、アルミニウムとチタン等が挙げられる。タングステンや窒化タンタルは、耐熱性が高いため、2層の導電膜を形成した後の工程において、熱活性化を目的とした加熱処理を行うことができる。また、2層の導電膜の組み合わせとして、例えば、 $n$  型の導電性を付与する不純物元素がドーピングされたシリコンとニッケルシリサイド、 $n$  型の導電性を付与する不純物元素がドーピングされたシリコンとタングステンシリサイド等も用いることができる。

## 【 0 4 4 7 】

3つの導電膜を積層する3層構造の場合は、モリブデン膜とアルミニウム膜とモリブデン膜の積層構造を採用するとよい。

## 【 0 4 4 8 】

また、ゲート電極105n及びゲート電極105pに酸化インジウム、酸化インジウム酸化スズ混合物、酸化インジウム酸化亜鉛混合物、酸化亜鉛、酸化亜鉛アルミニウム、酸化亜鉛アルミニウム、又は酸化亜鉛ガリウム等の透光性を有する酸化物導電膜を用いることもできる。

## 【 0 4 4 9 】

本実施の形態では、膜厚30nm程度の窒化タンタル上に、膜厚170nm程度のタンゲステン積層したゲート電極105n及びゲート電極105pを用いる。

10

## 【 0 4 5 0 】

なお、マスクを用いずに、液滴吐出法を用いて選択的にゲート電極105n及びゲート電極105pを形成しても良い。液滴吐出法とは、所定の組成物を含む液滴を細孔から吐出又は噴出することで所定のパターンを形成する方法を意味し、インクジェット法などがその範疇に含まれる。

## 【 0 4 5 1 】

また、ゲート電極105n及びゲート電極105pは、導電膜を形成後、ICP(Inductively Coupled Plasma:誘導結合型プラズマ)エッチング法を用い、エッチング条件(コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電力量、基板側の電極温度等)を適宜調節することにより、所望のテーパー形状を有するようにエッチングすることができる。また、テーパー形状は、マスクの形状によっても角度等を制御することができる。なお、エッチング用ガスとしては、塩素、塩化硼素、塩化シリコンもしくは四塩化炭素などの塩素系ガス、四弗化炭素、弗化硫黄もしくは弗化窒素などのフッ素系ガス又は酸素を適宜用いることができる。

20

## 【 0 4 5 2 】

次いで、ゲート絶縁膜104n及びゲート絶縁膜104pと、ゲート電極105n及びゲート電極105pとを覆うように絶縁膜を形成した後、エッチング等により、上記絶縁膜の形状を加工することで、図42(C)に示すように、サイドウォール170nをゲート電極105nの側部に、サイドウォール170pをゲート電極105pの側部に、それぞれ形成する。本実施の形態では、膜厚100nmの酸化窒化シリコン膜と、膜厚200nmの酸化シリコン膜とが順に積層された絶縁膜を、ゲート電極105n及びゲート電極105pを覆うように形成した後、ドライエッチングによりその形状を加工することで、サイドウォール170n及びサイドウォール170pを形成する。

30

## 【 0 4 5 3 】

なお、上記エッチングにより、ゲート絶縁膜104nのうち、サイドウォール170nの下部以外の部分が除去され、また、ゲート絶縁膜104pのうち、サイドウォール170pの下部以外の部分が除去される。

## 【 0 4 5 4 】

次に、図42(D)に示すように、ゲート電極105n及びゲート電極105pと、サイドウォール170n及びサイドウォール170pとをマスクとして、一導電性を付与する不純物元素を半導体膜103n及び半導体膜103pに添加する。具体的には、まず、半導体膜103nを覆うようにマスクを形成した後、半導体膜103pに、p型の導電性を付与する不純物元素を添加する。上記不純物元素の添加により、半導体膜103pにおいて、一部の低濃度不純物領域117a及び低濃度不純物領域118aにさらに不純物が添加され、ゲート電極105pと重なる第1の領域114と、サイドウォール170pと重なり、なおかつ第1の領域114を間に挟む第3の領域117及び第3の領域118と、第1の領域114、第3の領域117及び第3の領域118を間に挟む第2の領域115及び第2の領域116とが形成される。次いで、半導体膜103pを覆うようにマスクを形成した後、半導体膜103nに、n型の導電性を付与する不純物元素を添加する。上記

40

50

不純物元素の添加により、半導体膜 1 0 3 n において、一部の低濃度不純物領域 1 1 1 a 及び低濃度不純物領域 1 1 2 a にさらに不純物が添加され、ゲート電極 1 0 5 n と重なる第 1 の領域 1 0 8 と、サイドウォール 1 7 0 n と重なり、なおかつ第 1 の領域 1 0 8 を間に挟む第 3 の領域 1 1 1 及び第 3 の領域 1 1 2 と、第 1 の領域 1 0 8、第 3 の領域 1 1 1 及び第 3 の領域 1 1 2 を間に挟む第 2 の領域 1 0 9 及び第 2 の領域 1 1 0 とが形成される。

#### 【 0 4 5 5 】

第 3 の領域 1 1 7 及び第 3 の領域 1 1 8 は、サイドウォール 1 7 0 p と重なっていることにより、第 2 の領域 1 1 5 及び第 2 の領域 1 1 6 よりも、p 型の導電性を付与する不純物元素の濃度が低い。また、第 3 の領域 1 1 1 及び第 3 の領域 1 1 2 は、サイドウォール 1 7 0 n と重なっていることにより、第 2 の領域 1 0 9 及び第 2 の領域 1 1 0 よりも、n 型の導電性を付与する不純物元素の濃度が低い。

10

#### 【 0 4 5 6 】

なお、本実施の形態では、1 回目の不純物の添加により低濃度不純物領域 1 1 1 a 及び低濃度不純物領域 1 1 2 a と、低濃度不純物領域 1 1 7 a 及び低濃度不純物領域 1 1 8 a とを形成してから、2 回目の不純物の添加を行うことで L D D 領域として機能する第 3 の領域 1 1 1 及び第 3 の領域 1 1 2 と、第 3 の領域 1 1 7 及び第 3 の領域 1 1 8 とを形成しているが、本発明の一態様はこの構成に限定されない。例えば、上記 1 回目の不純物の添加を行わずに、2 回目の不純物の添加を、サイドウォール 1 7 0 n 及びサイドウォール 1 7 0 p の下部に不純物が回り込むような条件で行うことで、L D D 領域として機能する第 3 の領域 1 1 1 及び第 3 の領域 1 1 2 と、第 3 の領域 1 1 7 及び第 3 の領域 1 1 8 とを形成することも可能である。また、上記 1 回目の不純物の添加を行わず、なおかつ 2 回目の不純物の添加を、サイドウォール 1 7 0 n 及びサイドウォール 1 7 0 p の下部に不純物が入りにくい条件で行うことで、第 1 の領域 1 0 8 と第 2 の領域 1 0 9 及び第 2 の領域 1 1 0 との間に、または、第 1 の領域 1 1 4 と第 2 の領域 1 1 5 及び第 2 の領域 1 1 6 との間に、オフセット領域を設けても良い。オフセット領域における不純物濃度は、第 1 の領域 1 0 8 または第 1 の領域 1 1 4 と同程度であることが望ましい。

20

#### 【 0 4 5 7 】

次いで、図 4 3 ( A ) に示すように、半導体膜 1 0 3 n 及び半導体膜 1 0 3 p と、ゲート電極 1 0 5 n 及びゲート電極 1 0 5 p と、サイドウォール 1 7 0 p 及びサイドウォール 1 7 0 n と、絶縁膜 1 0 1 とを覆うように、絶縁膜 1 7 1 を形成する。そして、エッチング等により絶縁膜 1 7 1 に開口部を形成し、一部の第 2 の領域 1 0 9 及び第 2 の領域 1 1 0 と、一部の第 2 の領域 1 1 5 及び第 2 の領域 1 1 6 とを露出させる。次いで、第 2 の領域 1 0 9 に接する導電膜 1 0 6 と、第 2 の領域 1 1 0 及び第 2 の領域 1 1 5 に接する導電膜 1 0 7 と、第 2 の領域 1 1 6 に接する導電膜 1 1 3 とを、絶縁膜 1 7 1 上に形成する。

30

#### 【 0 4 5 8 】

具体的に、絶縁膜 1 7 1 は、酸化シリコン、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウムなどの無機の絶縁膜を用いることができる。特に、誘電率の低い ( l o w - k ) 材料を絶縁膜 1 7 1 に用いることで、各種電極や配線の重なりに起因する容量を十分に低減することが可能になるため好ましい。なお、絶縁膜 1 7 1 に、上記材料を用いた多孔性の絶縁膜を適用しても良い。多孔性の絶縁膜では、密度の高い絶縁膜と比較して誘電率が低下するため、電極や配線に起因する寄生容量を更に低減することが可能である。

40

#### 【 0 4 5 9 】

本実施の形態では、絶縁膜 1 7 1 として膜厚 5 0 0 n m の酸化窒化シリコン膜を用いる。なお、本実施の形態では、絶縁膜 1 7 1 が単層の絶縁膜で構成されている場合を例示しているが、絶縁膜 1 7 1 は、積層された複数の絶縁膜で構成されていても良い。

#### 【 0 4 6 0 】

導電膜 1 0 6、導電膜 1 0 7、及び導電膜 1 1 3 となる導電膜は、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた元素、又は上述した元

50

素を成分とする合金が、上述した元素を組み合わせた合金膜等が挙げられる。また、アルミニウム、銅などの金属膜の下側もしくは上側にクロム、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンなどの高融点金属膜を積層させた構成としても良い。また、アルミニウム又は銅は、耐熱性や腐食性の問題を回避するために、高融点金属材料と組み合わせて用いると良い。高融点金属材料としては、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、ネオジム、スカンジウム、イットリウム等を用いることができる。

【0461】

また、導電膜106、導電膜107、及び導電膜113となる導電膜は、単層構造でも、2層以上の積層構造としてもよい。例えば、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造、アルミニウム膜上にチタン膜を積層する2層構造、チタン膜と、そのチタン膜上に重ねてアルミニウム膜を積層し、更にその上にチタン膜を成膜する3層構造などが挙げられる。

10

【0462】

また、導電膜106、導電膜107、及び導電膜113となる導電膜としては、導電性の金属酸化物で形成しても良い。導電性の金属酸化物としては酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム酸化スズ混合物、酸化インジウム酸化亜鉛混合物又は前記金属酸化物材料にシリコン若しくは酸化シリコンを含ませたものを用いることができる。本実施の形態では、膜厚300nm程度のタングステン膜を、導電膜106、導電膜107、及び導電膜113として用いる。

【0463】

以上の工程により、記憶素子が有するnチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pを形成することができる。

20

【0464】

次いで、図43(B)に示すように、導電膜106、導電膜107、及び導電膜113を覆うように、絶縁膜171上に絶縁膜119と絶縁膜173とを順に積層するように形成した後、絶縁膜173上に酸化物半導体膜142bを形成する。

【0465】

絶縁膜119は単層構造でも2層以上の積層構造でもよいが、その表面は高い平坦性を有することが好ましい。絶縁膜119として、例えば、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコンなどを用いることができる。そして、絶縁膜119は、LPCVD法、プラズマCVD法、光CVD法、熱CVD法などのCVD法を用いて形成することができる。

30

【0466】

また、絶縁膜119として、有機シランを用いて化学気相成長法により作製される酸化シリコン膜を用いることもできる。有機シランとしては、珪酸エチル( $\text{TEOS: Si(OC}_2\text{H}_5)_4$ )、トリメチルシラン( $\text{TMS: (CH}_3)_3\text{SiH}$ )、テトラメチルシクロテトラシロキサン( $\text{TMCTS}$ )、オクタメチルシクロテトラシロキサン( $\text{OMCTS}$ )、ヘキサメチルジシラザン( $\text{HMDS}$ )、トリエトキシシラン( $\text{SiH(OC}_2\text{H}_5)_3$ )、トリスジメチルアミノシラン( $\text{SiH(N(CH}_3)_2)_3$ )等を用いることができる。もちろん、モノシラン、ジシラン、又はトリシラン等の無機シランを用いて、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン、窒化酸化シリコンなどを形成しても良い。

40

【0467】

本実施の形態では、LPCVD法を用いて、酸化シリコンを含む絶縁膜119を形成する。

【0468】

なお、後に形成されるトランジスタ121の、電気的特性のばらつきを抑えるためには、酸化物半導体膜142bの表面は高い平坦性を有していることが望ましい。そして、酸化物半導体膜142bの平坦性を高めるためには、絶縁膜173の表面が高い平坦性が確保していることが望ましい。しかし、絶縁膜173と酸化物半導体膜142bの界面近傍に水素などの不純物が混入するのを防ぐためには、絶縁膜173を形成した後、絶縁膜173を大気にさらすことなく、連続的に酸化物半導体膜142bを形成することが望ましい

50

。よって、本実施の形態では、絶縁膜 173 の下に位置する絶縁膜 119 の表面に平坦化処理を施しておく。上記構成により、絶縁膜 173 の表面に平坦化処理を施さなくとも、絶縁膜 173 の表面の平坦性を確保することができる。そして、絶縁膜 173 の表面の平坦性を確保しつつ、絶縁膜 173 と酸化物半導体膜 142b の連続成膜を実現することができる。

#### 【0469】

絶縁膜 119 の平坦化処理は、化学的機械研磨法 (Chemical Mechanical Polishing: CMP 法)、液体ジェット研磨法等の研磨処理、ドライエッチング又はウェットエッチング等のエッチング処理、または研磨処理とエッチング処理を組み合わせで行うことができる。

10

#### 【0470】

本実施の形態では、CMP 法を用いて、絶縁膜 119 に平坦化処理を施す場合について説明する。絶縁膜 119 の平坦化処理は、例えば、ポリウレタン地の研磨布を用い、スラリーはシリカ系スラリー (粒径 60 nm)、スラリー流量 100 ml/min 以上 500 ml/min 以下、研磨圧 0.005 MPa 以上 0.08 MPa 以下、スピンドル回転数 20 rpm 以上 50 rpm 以下、テーブル回転数 20 rpm 以上 50 rpm 以下で行うことができる。

#### 【0471】

本実施の形態では、上記 CMP 法による研磨後の絶縁膜 119 の膜厚を、300 nm とする。

20

#### 【0472】

また、絶縁膜 173 は、スパッタ法、CVD 法等により形成する。絶縁膜 173 は、熱が与えられることにより酸素が脱離する絶縁膜であることが好ましい。熱が与えられることにより酸素が脱離する絶縁膜としては、化学量論的組成比を満たす酸素よりも多くの酸素を含む絶縁膜を用いることが好ましい。熱が与えられることにより酸素が脱離する絶縁膜は、加熱処理の際に、酸素が脱離することにより、後に形成される酸化物半導体膜に酸素を拡散 (又は供給) させることができる。絶縁膜 173 として、例えば、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム等を用いることができる。スパッタ法を用いて絶縁膜 173 を形成することにより、熱が与えられることにより酸素が脱離しやすい絶縁膜とすることができるため、好ましい。絶縁膜 173 は、単数の絶縁膜で構成されていても良いし、積層された複数の絶縁膜で構成されていても良い。

30

#### 【0473】

絶縁膜 173 は、50 nm 以上 800 nm 以下、好ましくは 200 nm 以上 500 nm 以下とする。絶縁膜 173 を厚く形成することで、絶縁膜 173 から放出される酸素の量を増加させることができると共に、絶縁膜 173 及び後に形成される酸化物半導体膜 142b との界面における界面準位を低減することが可能である。

#### 【0474】

本実施の形態では、スパッタ法を用いて形成した、膜厚 200 nm の酸化シリコン膜を、絶縁膜 173 として用いる。絶縁膜 173 をスパッタ法により形成する場合は、成膜ガスとして、酸素ガス、又は酸素及び希ガスの混合ガス等を用いることができる。また、成膜ガス中の酸素量を高くすることにより、絶縁膜 173 に含まれる酸素の量を増加させることができるため、好ましい。代表的には、成膜ガス中の酸素濃度を 6% 以上 100% 以下にするとよい。

40

#### 【0475】

絶縁膜 173 として、酸化シリコン膜を形成する場合、石英 (好ましくは合成石英) をターゲットに用い、基板温度 300 °C 以上 450 °C 以下 (好ましくは 700 °C 以上 2000 °C 以下)、ターゲットと基板の間の距離 (T-S 間距離) を 20 mm 以上 400 mm 以下 (好ましくは 40 mm 以上 200 mm 以下)、圧力を 0.1 Pa 以上 4 Pa 以下 (好ましくは 0.2 Pa 以上 1.2 Pa 以下)、高周波電源を 0.5 kW 以上 12 kW 以下 (好ましくは

50

1 kW以上5 kW以下)、成膜ガス中の $O_2 / (O_2 + Ar)$ 割合を1%以上100%以下(好ましくは6%以上100%以下)として、RFスパッタ法を用いることが好ましい。なお、石英(好ましくは合成石英)ターゲットに代えてシリコンターゲットを用いることもできる。なお、成膜ガスとしては、酸素のみを用いてもよい。

#### 【0476】

上記酸化物半導体膜142bの膜厚は、2 nm以上200 nm以下、好ましくは3 nm以上50 nm以下、更に好ましくは3 nm以上20 nm以下とする。酸化物半導体膜は、酸化物半導体をターゲットとして用い、スパッタ法により成膜する。また、酸化物半導体膜は、希ガス(例えばアルゴン)雰囲気下、酸素雰囲気下、又は希ガス(例えばアルゴン)及び酸素混合雰囲気下においてスパッタ法により形成することができる。

10

#### 【0477】

なお、酸化物半導体膜をスパッタ法により成膜する前に、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパッタを行い、絶縁膜173の表面に付着している塵埃を除去することが好ましい。逆スパッタとは、ターゲット側に電圧を印加せずに、アルゴン雰囲気下で基板側にRF電源を用いて電圧を印加して基板近傍にプラズマを形成して表面を改質する方法である。なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウムなどを用いてもよい。また、アルゴン雰囲気に酸素、亜酸化窒素などを加えた雰囲気で行ってもよい。また、アルゴン雰囲気に塩素、四フッ化炭素などを加えた雰囲気で行ってもよい。

#### 【0478】

酸化物半導体膜には、上述したような材料を用いることができる。本実施の形態では、In(インジウム)、Ga(ガリウム)、及びZn(亜鉛)を含むターゲットを用いたスパッタ法により得られる膜厚20 nmのIn-Ga-Zn系酸化物半導体の薄膜を、酸化物半導体膜として用いる。上記ターゲットとして、例えば、 $In_2O_3 : Ga_2O_3 : ZnO = 1 : 1 : 1$  [mol数比]の組成比を有するターゲットを用いる。また、 $In_2O_3 : Ga_2O_3 : ZnO = 1 : 1 : 2$  [mol数比]の組成比を有するターゲット、または $In_2O_3 : Ga_2O_3 : ZnO = 1 : 1 : 4$  [mol数比]を有するターゲットを用いることができる。また、In、Ga、及びZnを含むターゲットの充填率は90%以上100%以下、好ましくは95%以上100%未満である。充填率の高いターゲットを用いることにより、成膜した酸化物半導体膜は緻密な膜となる。

20

#### 【0479】

なお、酸化物半導体としてIn-Zn系の材料を用いる場合、用いるターゲットの組成比は、原子数比で、 $In : Zn = 50 : 1 \sim 1 : 2$  (モル数比に換算すると $In_2O_3 : ZnO = 25 : 1 \sim 1 : 4$ )、好ましくは $In : Zn = 20 : 1 \sim 1 : 1$  (モル数比に換算すると $In_2O_3 : ZnO = 10 : 1 \sim 1 : 2$ )、さらに好ましくは $In : Zn = 1.5 : 1 \sim 15 : 1$  (モル数比に換算すると $In_2O_3 : ZnO = 3 : 4 \sim 15 : 2$ )とする。例えば、In-Zn系酸化物半導体の形成に用いるターゲットは、原子数比が $In : Zn : O = X : Y : Z$ のとき、 $Z > 1.5X + Y$ とする。Znの比率を上記範囲に収めることで、移動度の向上を実現することができる。

30

#### 【0480】

また、酸化物半導体としてIn-Sn-Zn系の材料を用いる場合、用いるターゲットの組成比は、 $In : Sn : Zn$ の原子数比を、1 : 2 : 2、2 : 1 : 3、1 : 1 : 1、または4 : 9 : 7とすれば良い。

40

#### 【0481】

本実施の形態では、減圧状態に保持された処理室内に基板を保持し、処理室内の残留水分を除去しつつ水素及び水分が除去されたスパッタガスを導入し、上記ターゲットを用いて酸化物半導体膜を成膜する。成膜時に、基板温度を100 以上600 以下、好ましくは200 以上400 以下としても良い。基板を加熱しながら成膜することにより、成膜した酸化物半導体膜に含まれる不純物濃度を低減することができる。また、スパッタによる損傷が軽減される。処理室内の残留水分を除去するためには、吸着型の真空ポンプを用いることが好ましい。例えば、クライオポンプ、イオンポンプ、チタンサブリメーショ

50

ンポンプを用いることが好ましい。また、排気手段としては、ターボポンプにコールドトラップを加えたものであってもよい。クライオポンプを用いて処理室を排気すると、例えば、水素原子、水 ( $\text{H}_2\text{O}$ ) など水素原子を含む化合物 (より好ましくは炭素原子を含む化合物も) 等が排気されるため、当該処理室で成膜した酸化物半導体膜に含まれる不純物の濃度を低減できる。

【0482】

成膜条件の一例としては、基板とターゲットの間との距離を  $100\text{ mm}$ 、圧力  $0.4\text{ Pa}$ 、直流 (DC) 電源  $0.5\text{ kW}$ 、アルゴンと酸素の流量比が  $30\text{ sccm} / 15\text{ sccm}$  雰囲気下の条件が適用される。なお、パルス直流 (DC) 電源を用いると、成膜時に発生する塵埃が軽減でき、膜厚分布も均一となるために好ましい。

10

【0483】

また、スパッタ装置の処理室のリークレートを  $1 \times 10^{-10}\text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{秒}$  以下とすることで、スパッタ法による成膜途中における酸化物半導体膜への、アルカリ金属、水素化物等の不純物の混入を低減することができる。また、排気系として上述した吸着型の真空ポンプを用いることで、排気系からのアルカリ金属、水素原子、水素分子、水、水酸基、または水素化物等の不純物の逆流を低減することができる。

【0484】

また、ターゲットの純度を、 $99.99\%$  以上とすることで、酸化物半導体膜に混入するアルカリ金属、水素原子、水素分子、水、水酸基、または水素化物等を低減することができる。また、当該ターゲットを用いることで、酸化物半導体膜において、リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属の濃度を低減することができる。

20

【0485】

なお、酸化物半導体膜に水素、水酸基及び水分がなるべく含まれないようにするために、成膜の前処理として、スパッタ装置の予備加熱室で絶縁膜  $173\text{ \AA}$  までが形成された基板  $100$  を予備加熱し、基板  $100$  上に形成された各種絶縁膜及び導電膜に吸着した水分又は水素などの不純物を、脱離し排気することが好ましい。なお、予備加熱の温度は、 $100$  以上  $400$  以下、好ましくは  $150$  以上  $300$  以下である。また、予備加熱室に設ける排気手段はクライオポンプが好ましい。なお、この予備加熱の処理は省略することもできる。また、この予備加熱は、後に行われる絶縁膜  $143\text{ \AA}$  の形成前にも同様に行ってもよい。

30

【0486】

なお、スパッタ等で成膜された酸化物半導体膜中には、不純物としての水分又は水素 (水酸基を含む) が多量に含まれていることがある。水分又は水素はドナー準位を形成しやすいため、酸化物半導体にとっては不純物である。そこで、本発明の一態様では、酸化物半導体膜  $142\text{ b}$  中の水分又は水素などの不純物を低減 (脱水化または脱水素化) するために、酸化物半導体膜  $142\text{ b}$  に対して、減圧雰囲気下、窒素や希ガスなどの不活性ガス雰囲気下、酸素ガス雰囲気下、又は超乾燥エア (CRDS (キャピティリングダウンレーザ一分光法) 方式の露点計を用いて測定した場合の水分量が  $20\text{ ppm}$  (露点換算で  $-55$ ) 以下、好ましくは  $1\text{ ppm}$  以下、好ましくは  $10\text{ ppb}$  以下の空気) 雰囲気下で、酸化物半導体膜  $142\text{ b}$  に加熱処理を施す。

40

【0487】

酸化物半導体膜  $142\text{ b}$  に加熱処理を施すことで、酸化物半導体膜  $142\text{ b}$  中の水分又は水素を脱離させることができる。具体的には、 $250$  以上  $750$  以下、好ましくは  $400$  以上基板の歪み点未満の温度で加熱処理を行えば良い。例えば、 $500$ 、3分間以上6分間以下程度で行えばよい。加熱処理にRTA法を用いれば、短時間に脱水化又は脱水素化が行えるため、ガラス基板の歪点を越える温度でも処理することができる。

【0488】

本実施の形態では、加熱処理装置の一つである電気炉を用いる。

【0489】

なお、加熱処理装置は電気炉に限られず、抵抗発熱体などの発熱体からの熱伝導又は熱輻

50

射によって、被処理物を加熱する装置を備えていてもよい。例えば、GRTA (Gas Rapid Thermal Anneal) 装置、LRTA (Lamp Rapid Thermal Anneal) 装置等のRTA (Rapid Thermal Anneal) 装置を用いることができる。LRTA装置は、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧水銀ランプなどのランプから発する光(電磁波)の輻射により、被処理物を加熱する装置である。GRTA装置は、高温のガスを用いて加熱処理を行う装置である。気体には、アルゴンなどの希ガス、又は窒素のような、加熱処理によって被処理物と反応しない不活性気体が用いられる。

#### 【0490】

10

加熱処理においては、窒素、又はヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスに、水分又は水素などが含まれないことが好ましい。又は、加熱処理装置に導入する窒素、又はヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの純度を、6N(99.9999%)以上、好ましくは7N(99.99999%)以上、(即ち不純物濃度を1ppm以下、好ましくは0.1ppm以下)とすることが好ましい。

#### 【0491】

以上の工程により、酸化物半導体膜142b中の水素の濃度を低減することができる。また、当該水素濃度が低減された酸化物半導体膜を用いることで、耐圧性が高く、オフ電流の著しく小さいトランジスタを作製することができる。上記加熱処理は、酸化物半導体膜142bの成膜以降であれば、いつでも行うことができる。

20

#### 【0492】

なお、酸化物半導体膜142bは非晶質であっても良いが、結晶性を有していても良い。結晶性を有する酸化物半導体膜としては、c軸配向し、かつab面、表面または界面の方向から見て三角形または六角形状の原子配列を有し、c軸においては金属原子が層状または金属原子と酸素原子とが層状に配列しており、ab面においてはa軸またはb軸の向きが異なる(c軸を中心に回転した)結晶を含む結晶性酸化物半導体(C Axis Aligned Crystalline Oxide Semiconductor: CAAC-OSとも呼ぶ)であっても、トランジスタの信頼性を高めるという効果を得ることができるので、好ましい。

#### 【0493】

30

次いで、図43(C)に示すように、エッチング等により、酸化物半導体膜142bと、絶縁膜173の形状を加工することで、島状の酸化物半導体膜142と、後に形成される絶縁膜140の一部である第3の酸化絶縁膜140cが形成される。第3の酸化絶縁膜140cは、島状の酸化物半導体膜142と重なる領域以外が、部分的にエッチングされている。

#### 【0494】

なお、酸化物半導体膜142を形成するためのエッチングは、ドライエッチングでもウェットエッチングでもよく、両方を用いてもよい。ドライエッチングに用いるエッチングガスとしては、塩素を含むガス(塩素系ガス、例えば塩素( $\text{Cl}_2$ )、三塩化硼素( $\text{BCl}_3$ )、四塩化シリコン( $\text{SiCl}_4$ )、四塩化炭素( $\text{CCl}_4$ )など)が好ましい。また、フッ素を含むガス(フッ素系ガス、例えば四弗化炭素( $\text{CF}_4$ )、六弗化硫黄( $\text{SF}_6$ )、三弗化窒素( $\text{NF}_3$ )、トリフルオロメタン( $\text{CHF}_3$ )など)、臭化水素( $\text{HBr}$ )、酸素( $\text{O}_2$ )、これらのガスにヘリウム( $\text{He}$ )やアルゴン( $\text{Ar}$ )などの希ガスを添加したガス、などを用いることができる。

40

#### 【0495】

ドライエッチング法としては、平行平板型RIE (Reactive Ion Etching) 法や、ICP (Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ) エッチング法を用いることができる。所望の形状にエッチングできるように、エッチング条件(コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電力量、基板側の電極温度等)を適宜調節する。

50

## 【0496】

ウェットエッチングに用いるエッチング液として、燐酸と酢酸と硝酸を混ぜた溶液、クエン酸やシュウ酸などの有機酸を用いることができる。

## 【0497】

酸化物半導体膜142を形成するためのレジストマスクをインクジェット法で形成してもよい。レジストマスクをインクジェット法で形成するとフォトマスクを使用しないため、製造コストを低減できる。

## 【0498】

なお、次工程の導電膜を形成する前に逆スパッタを行い、酸化物半導体膜142b及び絶縁膜173の表面に付着しているレジスト残渣などを除去することが好ましい。

10

## 【0499】

本実施の形態では、酸化物半導体膜142b及び絶縁膜173の形状の加工を、ドライエッチングで行う。例えば、ドライエッチングの条件として、例えば、 $ICP/Bias = 45/100W$ 、圧力 $1.9Pa$ 、エッチングガスは、 $BCl_3$ 及び $Cl_2$ の混合ガスとし、流量比は、 $BCl_3/Cl_2 = 60sccm/20sccm$ とする。このような条件を採用することにより、島状の酸化物半導体膜142を形成した後、絶縁膜173から第3の酸化絶縁膜140cを形成することができる。エッチングの際に、水素を含む不純物が含まれないように行うことが望ましい。

## 【0500】

なお、酸化物半導体膜142をドライエッチングで形成する場合、酸化物半導体膜142の側面近傍、すなわち端部が、塩素ラジカル、フッ素ラジカル等を含むプラズマに曝されると、酸化物半導体膜142の端部に露出する金属原子と、塩素ラジカル、フッ素ラジカル等とが結合する。このとき、金属原子と塩素原子、フッ素原子が結合して脱離するため、酸化物半導体膜142中に当該金属原子と結合していた酸素原子が活性となる。活性となった酸素原子は容易に反応し、脱離しやすい。そのため、酸化物半導体膜142の端部には酸素欠損が生じやすい。

20

## 【0501】

エッチング工程により露出された酸化物半導体膜の端部が活性であると、減圧雰囲気または還元雰囲気、更には減圧雰囲気での加熱処理において、酸素を引き抜かれ、該酸化物半導体膜の端部で酸素欠損を生じる。当該酸素欠損の一部はドナーとなり、キャリアである電子を生成するため、該酸化物半導体膜142の端部はn型化する。

30

## 【0502】

後に形成される導電膜145及び導電膜146が、n型化した酸化物半導体膜142の端部と接する場合、当該端部を介して、導電膜145と導電膜146の間にリーク電流が発生してしまう。当該リーク電流は、トランジスタのオフ電流の上昇の原因となる。

## 【0503】

次いで、図44(A)に示すように、第3の酸化絶縁膜140c及び酸化物半導体膜142上に、絶縁膜174及び絶縁膜175を形成する。絶縁膜174は、絶縁膜173と同様に、熱が与えられることにより酸素が脱離する絶縁膜を用いて形成することが好ましい。また、絶縁膜175は、酸素の拡散を防ぐ絶縁膜で形成する。絶縁膜175の一例として、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム等がある。

40

## 【0504】

絶縁膜174及び絶縁膜175の成膜方法は、絶縁膜173と同様の成膜方法を適宜選択することができる。なお、絶縁膜174及び絶縁膜175を成膜する際に、酸化物半導体膜142の端部から酸素の脱離量を低減するため、絶縁膜174及び絶縁膜175の成膜温度は、可能な限り低い温度、好ましくは室温で成膜することが望ましい。

## 【0505】

酸化物半導体膜142の端部に酸素欠損が生じたとしても、熱が与えられることにより酸素が脱離する絶縁膜174が酸化物半導体膜142の端部に接しており、なおかつ酸素の拡散を防ぐ絶縁膜175が絶縁膜174を間に挟んで酸化物半導体膜142の端部と重な

50

っていることにより、後の加熱処理にて絶縁膜 174 から酸化物半導体膜 142 の端部に酸素を供給することができる。よって、酸化物半導体膜 142 の端部における酸素欠損を低減することができる。

#### 【0506】

本実施の形態では、絶縁膜 174 として膜厚 20 nm 程度の酸化シリコン膜を用い、絶縁膜 175 として膜厚 100 nm 程度の酸化アルミニウム膜を用いる。

#### 【0507】

次いで、図 44 (B) に示すように、絶縁膜 175 に平坦化処理を施すことにより、絶縁膜 175 から第 2 の酸化絶縁膜 140 b を形成する。平坦化処理は、化学的機械研磨法 (Chemical Mechanical Polishing: CMP 法)、液体ジェット研磨法等の研磨処理、ドライエッチング又はウェットエッチング等のエッチング処理、または研磨処理とエッチング処理を組み合わせで行うことができる。本実施の形態では、CMP 法を用いて、絶縁膜 175 に平坦化処理を施す。絶縁膜 175 の平坦化処理は、絶縁膜 174 が露出するまで行う。なお、酸化物半導体膜 142 の膜厚が数 nm ~ 数十 nm と薄い場合、酸化物半導体膜 142 が、平坦化処理によって除去されないようにすることが望ましい。

#### 【0508】

絶縁膜 175 に CMP 法を施す条件は、例えば、ポリウレタン地の研磨布を用い、スラリーはシリカ系スラリー (粒径 60 nm)、スラリー流量 100 ml/min 以上 500 ml/min 以下、研磨圧 0.005 MPa 以上 0.08 MPa 以下、スピンドル回転数 20 rpm 以上 50 rpm 以下、テーブル回転数 20 rpm 以上 50 rpm 以下とする。

#### 【0509】

次いで、図 44 (C) に示すように、絶縁膜 174 の露出した箇所を除去して、酸化物半導体膜 142 の表面を露出させる。上記工程により、絶縁膜 174 から第 1 の酸化絶縁膜 140 a を形成する。絶縁膜 174 の除去は、エッチング処理を用いて行う。但し、酸化物半導体膜 142 に対して絶縁膜 174 の選択比が高いエッチング条件を採用することが必要である。絶縁膜 174 の露出した箇所を除去した後、酸化物半導体膜 142 の表面を平坦にしておくことで、後に形成されるトランジスタ 121 の電気的特性を向上させることができる。

#### 【0510】

ドライエッチングの条件として、例えば、ICP/Bias = 500/50 W、圧力 1.5 Pa、エッチングガスは、CF<sub>4</sub> 及び O<sub>2</sub> の混合ガスとし、流量比は、CF<sub>4</sub>/O<sub>2</sub> = 70/30 sccm とする。このような条件を採用することにより、絶縁膜 174 を選択的に除去して第 1 の酸化絶縁膜 140 a を形成することができる。また、酸化物半導体膜 142 が除去されてしまうことを抑制することができる。エッチングの際に、水素を含む不純物が含まれないように行うことが望ましい。

#### 【0511】

第 1 の酸化絶縁膜 140 a を形成した後、加熱処理を行ってもよい。加熱処理を行うことで、酸化物半導体膜 142 中の水素を含む不純物を除去することができる。また、第 1 の酸化絶縁膜 140 a、第 3 の酸化絶縁膜 140 c から酸素が脱離することにより、酸化物半導体膜 142 の端部と下部に酸素を供給することができ、酸素欠損を低減することができる。

#### 【0512】

次いで、図 45 (A) に示すように、第 1 の酸化絶縁膜 140 a、第 2 の酸化絶縁膜 140 b、及び酸化物半導体膜 142 を覆うように、絶縁膜 143 a、導電膜 144 a、絶縁膜 151 a を、順に積層するように形成する。

#### 【0513】

絶縁膜 143 a 及び絶縁膜 151 a は、ゲート絶縁膜 104 n またはゲート絶縁膜 104 p と同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。なお、後にゲート絶縁膜 143 となる絶縁膜 143 a は、水分や、水素などの不純物を極力含まないことが

10

20

30

40

50

望ましく、単層の絶縁膜であっても良いし、積層された複数の絶縁膜で構成されていても良い。ゲート絶縁膜 1 4 3 に水素が含まれると、その水素が酸化物半導体膜 1 4 2 へ侵入し、又は水素が酸化物半導体膜 1 4 2 中の酸素を引き抜き、酸化物半導体膜 1 4 2 が低抵抗化（*n*型化）してしまい、寄生チャネルが形成されるおそれがある。よって、ゲート絶縁膜 1 4 3 はできるだけ水素を含まない膜になるように、成膜方法に水素を用いないことが重要である。上記ゲート絶縁膜 1 4 3 には、バリア性の高い材料を用いるのが望ましい。例えば、バリア性の高い絶縁膜として、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、窒化アルミニウム膜、又は窒化酸化アルミニウム膜などを用いることができる。複数の積層された絶縁膜を用いる場合、窒素の含有比率が低い酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜などの絶縁膜を、上記バリア性の高い絶縁膜よりも、酸化物半導体膜 1 4 2 に近い側に形成する。そして、窒素の含有比率が低い絶縁膜を間に挟んで酸化物半導体膜 1 4 2 と重なるように、バリア性の高い絶縁膜を形成する。バリア性の高い絶縁膜を用いることで、酸化物半導体膜 1 4 2 内、ゲート絶縁膜 1 4 3 内、或いは、酸化物半導体膜 1 4 2 と他の絶縁膜の界面とその近傍に、水分又は水素などの不純物が入り込むのを防ぐことができる。また、酸化物半導体膜 1 4 2 に接するように窒素の比率が低い酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜などの絶縁膜を形成することで、バリア性の高い材料を用いた絶縁膜が酸化物半導体膜 1 4 2 に直接接するのを防ぐことができる。

10

**【0514】**

本実施の形態では、プラズマ CVD 法で形成された膜厚 20 nm の酸化窒化シリコン膜を絶縁膜 1 4 3 a として用い、スパッタ法で形成された膜厚 100 nm の酸化シリコン膜を絶縁膜 1 5 1 a として用いる。

20

**【0515】**

なお、絶縁膜 1 4 3 a を形成した後に、加熱処理を施しても良い。加熱処理は、窒素、超乾燥空気、又は希ガス（アルゴン、ヘリウムなど）の雰囲気下において、好ましくは 200 以上 400 以下、例えば 250 以上 350 以下で行う。上記ガスは、水の含有量が 20 ppm 以下、好ましくは 1 ppm 以下、より好ましくは 10 ppb 以下であることが望ましい。

**【0516】**

また、酸素雰囲気下で酸化物半導体膜 1 4 2 に加熱処理を施すことで、酸化物半導体に酸素を添加し、酸化物半導体膜 1 4 2 中においてドナーとなる酸素欠損を低減させても良い。加熱処理の温度は、例えば 100 以上 350 未満、好ましくは 150 以上 250 未満で行う。上記酸素雰囲気下の加熱処理に用いられる酸素ガスには、水、水素などが含まれないことが好ましい。又は、加熱処理装置に導入する酸素ガスの純度を、6N（99.9999%）以上、好ましくは 7N（99.99999%）以上、（即ち酸素中の不純物濃度を 1 ppm 以下、好ましくは 0.1 ppm 以下）とすることが好ましい。

30

**【0517】**

或いは、イオン注入法又はイオンドーピング法などを用いて、酸化物半導体膜 1 4 2 に酸素を添加することで、ドナーとなる酸素欠損を低減させても良い。例えば、2.45 GHz のマイクロ波でプラズマ化した酸素を酸化物半導体膜 1 4 2 に添加すれば良い。

**【0518】**

導電膜 1 4 4 a は、スパッタ法や真空蒸着法で形成することができる。導電膜 1 4 4 a となる導電膜は、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた元素、又は上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜等が挙げられる。また、アルミニウム、銅などの金属膜の下側もしくは上側にクロム、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンなどの高融点金属膜を積層させた構成としても良い。また、アルミニウム又は銅は、耐熱性や腐食性の問題を回避するために、高融点金属材料と組み合わせると良い。高融点金属材料としては、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、ネオジム、スカンジウム、イットリウム等を用いることができる。

40

**【0519】**

50

また、導電膜 1 4 4 a となる導電膜は、単層構造でも、2 層以上の積層構造としてもよい。導電膜 1 4 4 a は、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた元素、又は上述した元素を成分とする合金膜か、上述した元素を組み合わせた合金膜等を用いることができる。また、アルミニウム、銅などの金属膜の下側もしくは上側にクロム、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンなどの高融点金属膜を積層させた構成としても良い。また、アルミニウム又は銅は、耐熱性や腐食性の問題を回避するために、高融点金属材料と組み合わせて用いると良い。高融点金属材料としては、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、ネオジウム、スカンジウム、イットリウム等を用いることができる。また、Cu - Mg - Al 合金、Mo - Ti 合金、Ti、Mo、は、酸化膜との密着性が高い。よって、絶縁膜 1 4 3 a が酸化物である場合、絶縁膜 1 4 3 a 上の導電膜 1 4 4 a に、上述した酸化膜との密着性が高い材料を用いることが望ましい。例えば、導電膜 1 4 4 a として、下層に Cu - Mg - Al 合金、Mo - Ti 合金、Ti、或いは Mo で構成される導電膜、上層に抵抗値の低い Cu で構成される導電膜を積層して用いることで、酸化物である絶縁膜 1 4 3 a との密着性を高め、なおかつ、抵抗値を下げるることができる。

10

#### 【0520】

また、導電膜 1 4 4 a となる導電膜としては、導電性の金属酸化物で形成しても良い。導電性の金属酸化物としては酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム酸化スズ混合物、酸化インジウム酸化亜鉛混合物又は前記金属酸化物材料にシリコン若しくは酸化シリコンを含ませたものを用いることができる。

20

#### 【0521】

導電膜形成後に加熱処理を行う場合には、この加熱処理に耐える耐熱性を導電膜に持たせることが好ましい。

#### 【0522】

本実施の形態では、膜厚 30 nm の窒化タンタル膜上に、膜厚 135 nm のタングステン膜を積層させ、導電膜 1 4 4 a として用いる。

#### 【0523】

次に、絶縁膜 1 5 1 a 上にマスクを形成し、導電膜 1 4 4 a 及び絶縁膜 1 5 1 a をエッチングすることで、図 4 5 ( B ) に示すように、ゲート電極 1 4 4、及びゲート電極 1 4 4 上の絶縁膜 1 5 1 を形成する。

30

#### 【0524】

導電膜 1 4 4 a 及び絶縁膜 1 5 1 a のエッチングには、ウェットエッチングまたはドライエッチングを用いることができ、ウェットエッチングとドライエッチングを組み合わせる用いてもよい。導電膜 1 4 4 a 及び絶縁膜 1 5 1 a を所望の形状にエッチングできるよう、材料に合わせてエッチング条件（エッチングガスやエッチング液、エッチング時間、温度等）を適宜設定する。ただし、トランジスタ 1 2 1 のチャネル長（L）を微細に加工するためには、ドライエッチングを用いることが好ましい。

#### 【0525】

絶縁膜 1 5 1 a のエッチング用ガスとしては、例えば、六フッ化硫黄（ $\text{SF}_6$ ）、三フッ化窒素（ $\text{NF}_3$ ）、トリフルオロメタン（ $\text{CHF}_3$ ）などのフッ素を含むガス、又は、四フッ化炭素（ $\text{CF}_4$ ）と水素の混合ガス等を用いることができ、希ガス（ヘリウム（He）、アルゴン（Ar）、キセノン（Xe））、一酸化炭素、又は二酸化炭素等を添加しても良い。また、導電膜 1 4 4 a のエッチング用ガスとしては、塩素、塩化硼素、塩化シリコン、四塩化炭素などの塩素系ガス、四弗化炭素、弗化硫黄、弗化窒素などのフッ素系ガス、または酸素などを適宜用いることができる。

40

#### 【0526】

次に、図 4 5 ( C ) に示すように、ゲート電極 1 4 4 及び絶縁膜 1 5 1 をマスクとして酸化化物半導体膜 1 4 2 にドーパントを添加することで、ゲート電極 1 4 4 と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第 1 の領域 1 4 7 と、ソースまたはドレインとして機能し、第 1 の領域 1 4 7 を挟む第 2 の領域 1 4 8 及び第 2 の領域 1 4 9 とを形成

50

する。

#### 【0527】

酸化物半導体膜142にドーパントを添加する方法として、イオンドーピング法またはイオンインプランテーション法を用いることができる。また、添加するドーパントは、例えばヘリウム、アルゴン、キセノンなどの希ガスや、窒素、リン、ヒ素、アンチモンなどの15族原子などを少なくとも一つ用いることができる。

#### 【0528】

例えば、窒素をドーパントとして用いた場合、第2の領域148及び第2の領域149中の窒素原子の濃度は、 $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以上 $1 \times 10^{22} / \text{cm}^3$ 以下であることが望ましい。

10

#### 【0529】

さらに、上記ドーパントの添加はイオンドーピング法またはイオンインプランテーション法以外の方法でも行うことができる。例えば、添加する元素を含むガス雰囲気にてプラズマを発生させて、被添加物に対してプラズマ処理を行うことによって、ドーパントを添加することができる。上記プラズマを発生させる装置としては、ドライエッチング装置やプラズマCVD装置、高密度プラズマCVD装置などを用いることができる。

#### 【0530】

ドーピングの条件として、例えば、ドーパントが窒素の場合、加速電圧を20kVとして行う。また、ドーパントがリンの場合、加速電圧を40kVとして行う。窒素又はリンのドーズ量が $1 \times 10^{14} / \text{cm}^2$ 以下の場合、450 未満で熱処理を行うことが好ましい。これにより、ドーパントを含む第2の領域148及び第2の領域149におけるシート抵抗を $1 \times 10^7 / \text{sq}$ 以下とすることができる。また、ドーズ量が $5 \times 10^{14} / \text{cm}^2$ 以上 $5 \times 10^{15} / \text{cm}^2$ 未満の場合、450 以上600 以下で熱処理を行うことが好ましい。これにより、第2の領域148及び第2の領域149においてシート抵抗を $1 \times 10^5 / \text{sq}$ 以下とすることができる。さらに、ドーズ量が $5 \times 10^{15} / \text{cm}^2$ 以上の場合、600 以上で熱処理を行うことがこのましい。これにより、ドーパントを含む第2の領域148及び第2の領域149においてシート抵抗を $1 \times 10^5 / \text{sq}$ 以下とすることができる。

20

#### 【0531】

第2の領域148及び第2の領域149において、シート抵抗を低減することにより、第2の領域148及び第2の領域149と、後に形成される導電膜145及び導電膜146の間の抵抗を低減することができる。よって、トランジスタ121の微細化を進めても、高いオン電流と、高速動作を確保することができる。また、トランジスタ121の微細化により、記憶装置の単位面積あたりの記憶容量を高めることができる。

30

#### 【0532】

次に、絶縁膜143a、ゲート電極144、及び絶縁膜151等を覆うように絶縁膜を形成した後、当該絶縁膜及び絶縁膜143aの形状をエッチング等により加工する。上記工程により、図46(A)に示すように、当該絶縁膜からゲート電極144の側部に設けられたサイドウォール150が形成され、絶縁膜143aからゲート電極144及びサイドウォール150の下部に設けられたゲート絶縁膜143が形成される。サイドウォール150となる絶縁膜は、絶縁膜173と同様の材料及び成膜方法を用いて形成することができる。例えば、窒化シリコン膜上に酸化シリコン膜が成膜された積層構造を採用することもできる。本実施の形態では、サイドウォール150となる絶縁膜を、酸化シリコン膜で形成する。

40

#### 【0533】

次に、加熱処理を行ってもよい。当該加熱処理の温度は、代表的には、150 以上450 以下、好ましくは250 以上325 以下とする。または、250 から325 まで徐々に温度上昇させながら加熱してもよい。

#### 【0534】

加熱処理を行うことにより、酸化物半導体膜142に接している絶縁膜から酸化物半導体

50

膜 1 4 2 に酸素が拡散し、酸化物半導体膜 1 4 2 の絶縁膜に接する面とその近傍における酸素欠損を低減することができる。また、ドーパントを含む第 2 の領域 1 4 8 及び第 2 の領域 1 4 9 の抵抗を低減することができる。

#### 【0535】

次いで、導電膜を形成し、当該導電膜の形状をエッチング等により加工することで、図 4 6 ( B ) に示すように、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 と、導電膜 1 5 3 とを形成する。導電膜 1 4 5 は第 2 の領域 1 4 8 に接しており、導電膜 1 4 6 は第 2 の領域 1 4 9 に接している。また、導電膜 1 5 3 は、第 2 の酸化絶縁膜 1 4 0 b 上に形成されている。導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 と、導電膜 1 5 3 とは、導電膜 1 4 4 a と同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。

10

#### 【0536】

導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 と、導電膜 1 5 3 とを形成するためのエッチングには、ウェットエッチングまたはドライエッチングを用いることができる。上記エッチングに、ウェットエッチングとドライエッチングを組み合わせる用いてもよい。導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 と、導電膜 1 5 3 とを所望の形状にエッチングできるよう、材料に合わせてエッチング条件（エッチングガスやエッチング液、エッチング時間、温度等）を適宜設定する。ただし、トランジスタを微細に加工するためには、ドライエッチングを用いるのが好ましい。ドライエッチングに用いるエッチングガスとしては、例えば、六フッ化硫黄（ $\text{SF}_6$ ）、三フッ化窒素（ $\text{NF}_3$ ）、トリフルオロメタン（ $\text{CHF}_3$ ）などのフッ素を含むガス、又は、四フッ化炭素（ $\text{CF}_4$ ）と水素の混合ガス等を用いることができ、希ガス（ヘリウム（ $\text{He}$ ）、アルゴン（ $\text{Ar}$ ）、キセノン（ $\text{Xe}$ ））、一酸化炭素、又は二酸化炭素等を添加しても良い。

20

#### 【0537】

本実施の形態では、膜厚 100 nm 程度のタンゲステン膜を、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 と、導電膜 1 5 3 として用いる。導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 と、導電膜 1 5 3 としてタンゲステン膜を用いる場合のエッチング条件として、例えば、 $\text{ICP/Bias} = 500 / 150 \text{ W}$ 、圧力 1.0 Pa、エッチングガスは、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{Cl}_2$ 、及び  $\text{O}_2$  の混合ガスとし、流量比は、 $\text{CF}_4 / \text{Cl}_2 / \text{O}_2 = 25 / 25 / 10 \text{ sccm}$  とすれば良い。

#### 【0538】

なお、本実施の形態では、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 を、サイドウォール 1 5 0 に接して設ける。上記構成により、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 を形成するためのマスクに多少位置ずれが生じたとしても、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 と酸化物半導体膜 1 4 2 との接する面積が、変動するのを防ぐことができる。よって、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 の位置がずれることによる、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 と酸化物半導体膜 1 4 2 との間の抵抗の変動を抑制し、トランジスタ 1 2 1 のオン電流の変動を防ぐことができる。さらに、導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 を形成するためのエッチングの際に、酸化物半導体膜 1 4 2 がエッチングガスに曝されにくいため、好ましい。

30

#### 【0539】

以上の工程により、トランジスタ 1 2 1 を作製することができる。

40

#### 【0540】

次に、図 4 7 ( A ) に示すように、第 2 の酸化絶縁膜 1 4 0 b、導電膜 1 4 5、導電膜 1 4 6、導電膜 1 5 3、サイドウォール 1 5 0、及び絶縁膜 1 5 1 上に、絶縁膜 1 5 4 を形成した後、エッチング等により絶縁膜 1 5 4 に開口部を形成し、導電膜 1 4 6 の一部を露出させる。その後、絶縁膜 1 5 4 上において、導電膜 1 5 3 と重なる位置に導電膜 1 5 5 を、また、開口部において導電膜 1 4 6 と接する導電膜 1 5 6 を、形成する。

#### 【0541】

絶縁膜 1 5 4 は、酸化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化タンタル等の無機絶縁材料を含む材料を用いて形成することができる。また、ポリイミド、アクリル等の有機絶縁材料を用いて形成することも可能である。

50

## 【0542】

本実施の形態では、絶縁膜154を、スパッタ法で形成された膜厚50nmの酸化アルミニウム膜と、プラズマCVD法で形成された膜厚300nmの酸化窒化シリコン膜とを、順に積層させた構造を有している。なお、絶縁膜154は、単層の絶縁膜で構成されていても良いし、3層以上の積層された絶縁膜で構成されていても良い。

## 【0543】

導電膜155及び導電膜156は、導電膜144aと同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。本実施の形態では、膜厚20nmのチタン膜と、膜厚50nmのタンゲステン膜と、膜厚200nmのアルミニウム膜と、膜厚5nmのチタン膜とが順に積層された構造を有する導電膜155及び導電膜156を、スパッタ法にて形成する。

10

## 【0544】

以上の工程により、容量素子136を作製することができる。

## 【0545】

次いで、図47(B)に示すように、導電膜155及び導電膜156と、絶縁膜154とを覆うように、絶縁膜160を形成した後、絶縁膜160にエッチング等により開口部を形成することで、導電膜156の一部を露出させる。次いで、開口部において導電膜156と接する導電膜158を、絶縁膜160上に形成する。

## 【0546】

絶縁膜160はその表面が平坦化されていることが望ましい。絶縁膜160は、酸化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化タンタル等の無機絶縁材料を含む材料を用いて形成することができる。また、絶縁膜160は、ポリイミド、アクリル等の有機絶縁材料を用いて形成することも可能である。本実施の形態では、膜厚1500nmのポリイミド膜を、絶縁膜160として用いる。

20

## 【0547】

導電膜158は、導電膜144aと同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。本実施の形態では、膜厚20nmのチタン膜と、膜厚50nmのタンゲステン膜と、膜厚300nmのアルミニウム膜と、膜厚5nmのチタン膜とが順に積層された構造を有する導電膜158を、スパッタ法にて形成する。

## 【0548】

以上の工程により、図47(B)に示すような、本発明の一態様に係る半導体装置を作製することができる。

30

## 【0549】

なお、本実施の形態では、ゲート電極144及び絶縁膜151をマスクとして酸化物半導体膜142にドーパントを添加しているが、酸化物半導体膜142へのドーパントの添加は、サイドウォール150を形成した後、導電膜145及び導電膜146を形成する前に行っても良い。

## 【0550】

本実施の形態は、上記実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。

## 【0551】

(実施の形態5)  
本実施の形態では、図36に示す構成をその一部に有する半導体装置の、作製方法の一例について説明する。

40

## 【0552】

ただし、記憶素子が有するnチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pは、シリコンの他、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、単結晶炭化シリコンなどの半導体材料を用いていても良い。また、例えば、シリコンを用いたnチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pは、シリコンウェハなどの単結晶半導体基板、SOI法により作製されたシリコン薄膜、気相成長法により作製されたシリコン薄膜などを用いて形成することができる。

50

## 【0553】

なお、nチャネル型トランジスタ102n及びpチャネル型トランジスタ102pの作製方法については、実施の形態4と同様に行うことができる。よって、本実施の形態では、図43(A)に示した工程まで、実施の形態4の説明を参照することができる。

## 【0554】

図43(A)に示した工程まで終了した後、図48(A)に示すように、導電膜106、導電膜107、及び導電膜113を覆うように、絶縁膜171上に絶縁膜119と絶縁膜180とを順に積層するように形成する。

## 【0555】

絶縁膜119の材料、構成及び作製方法については、実施の形態4を参照することができる。また、絶縁膜180の材料、積層構造、及び作製方法は、実施の形態4に記載の絶縁膜173と同様とすることができる。

10

## 【0556】

次いで、図48(B)に示すように、エッチング等により、絶縁膜180の一部を除去することで、凸部を有する第1の酸化絶縁膜120aが形成される。第1の酸化絶縁膜120aは、後に形成される絶縁膜120の一部となる。絶縁膜180のエッチングは、ドライエッチングまたはウェットエッチング、或いはその両方を用いて行うことができる。エッチングの際に、水素を含む不純物が含まれないように行うことが望ましい。

## 【0557】

次いで、図48(C)に示すように、第1の酸化絶縁膜120aを覆うように、絶縁膜181を形成する。絶縁膜181の材料、積層構造、及び作製方法は、実施の形態4に記載の絶縁膜175と同様とすることができる。ただし、絶縁膜181は、第1の酸化絶縁膜120aの凸部の高さよりも、その膜厚が大きくなるように形成する。上記構成により、後の平坦化工程において、平坦性の高い第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120bを形成することができる。

20

## 【0558】

次いで、図49(A)に示すように、絶縁膜181に平坦化処理を施すことにより、絶縁膜181から第2の酸化絶縁膜120bを形成する。上記平坦化処理は、実施の形態4に記載の絶縁膜175に施した平坦化処理と同様に行うことができる。絶縁膜181に平坦化処理を施すことで、第1の酸化絶縁膜120aの凸部が露出する。なお、当該平坦化処理において、第1の酸化絶縁膜120aの凸部が、一部除去されても良い。

30

## 【0559】

次いで、図49(B)に示すように、第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120b上に、島状の酸化物半導体膜122を形成する。酸化物半導体膜122の材料、積層構造、及び作製方法は、実施の形態4に記載の酸化物半導体膜142と同様とすることができる。ただし、酸化物半導体膜122は、後に酸化物半導体膜122内に形成される第1の領域127が上記第1の酸化絶縁膜120aに接するように、なおかつ、後に酸化物半導体膜122内に形成される第2の領域128が第1の酸化絶縁膜120a及び第2の酸化絶縁膜120bに接するように、その形成される位置を定める。

## 【0560】

次いで、図49(C)に示すように、第1の酸化絶縁膜120a、第2の酸化絶縁膜120b、及び酸化物半導体膜122上を覆うように、絶縁膜123a、導電膜124a、絶縁膜131aを、順に積層するように形成する。

40

## 【0561】

絶縁膜123a及び絶縁膜131aは、実施の形態4における絶縁膜143a及び絶縁膜151aと、それぞれ同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。なお、絶縁膜123aを形成した後に、加熱処理を施しても良い。上記加熱処理は、実施の形態4において絶縁膜143aを形成した後に行われる加熱処理と同様の条件で行うことができる。

## 【0562】

50

また、導電膜 1 2 4 a は、実施の形態 4 における導電膜 1 4 4 a と、同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。

【 0 5 6 3 】

次に、絶縁膜 1 3 1 a 上にマスクを形成し、導電膜 1 2 4 a 及び絶縁膜 1 3 1 a をエッチングすることで、図 5 0 ( A ) に示すように、ゲート電極 1 2 4、及びゲート電極 1 2 4 上の絶縁膜 1 3 1 を形成する。導電膜 1 2 4 a 及び絶縁膜 1 3 1 a のエッチングは、実施の形態 4 における導電膜 1 4 4 a 及び絶縁膜 1 5 1 a のエッチングと同様の条件で行うことができる。

【 0 5 6 4 】

次に、図 5 0 ( B ) に示すように、ゲート電極 1 2 4 及び絶縁膜 1 3 1 をマスクとして酸化物半導体膜 1 2 2 にドーパントを添加することで、ゲート電極 1 2 4 と重なり、少なくとも一部がチャネル形成領域として機能する第 1 の領域 1 2 7 と、ソースまたはドレインとして機能し、第 1 の領域 1 2 7 を挟む第 2 の領域 1 2 8 及び第 2 の領域 1 2 9 とを形成する。

【 0 5 6 5 】

酸化物半導体膜 1 2 2 へのドーパントの添加と、その後に行われる加熱処理については、実施の形態 4 における酸化物半導体膜 1 4 2 へのドーパントの添加と加熱処理と同様に行うことができる。上記ドーパントの添加と加熱処理により、第 2 の領域 1 2 8 及び第 2 の領域 1 2 9 において、シート抵抗を低減させることができる。よって、第 2 の領域 1 2 8 及び第 2 の領域 1 2 9 と、後に形成される導電膜 1 2 5 及び導電膜 1 2 6 の間の抵抗を低減することができる。そのため、トランジスタ 1 2 1 の微細化を進めても、高いオン電流と、高速動作を確保することができる。また、トランジスタ 1 2 1 の微細化により、記憶装置の単位面積あたりの記憶容量を高めることができる。

【 0 5 6 6 】

次に、絶縁膜 1 2 3 a、ゲート電極 1 2 4、及び絶縁膜 1 3 1 等を覆うように絶縁膜を形成した後、当該絶縁膜及び絶縁膜 1 2 3 a の形状をエッチング等により加工する。上記工程により、図 5 1 ( A ) に示すように、当該絶縁膜からゲート電極 1 2 4 の側部に設けられたサイドウォール 1 3 0 が形成され、絶縁膜 1 2 3 a からゲート電極 1 2 4 及びサイドウォール 1 3 0 の下部に設けられたゲート絶縁膜 1 2 3 が形成される。サイドウォール 1 3 0 となる絶縁膜は、絶縁膜 1 8 0 と同様の材料、積層構造、及び作製方法を用いて形成することができる。

【 0 5 6 7 】

次に、加熱処理を行ってもよい。当該加熱処理の温度は、代表的には、1 5 0 以上 4 5 0 以下、好ましくは 2 5 0 以上 3 2 5 以下とする。または、2 5 0 から 3 2 5 まで徐々に温度上昇させながら加熱してもよい。

【 0 5 6 8 】

加熱処理を行うことにより、酸化物半導体膜 1 2 2 に接している絶縁膜から酸化物半導体膜 1 2 2 に酸素が拡散し、酸化物半導体膜 1 2 2 の絶縁膜に接する面とその近傍における酸素欠損を低減することができる。また、ドーパントを含む第 2 の領域 1 2 8 及び第 2 の領域 1 2 9 の抵抗を低減することができる。

【 0 5 6 9 】

次いで、導電膜を形成し、当該導電膜の形状をエッチング等により加工することで、図 5 1 ( B ) に示すように、導電膜 1 2 5 及び導電膜 1 2 6 と、導電膜 1 3 3 とを形成する。導電膜 1 2 5 は第 2 の領域 1 2 8 に接しており、導電膜 1 2 6 は第 2 の領域 1 2 9 に接している。また、導電膜 1 3 3 は、第 2 の酸化絶縁膜 1 2 0 b 上に形成されている。導電膜 1 2 5 及び導電膜 1 2 6 と、導電膜 1 3 3 とは、導電膜 1 2 4 a と同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。

【 0 5 7 0 】

導電膜 1 2 5 及び導電膜 1 2 6 と、導電膜 1 3 3 とを形成するためのエッチングは、実施の形態 4 における導電膜 1 4 5 及び導電膜 1 4 6 と、導電膜 1 5 3 とを形成するための工

10

20

30

40

50

ッチングと同様の条件で行うことができる。

【0571】

なお、本実施の形態では、導電膜125及び導電膜126を、サイドウォール130に接して設ける。上記構成により、導電膜125及び導電膜126を形成するためのマスクに多少位置ずれが生じたとしても、導電膜125及び導電膜126と酸化物半導体膜122との接する面積が、変動するのを防ぐことができる。よって、導電膜125及び導電膜126の位置がずれることによる、導電膜125及び導電膜126と酸化物半導体膜122との間の抵抗の変動を抑制し、トランジスタ121のオン電流の変動を防ぐことができる。さらに、導電膜125及び導電膜126を形成するためのエッチングの際に、酸化物半導体膜122がエッチングガスに曝されにくいいため、好ましい。

10

【0572】

以上の工程により、トランジスタ121を作製することができる。

【0573】

次に、図52(A)に示すように、第2の酸化絶縁膜120b、導電膜125、導電膜126、導電膜133、サイドウォール130、及び絶縁膜131上に、絶縁膜134を形成した後、エッチング等により絶縁膜134に開口部を形成し、導電膜126の一部を露出させる。その後、絶縁膜134上において、導電膜133と重なる位置に導電膜135を、また、開口部において導電膜126と接する導電膜186を、形成する。

【0574】

絶縁膜134は、実施の形態4における絶縁膜154と同様の材料、同様の積層構造、同様の作製方法を用いて形成することができる。また、導電膜135及び導電膜186は、導電膜124aと同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。

20

【0575】

以上の工程により、容量素子136を作製することができる。

【0576】

次いで、図52(B)に示すように、導電膜135及び導電膜186と、絶縁膜134とを覆うように、絶縁膜187を形成した後、絶縁膜187にエッチング等により開口部を形成することで、導電膜186の一部を露出させる。次いで、開口部において導電膜186と接する導電膜188を、絶縁膜187上に形成する。

【0577】

絶縁膜187は、実施の形態4における絶縁膜160と同様の材料、同様の積層構造、同様の作製方法を用いて形成することができる。導電膜188は、導電膜124aと同様の材料、同様の積層構造を用いて形成することが可能である。

30

【0578】

以上の工程により、図52(B)に示すような、本発明の一態様に係る半導体装置を作製することができる。

【0579】

なお、本実施の形態では、ゲート電極144及び絶縁膜151をマスクとして酸化物半導体膜142にドーパントを添加しているが、酸化物半導体膜142へのドーパントの添加は、サイドウォール150を形成した後、導電膜145及び導電膜146を形成する前に行っても良い。

40

【0580】

本実施の形態は、上記実施の形態と適宜組み合わせることで実施することが可能である。

【実施例1】

【0581】

本実施例では、In-Sn-Zn系酸化物半導体膜を用いたトランジスタの一例について、図34などを用いて説明する。

【0582】

図34は、コプラナー型であるトップゲート・トップコンタクト構造のトランジスタの上面図および断面図である。図34(A)にトランジスタの上面図を示す。また、図34(B)にトランジスタの断面図を示す。

50

B)は図34(A)の一点鎖線A1-A2に対応する断面図である。

【0583】

図34(B)に示すトランジスタは、基板1500と、基板1500上に設けられた下地絶縁膜1502と、下地絶縁膜1502の周辺に設けられた保護絶縁膜1504と、下地絶縁膜1502および保護絶縁膜1504上に設けられた高抵抗領域1506aおよび低抵抗領域1506bを有する酸化物半導体膜1506と、酸化物半導体膜1506上に設けられたゲート絶縁膜1508と、ゲート絶縁膜1508を介して酸化物半導体膜1506と重畳して設けられたゲート電極1510と、ゲート電極1510の側面と接して設けられた側壁絶縁膜1512と、少なくとも低抵抗領域1506bと接して設けられた一対の電極1514と、少なくとも酸化物半導体膜1506、ゲート電極1510および一対の電極1514を覆って設けられた層間絶縁膜1516と、層間絶縁膜1516に設けられた開口部を介して少なくとも一対の電極1514の一方と接続して設けられた配線1518と、を有する。

10

【0584】

なお、図示しないが、層間絶縁膜1516および配線1518を覆って設けられた保護膜を有していても構わない。該保護膜を設けることで、層間絶縁膜1516の表面伝導に起因して生じる微小リーク電流を低減することができ、トランジスタのオフ電流を小さくすることができる。

【実施例2】

【0585】

本実施例では、上記とは異なるIn-Sn-Zn系酸化物半導体膜を酸化物半導体膜に用いたトランジスタの他の一例について示す。

20

【0586】

図35は、本実施例で作製したトランジスタの構造を示す上面図および断面図である。図35(A)はトランジスタの上面図である。また、図35(B)は図35(A)の一点鎖線B1-B2に対応する断面図である。

【0587】

図35(B)に示すトランジスタは、基板1600と、基板1600上に設けられた下地絶縁膜1602と、下地絶縁膜1602上に設けられた酸化物半導体膜1606と、酸化物半導体膜1606と接する一対の電極1614と、酸化物半導体膜1606および一対の電極1614上に設けられたゲート絶縁膜1608と、ゲート絶縁膜1608を介して酸化物半導体膜1606と重畳して設けられたゲート電極1610と、ゲート絶縁膜1608およびゲート電極1610を覆って設けられた層間絶縁膜1616と、層間絶縁膜1616に設けられた開口部を介して一対の電極1614と接続する配線1618と、層間絶縁膜1616および配線1618を覆って設けられた保護膜1620と、を有する。

30

【0588】

基板1600としてはガラス基板を、下地絶縁膜1602としては酸化シリコン膜を、酸化物半導体膜1606としてはIn-Sn-Zn系酸化物半導体膜を、一対の電極1614としてはタングステン膜を、ゲート絶縁膜1608としては酸化シリコン膜を、ゲート電極1610としては窒化タンタル膜とタングステン膜との積層構造を、層間絶縁膜1616としては酸化窒化シリコン膜とポリイミド膜との積層構造を、配線1618としてはチタン膜、アルミニウム膜、チタン膜がこの順で形成された積層構造を、保護膜1620としてはポリイミド膜を、それぞれ用いた。

40

【0589】

なお、図35(A)に示す構造のトランジスタにおいて、ゲート電極1610と一対の電極1614との重畳する幅をL<sub>ov</sub>と呼ぶ。同様に、酸化物半導体膜1606に対する一対の電極1614のはみ出しをd<sub>W</sub>と呼ぶ。

【実施例3】

【0590】

本発明の一態様に係る半導体装置は、高速動作を確保でき、消費電力を抑えることができ

50

、高集積化を実現できる。高速動作する半導体装置、または高集積化が実現された半導体装置を用いることで、高機能の電子機器を実現することができる。また、低消費電力の半導体装置を用いることで、消費電力の低い電子機器を実現することができる。特に電力の供給を常時受けることが困難な携帯用の電子機器の場合、本発明の一態様に係る消費電力の低い半導体装置をその構成要素に追加することにより、連続使用時間が長くなるといったメリットが得られる。

#### 【0591】

本発明の一態様に係る半導体装置は、表示装置、パーソナルコンピュータ、記録媒体を備えた画像再生装置（代表的にはDVD：Digital Versatile Disc等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを有する装置）に用いることができる。その他に、本発明の一態様に係る半導体装置を用いることができる電子機器として、携帯電話、携帯型を含むゲーム機、携帯情報端末、電子書籍、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオーディオ、デジタルオーディオプレイヤー等）、複写機、ファクシミリ、プリンター、プリンター複合機、現金自動預け入れ払い機（ATM）、自動販売機などが挙げられる。これら電子機器の具体例を図17に示す。

10

#### 【0592】

図17（A）は携帯型ゲーム機であり、筐体7031、筐体7032、表示部7033、表示部7034、マイクロホン7035、スピーカー7036、操作キー7037、スタイラス7038等を有する。本発明の一態様に係る半導体装置は、携帯型ゲーム機の駆動を制御するための集積回路に用いることができる。携帯型ゲーム機の駆動を制御するための集積回路に本発明の一態様に係る半導体装置を用いることで、高機能の携帯型ゲーム機、消費電力の低い携帯型ゲーム機を提供することができる。なお、図17（A）に示した携帯型ゲーム機は、2つの表示部7033と表示部7034とを有しているが、携帯型ゲーム機が有する表示部の数は、これに限定されない。

20

#### 【0593】

図17（B）は携帯電話であり、筐体7041、表示部7042、音声入力部7043、音声出力部7044、操作キー7045、受光部7046等を有する。受光部7046において受信した光を電気信号に変換することで、外部の画像を取り込むことができる。本発明の一態様に係る半導体装置は、携帯電話の駆動を制御するための集積回路に用いることができる。携帯電話の駆動を制御するための集積回路に本発明の一態様に係る半導体装置を用いることで、高機能の携帯電話、消費電力の低い携帯電話を提供することができる。

30

#### 【0594】

図17（C）は携帯情報端末であり、筐体7051、表示部7052、操作キー7053等を有する。図17（C）に示す携帯情報端末は、モデムが筐体7051に内蔵されていても良い。本発明の一態様に係る半導体装置は、携帯情報端末の駆動を制御するための集積回路に用いることができる。携帯情報端末の駆動を制御するための集積回路に本発明の一態様に係る半導体装置を用いることで、高機能の携帯情報端末、消費電力の低い携帯情報端末を提供することができる。

40

#### 【0595】

本実施例は、上記実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。

#### 【符号の説明】

#### 【0596】

100	基板
101	絶縁膜
102n	nチャネル型トランジスタ
102p	pチャネル型トランジスタ
103n	半導体膜
103p	半導体膜

50

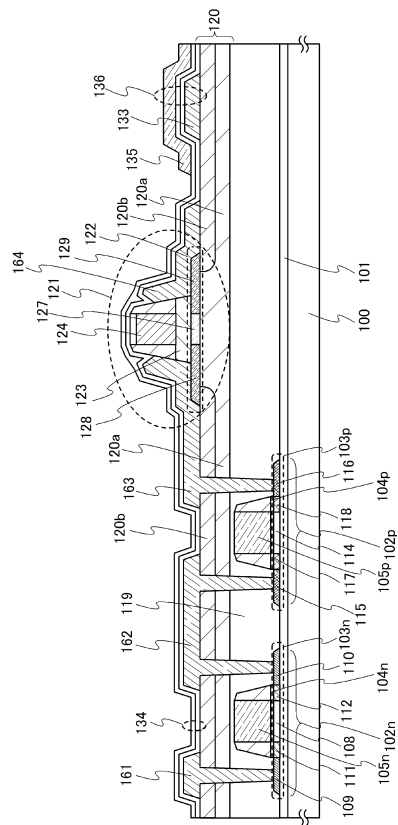
1 0 4 n	ゲート絶縁膜	
1 0 4 p	ゲート絶縁膜	
1 0 5 n	ゲート電極	
1 0 5 p	ゲート電極	
1 0 6	導電膜	
1 0 7	導電膜	
1 0 8	第 1 の領域	
1 0 9	第 2 の領域	
1 1 0	第 2 の領域	
1 1 1	第 3 の領域	10
1 1 1 a	低濃度不純物領域	
1 1 2	第 3 の領域	
1 1 2 a	低濃度不純物領域	
1 1 3	導電膜	
1 1 4	第 1 の領域	
1 1 5	第 2 の領域	
1 1 6	第 2 の領域	
1 1 7	第 3 の領域	
1 1 7 a	低濃度不純物領域	
1 1 8	第 3 の領域	20
1 1 8 a	低濃度不純物領域	
1 1 9	絶縁膜	
1 2 0	絶縁膜	
1 2 0 a	酸化絶縁膜	
1 2 0 b	酸化絶縁膜	
1 2 1	トランジスタ	
1 2 2	酸化物半導体膜	
1 2 3	ゲート絶縁膜	
1 2 3 a	絶縁膜	
1 2 4	ゲート電極	30
1 2 4 a	導電膜	
1 2 5	導電膜	
1 2 6	導電膜	
1 2 7	第 1 の領域	
1 2 8	第 2 の領域	
1 2 9	第 2 の領域	
1 3 0	サイドウォール	
1 3 1	絶縁膜	
1 3 1 a	絶縁膜	
1 3 2	端部	40
1 3 3	導電膜	
1 3 4	絶縁膜	
1 3 5	導電膜	
1 3 6	容量素子	
1 3 7	バックゲート電極	
1 3 8	導電膜	
1 4 0	絶縁膜	
1 4 0 a	酸化絶縁膜	
1 4 0 b	酸化絶縁膜	
1 4 0 c	酸化絶縁膜	50

1 4 1	開口部	
1 4 2	酸化物半導体膜	
1 4 2 b	酸化物半導体膜	
1 4 3	ゲート絶縁膜	
1 4 3 a	絶縁膜	
1 4 4	ゲート電極	
1 4 4 a	導電膜	
1 4 5	導電膜	
1 4 6	導電膜	
1 4 7	第 1 の領域	10
1 4 8	第 2 の領域	
1 4 9	第 2 の領域	
1 5 0	サイドウォール	
1 5 1	絶縁膜	
1 5 1 a	絶縁膜	
1 5 2	端部	
1 5 3	導電膜	
1 5 4	絶縁膜	
1 5 5	導電膜	
1 5 6	導電膜	20
1 5 7	バックゲート電極	
1 5 8	導電膜	
1 6 0	絶縁膜	
1 6 1	導電膜	
1 6 2	導電膜	
1 6 3	導電膜	
1 6 4	導電膜	
1 7 0 n	サイドウォール	
1 7 0 p	サイドウォール	
1 7 1	絶縁膜	30
1 7 3	絶縁膜	
1 7 4	絶縁膜	
1 7 5	絶縁膜	
1 8 0	絶縁膜	
1 8 1	絶縁膜	
1 8 6	導電膜	
1 8 7	絶縁膜	
1 8 8	導電膜	
1 9 0	第 3 の領域	
1 9 1	第 3 の領域	40
1 9 2	第 3 の領域	
1 9 3	第 3 の領域	
2 0 0	記憶回路	
2 0 1	位相反転素子	
2 0 2	位相反転素子	
2 0 3	トランジスタ	
2 0 4	トランジスタ	
2 0 5	容量素子	
2 0 6	スイッチング素子	
2 0 7	p チャネル型トランジスタ	50

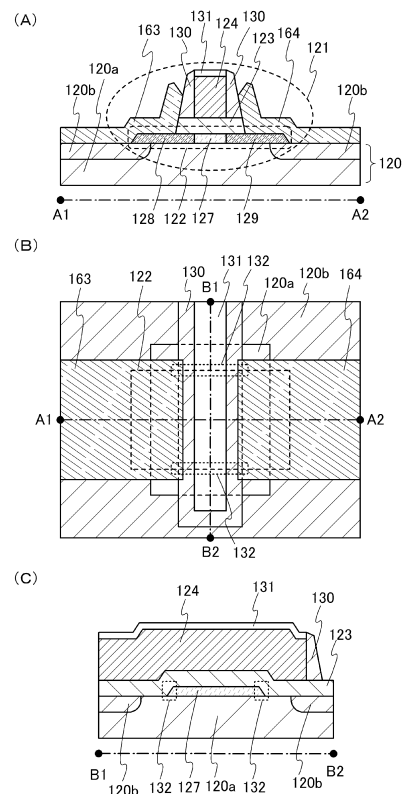
2 0 8	n チャンネル型トランジスタ	
2 0 9	p チャンネル型トランジスタ	
2 1 0	n チャンネル型トランジスタ	
2 1 1	記憶素子	
4 0 1	スイッチング素子	
4 0 2	記憶回路	
4 0 3	記憶回路群	
6 0 0	半導体装置	
6 0 1	制御装置	
6 0 2	A L U	10
6 0 3	データキャッシュ	
6 0 4	命令キャッシュ	
6 0 5	プログラムカウンタ	
6 0 6	命令レジスタ	
6 0 7	主記憶装置	
6 0 8	レジスタファイル	
1 1 0 1	下地絶縁層	
1 1 0 2	絶縁物	
1 1 0 3 a	半導体領域	
1 1 0 3 b	半導体領域	20
1 1 0 3 c	半導体領域	
1 1 0 4	ゲート絶縁膜	
1 1 0 5	ゲート電極	
1 1 0 6 a	側壁絶縁物	
1 1 0 6 b	側壁絶縁物	
1 1 0 7	絶縁物	
1 1 0 8 a	ソース電極	
1 1 0 8 b	ドレイン電極	
1 5 0 0	基板	
1 5 0 2	下地絶縁膜	30
1 5 0 4	保護絶縁膜	
1 5 0 6	酸化物半導体膜	
1 5 0 6 a	高抵抗領域	
1 5 0 6 b	低抵抗領域	
1 5 0 8	ゲート絶縁膜	
1 5 1 0	ゲート電極	
1 5 1 2	側壁絶縁膜	
1 5 1 4	電極	
1 5 1 6	層間絶縁膜	
1 5 1 8	配線	40
1 6 0 0	基板	
1 6 0 2	下地絶縁膜	
1 6 0 6	酸化物半導体膜	
1 6 0 8	ゲート絶縁膜	
1 6 1 0	ゲート電極	
1 6 1 4	電極	
1 6 1 6	層間絶縁膜	
1 6 1 8	配線	
1 6 2 0	保護膜	
7 0 3 1	筐体	50

7 0 3 2	筐体
7 0 3 3	表示部
7 0 3 4	表示部
7 0 3 5	マイクロホン
7 0 3 6	スピーカー
7 0 3 7	操作キー
7 0 3 8	スタイラス
7 0 4 1	筐体
7 0 4 2	表示部
7 0 4 3	音声入力部
7 0 4 4	音声出力部
7 0 4 5	操作キー
7 0 4 6	受光部
7 0 5 1	筐体
7 0 5 2	表示部
7 0 5 3	操作キー

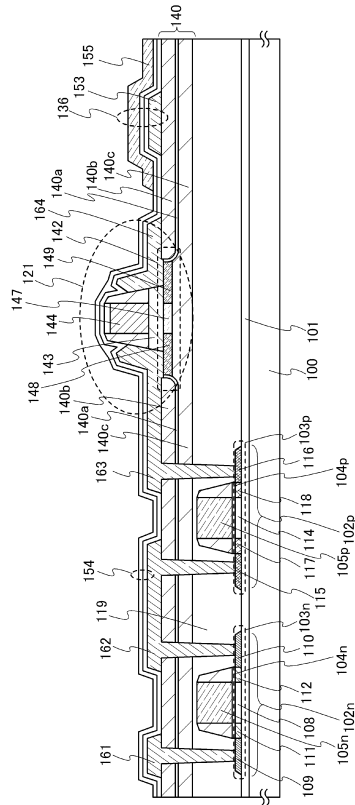
【図 1】



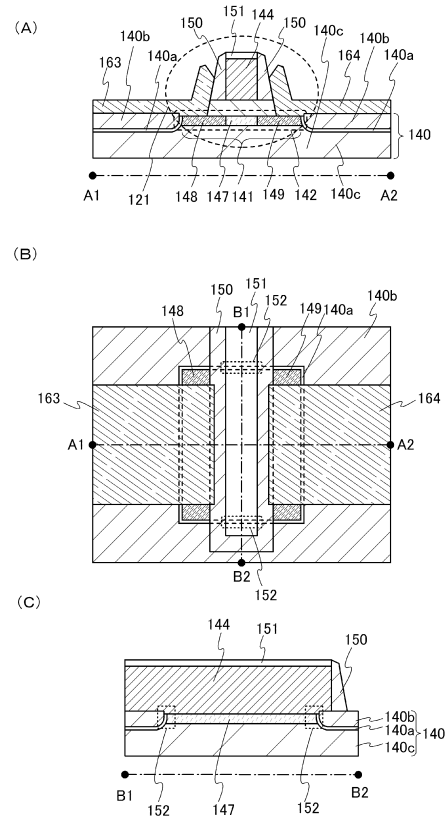
【図 2】



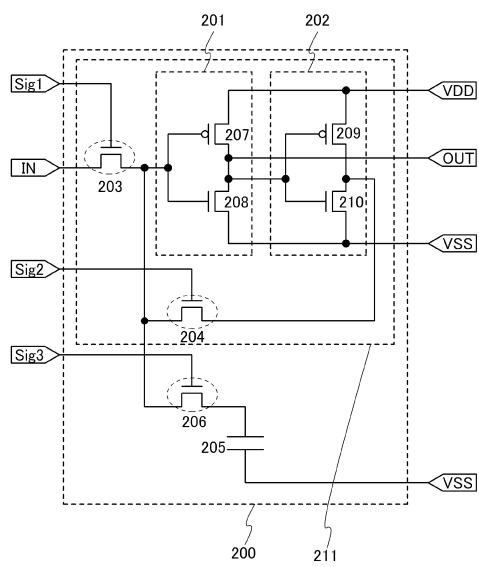
【図 3】



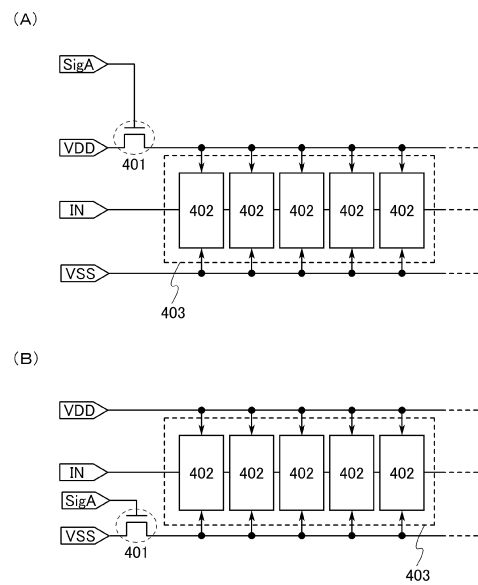
【図 4】



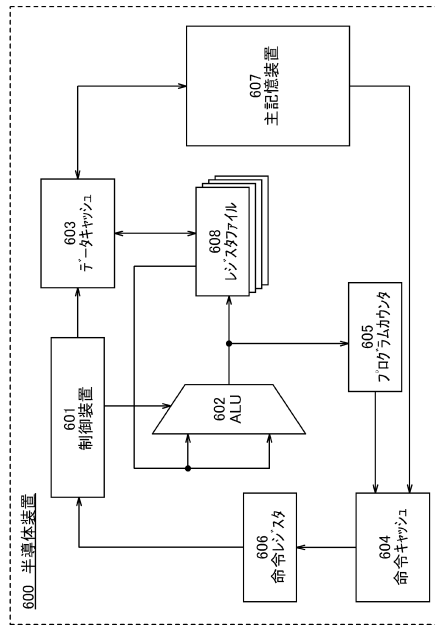
【図 5】



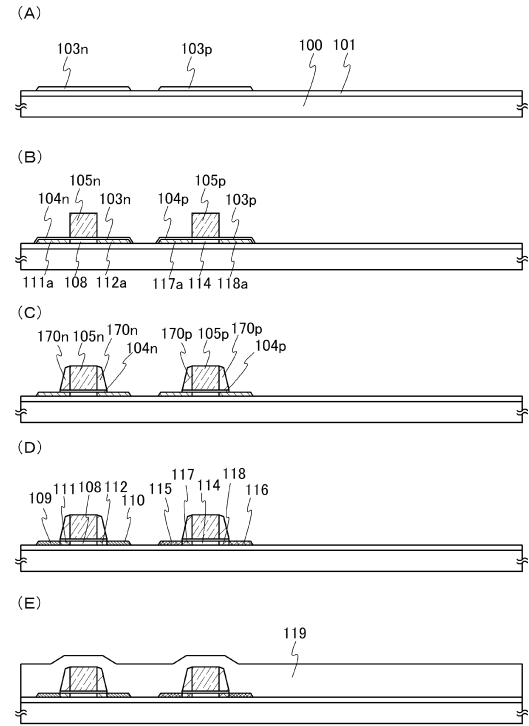
【図 6】



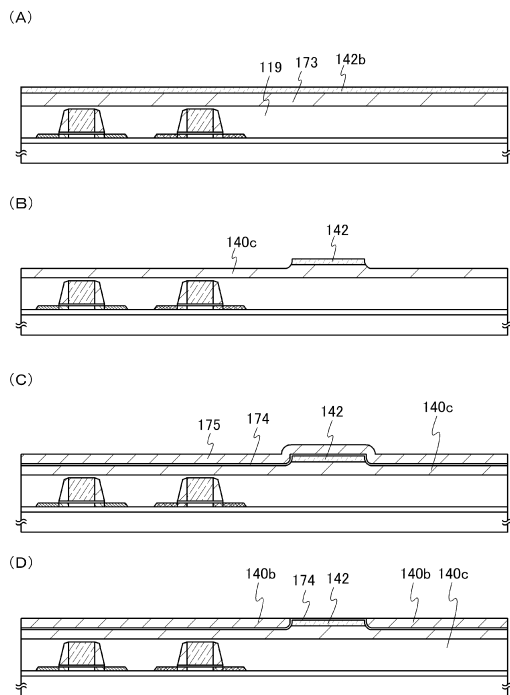
【図 7】



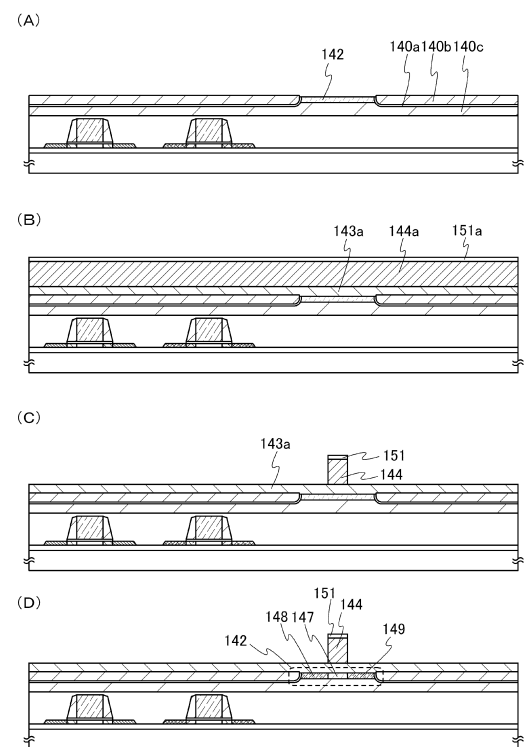
【図 8】



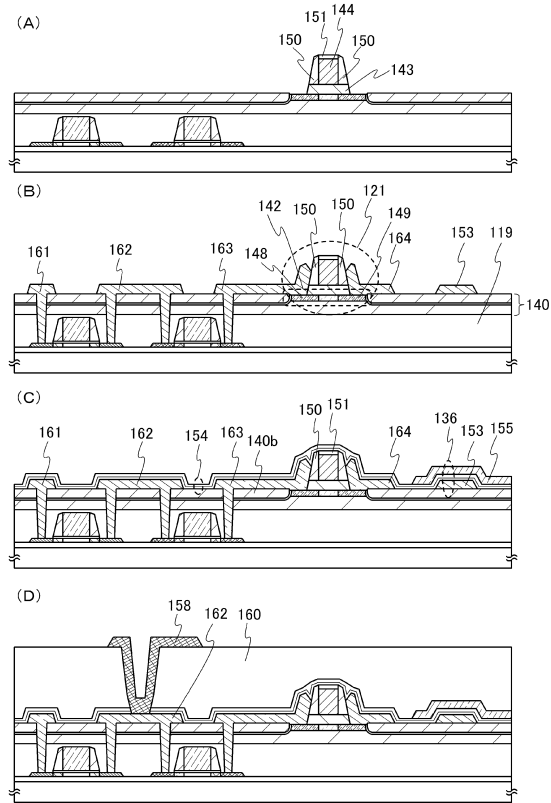
【図 9】



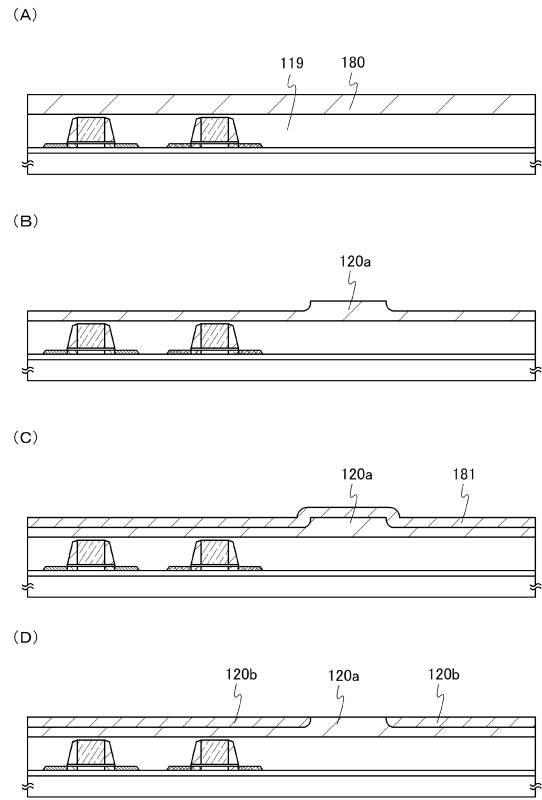
【図 10】



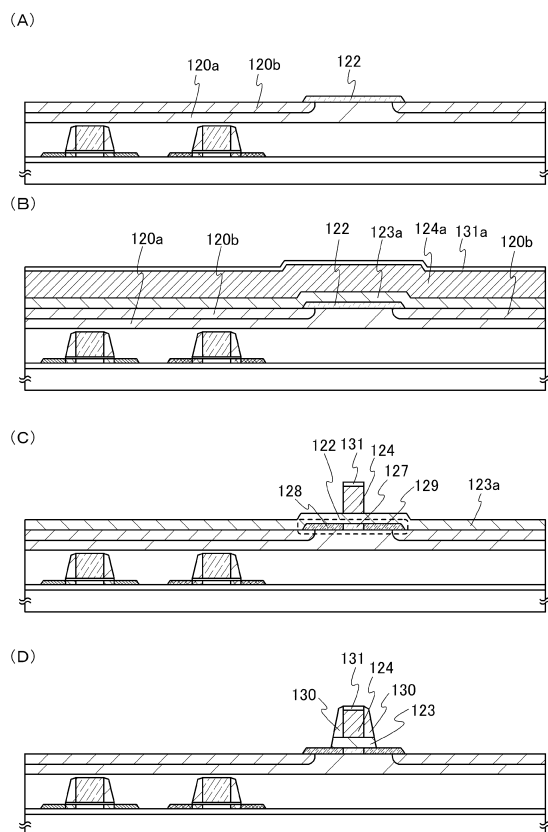
【図 1 1】



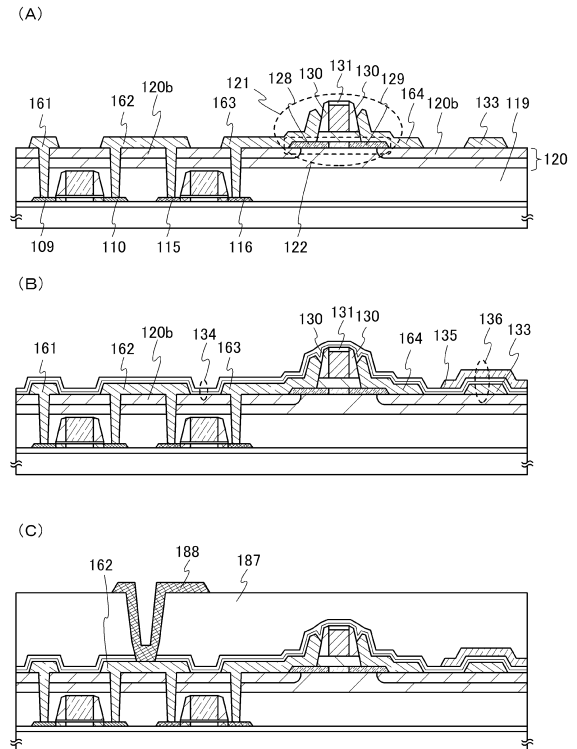
【図 1 2】



【図 1 3】

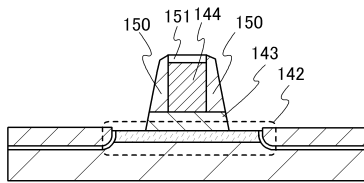


【図 1 4】

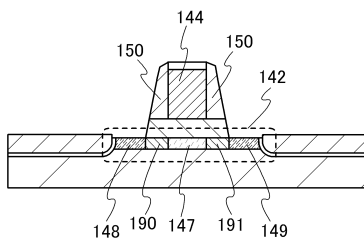


【図 15】

(A)

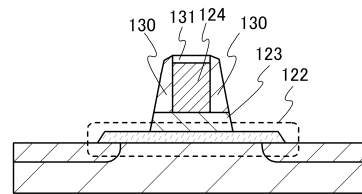


(B)

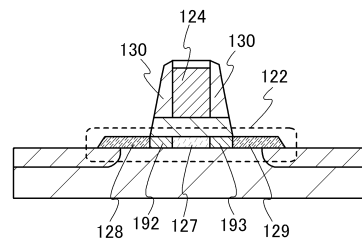


【図 16】

(A)

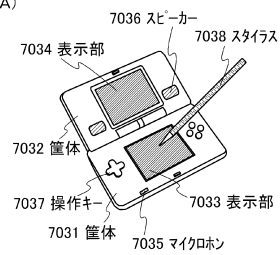


(B)

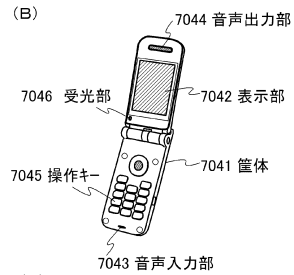


【図 17】

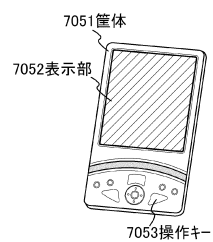
(A)



(B)

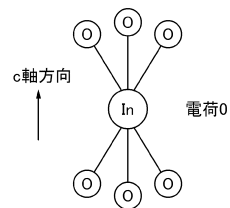


(C)

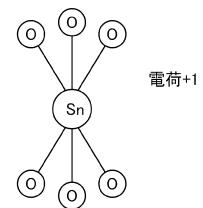


【図 18】

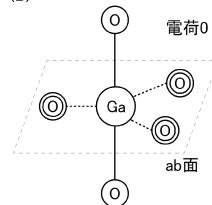
(A)



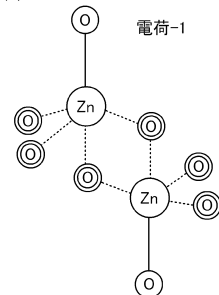
(D)



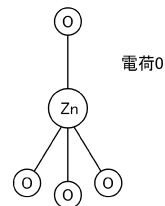
(B)



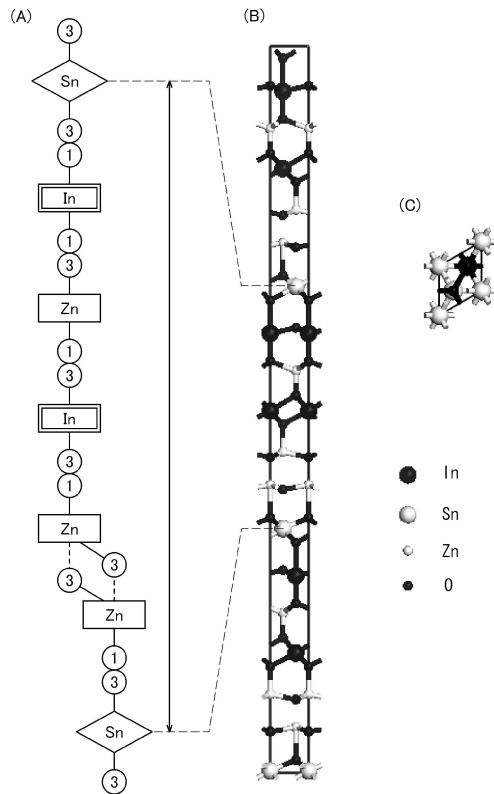
(E)



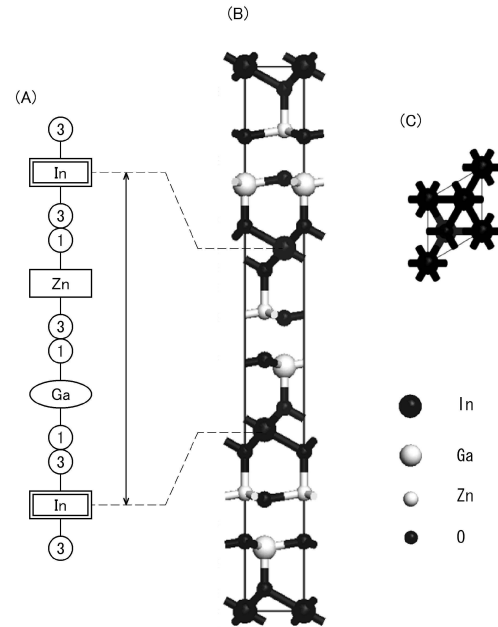
(C)



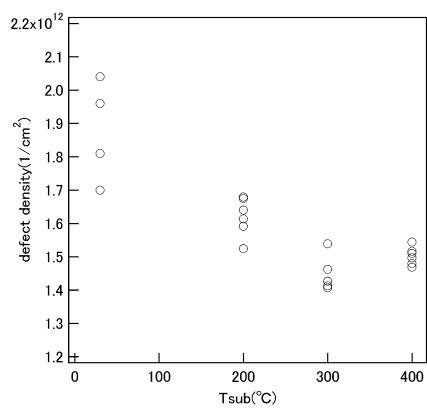
【図 19】



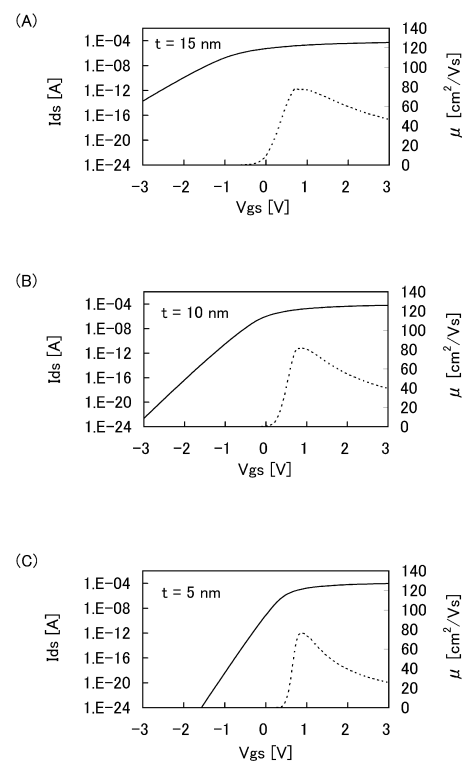
【図 20】



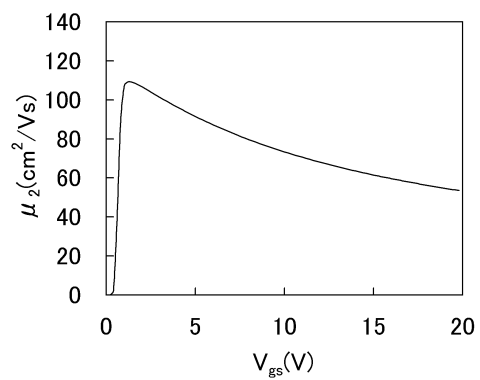
【図 21】



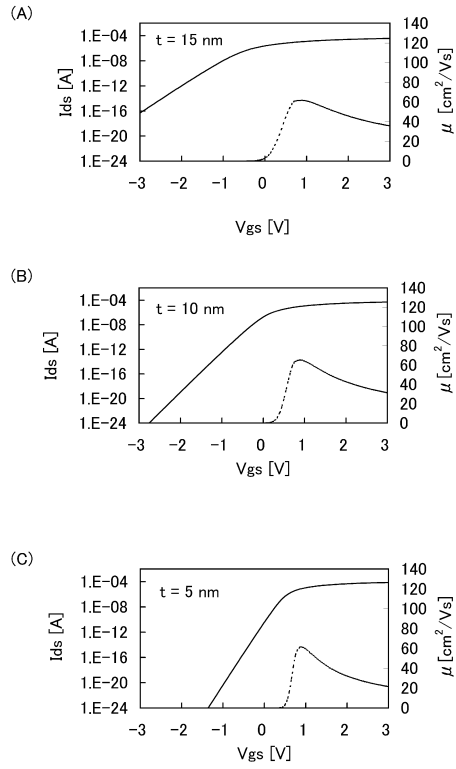
【図 23】



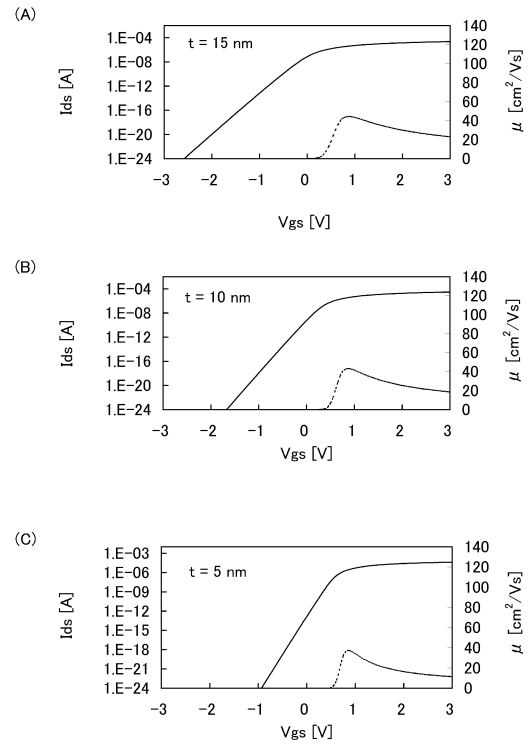
【図 22】



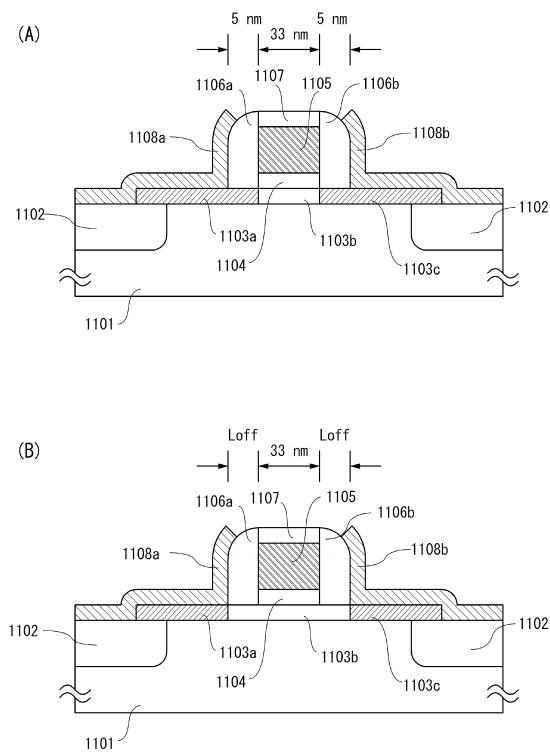
【図 2 4】



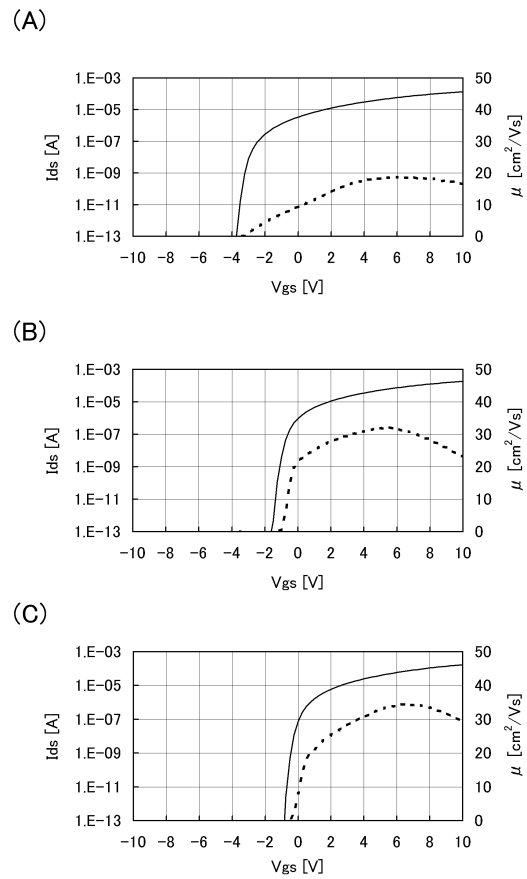
【図 2 5】



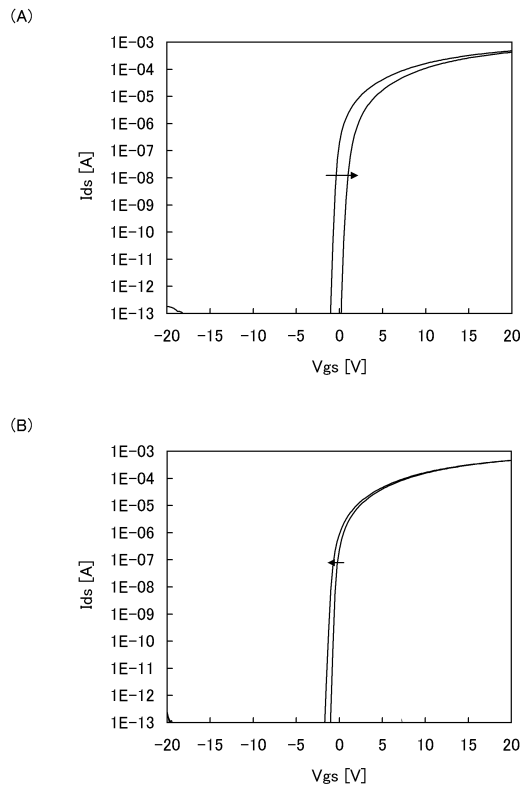
【図 2 6】



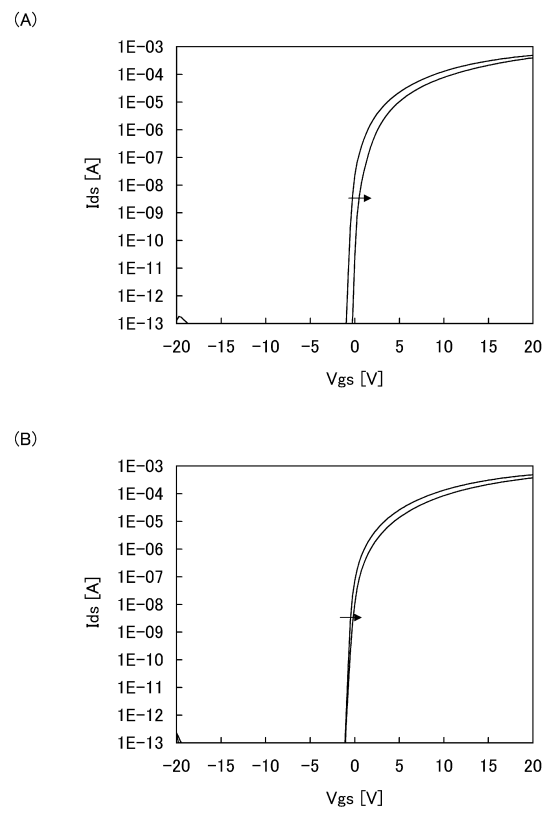
【図 2 7】



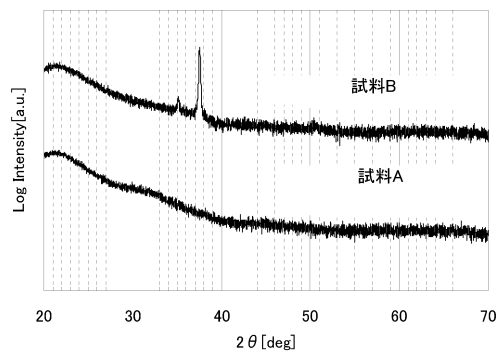
【図 28】



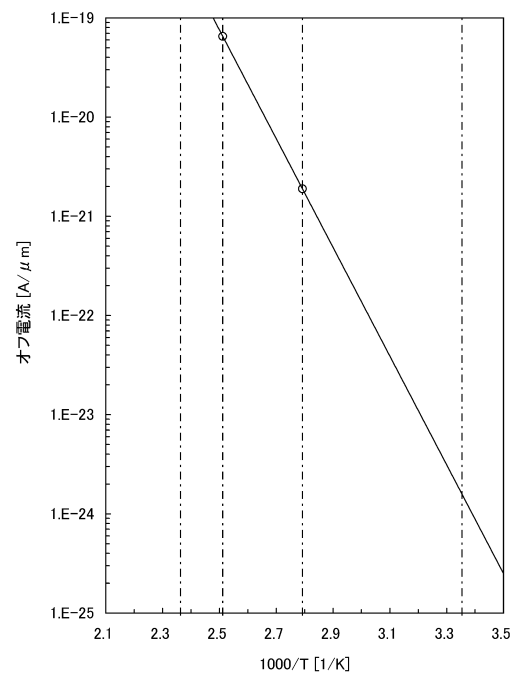
【図 29】



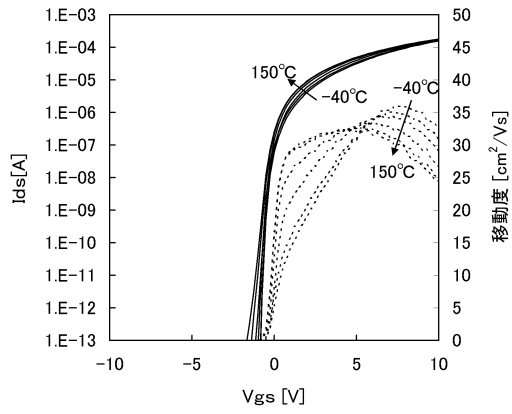
【図 30】



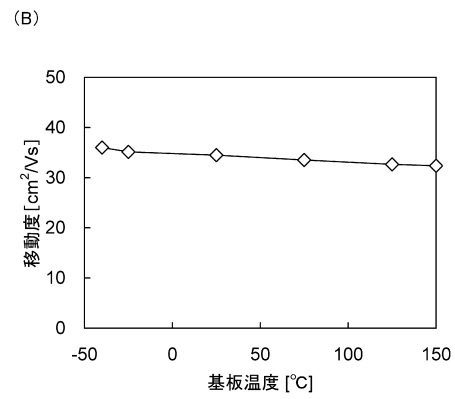
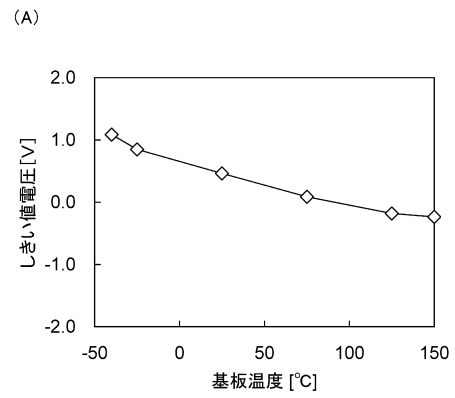
【図 31】



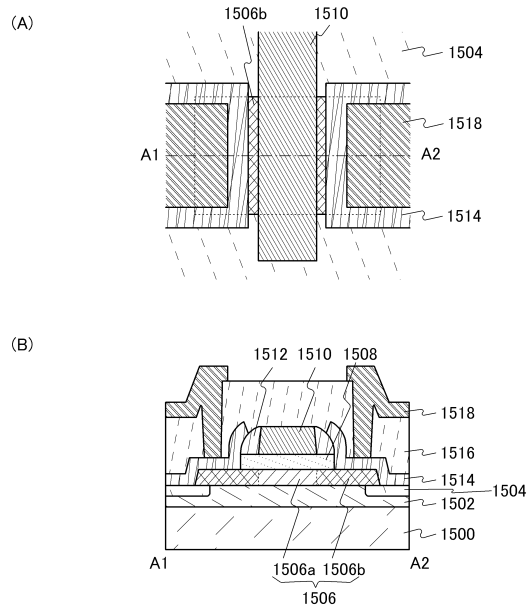
【図 3 2】



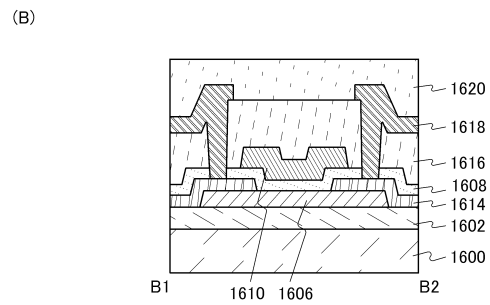
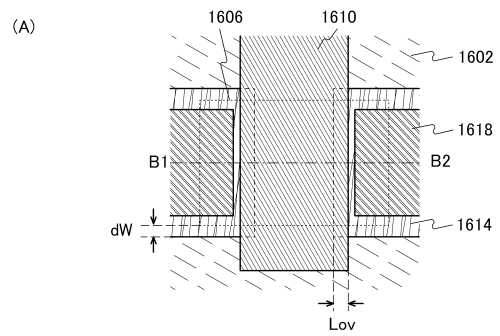
【図 3 3】



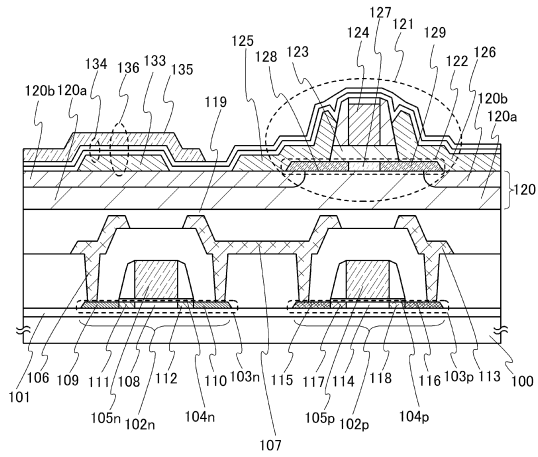
【図 3 4】



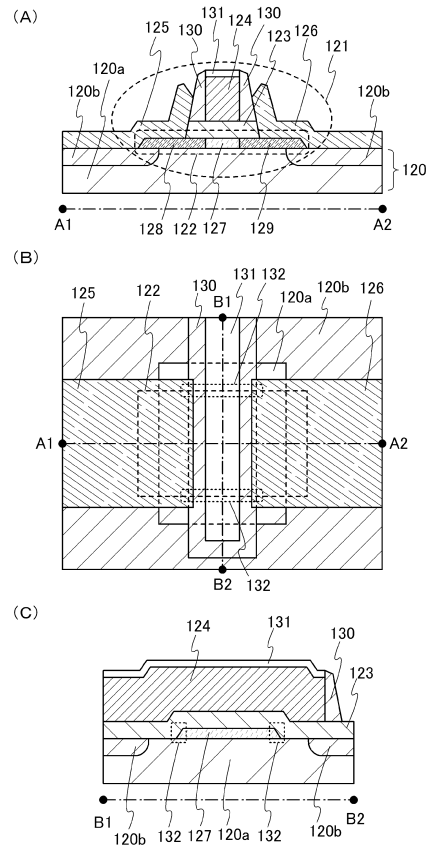
【図 3 5】



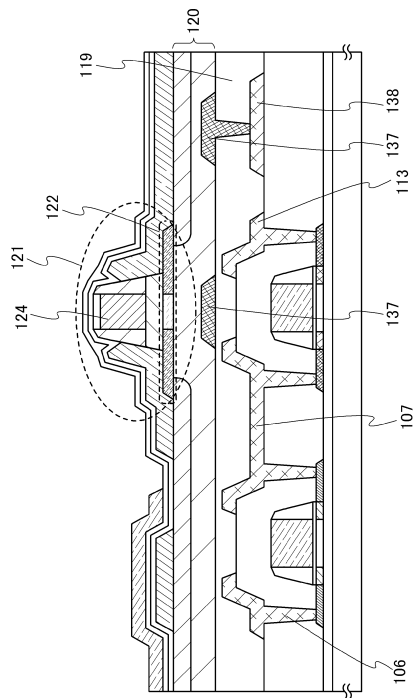
【図 36】



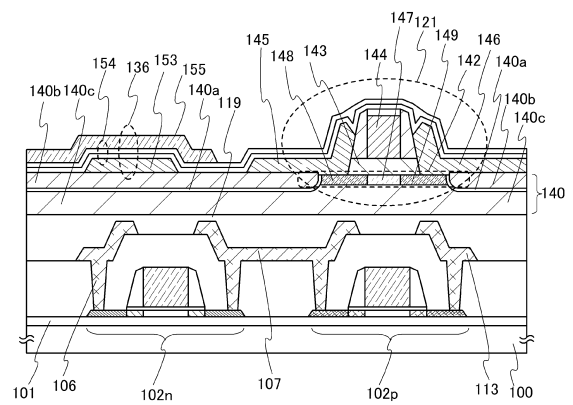
【図 37】



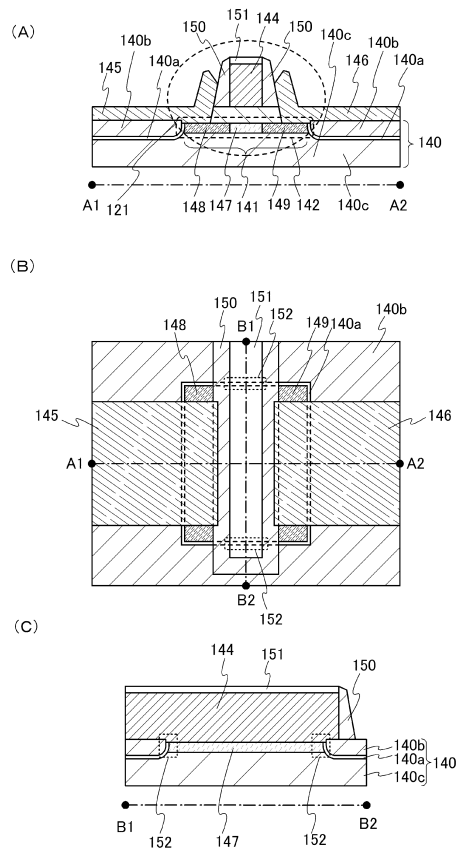
【図 38】



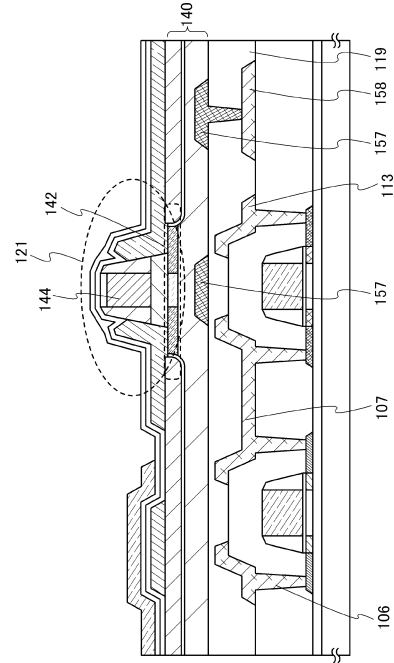
【図 39】



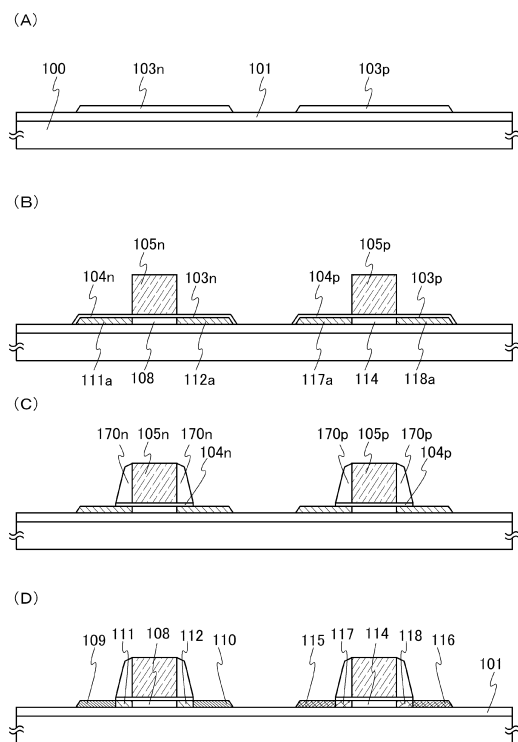
【図 40】



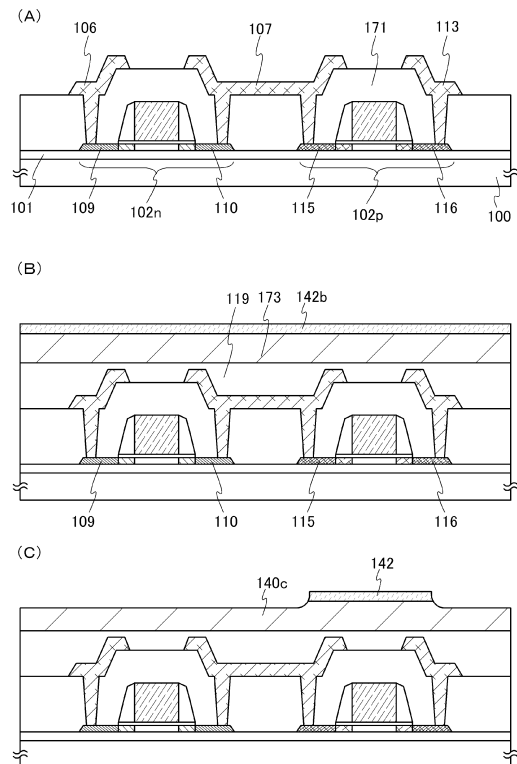
【図 41】



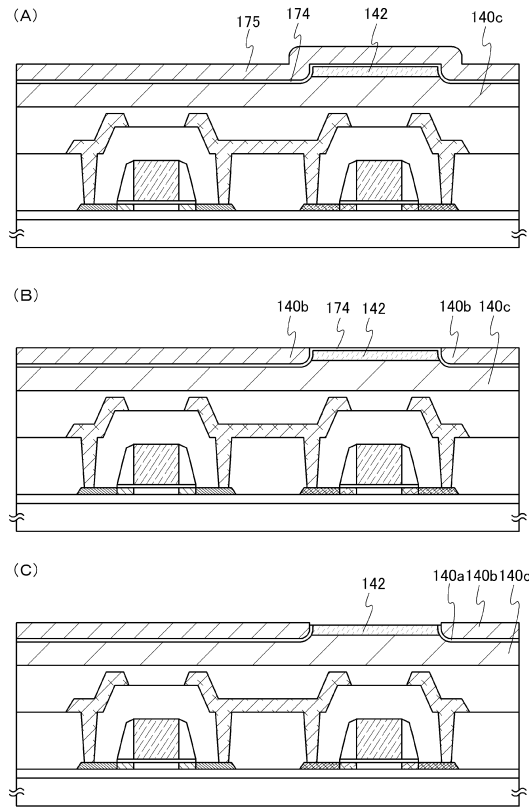
【図 42】



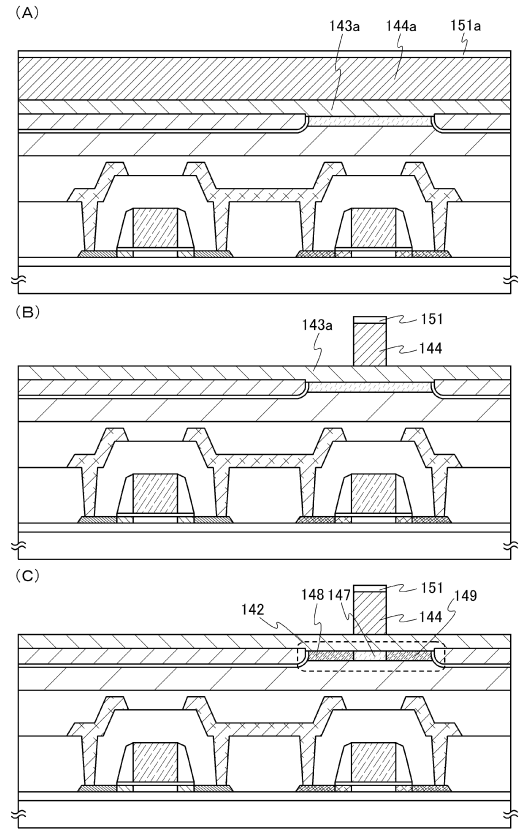
【図 43】



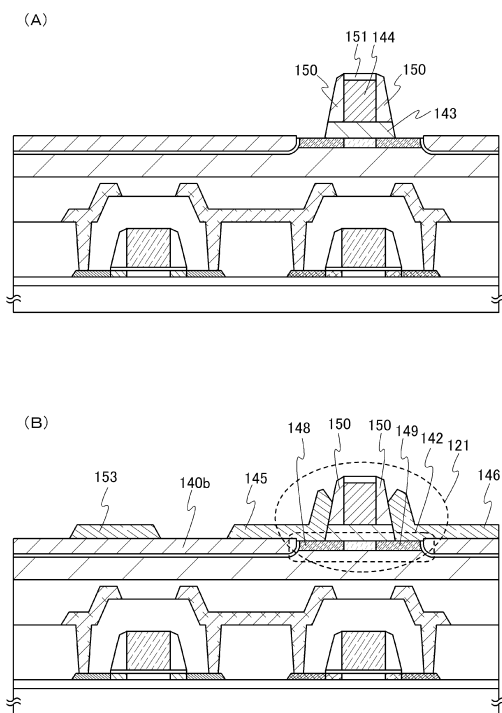
【図 4 4】



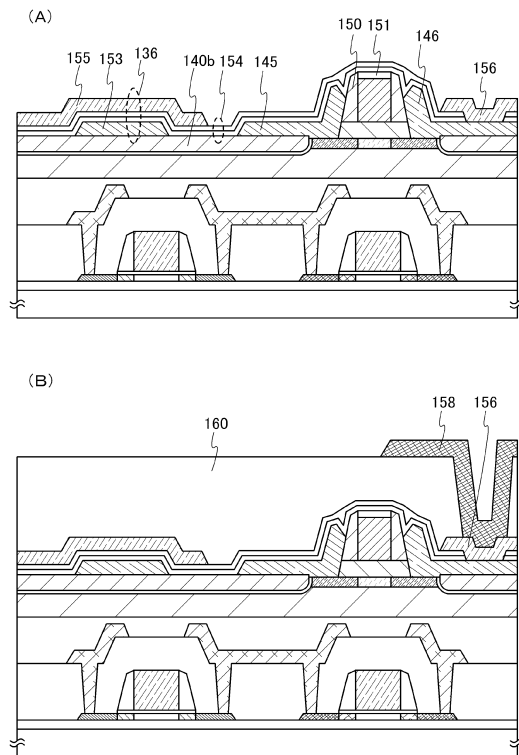
【図 4 5】



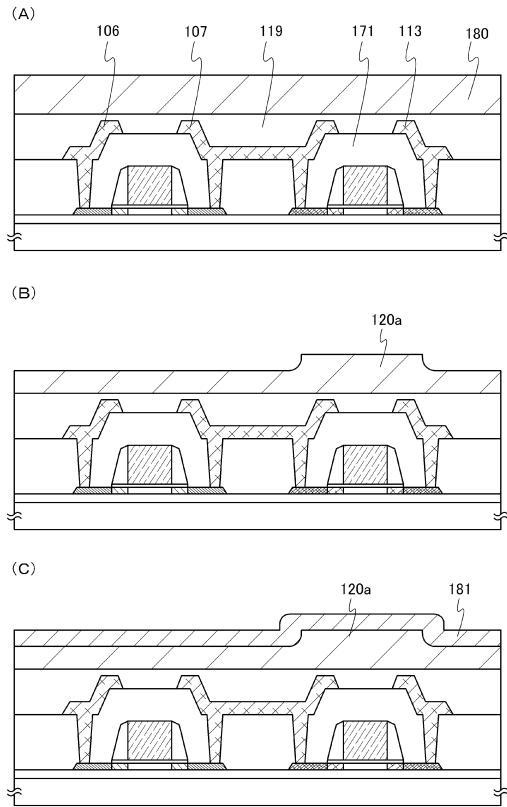
【図 4 6】



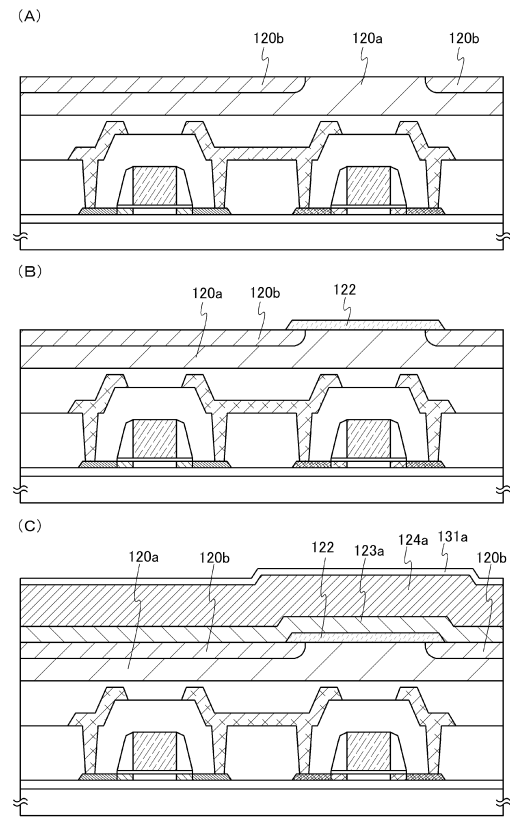
【図 4 7】



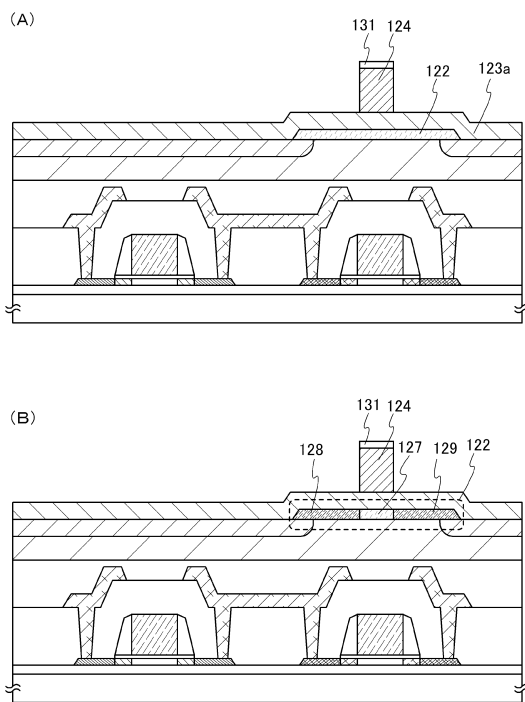
【図 48】



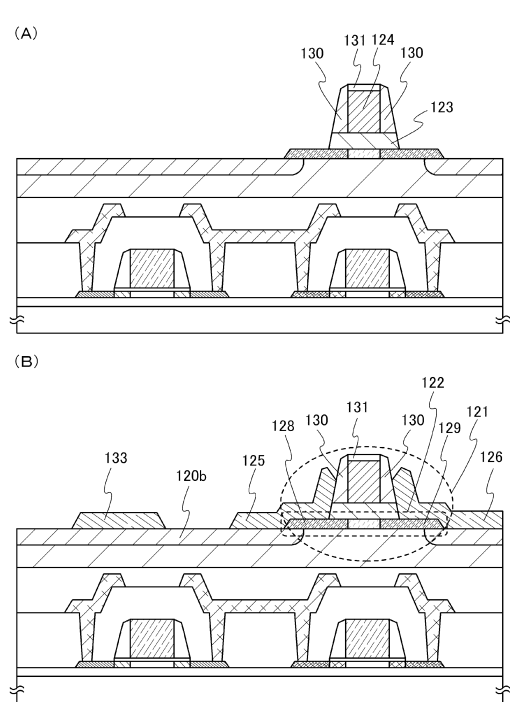
【図 49】



【図 50】



【図 51】





## フロントページの続き

(51) Int.Cl.			F I		
H 0 1 L	27/105	(2006.01)	H 0 1 L	29/78	6 1 8 C
H 0 1 L	27/10	(2006.01)	H 0 1 L	27/06	1 0 2 A
H 0 1 L	21/8234	(2006.01)	H 0 1 L	27/088	3 3 1 E
H 0 1 L	27/06	(2006.01)	H 0 1 L	27/088	E
H 0 1 L	27/088	(2006.01)	H 0 1 L	27/088	H
H 0 1 L	21/8238	(2006.01)	H 0 1 L	27/092	K
H 0 1 L	27/092	(2006.01)	H 0 1 L	27/088	C

(31)優先権主張番号 特願2011-113237(P2011-113237)

(32)優先日 平成23年5月20日(2011.5.20)

(33)優先権主張国 日本国(JP)

(31)優先権主張番号 特願2011-113238(P2011-113238)

(32)優先日 平成23年5月20日(2011.5.20)

(33)優先権主張国 日本国(JP)

審査官 岩本 勉

(56)参考文献 特開2011-049549(JP,A)  
 特開2010-073894(JP,A)  
 特開2005-033172(JP,A)  
 特開2007-318112(JP,A)  
 特開2010-205987(JP,A)  
 特開2010-272663(JP,A)  
 特開2008-277665(JP,A)  
 特開2012-227522(JP,A)  
 特開2012-169605(JP,A)  
 米国特許出願公開第2011/0037068(US,A1)  
 米国特許出願公開第2010/0065844(US,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H 0 1 L 2 9 / 7 8 6

H 0 1 L 2 1 / 3 3 6